Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» Институт естественных наук и математики Кафедра физической и неорганической химии

На правах рукописи

Матвеев Егор Станиславович

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЭВТЕКТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ НА ОСНОВЕ ИНДАТА БАРИЯ Ba₂In₂O₅

1.4.15. Химия твердого тела

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук

> Научный руководитель: доктор химических наук, доцент Анимица Ирина Евгеньевна

Екатеринбург – 2023

оглавление

Введение	. 5
Глава 1. Обзор литературы	13
1.1 Композиционные электролиты и композиционный эффект	13
1.1.1 Создание композиционных электролитов для оптимизации электрически	X
свойств ионных проводников	13
1.1.2 Классификация композиционных электролитов по типу систем	
«ионный проводник–изолятор»	14
1.2 Композиционные электролиты на основе ионных солей	15
1.2.1 Композиционные электролиты типа «ионная соль-простое вещество»	15
1.2.2 Композиционные электролиты типа «ионная соль-соль»	16
1.2.3 Композиционные электролиты типа «ионная соль-простой оксид»	17
1.2.4 Композиционные электролиты типа «ионная соль – сложный оксид»	25
1.3 Композиционные электролиты на основе простых оксидов	26
1.3.1 Композиционные электролиты типа «простой оксид – соль»	26
1.3.2 Композиционные электролиты типа «простой оксид – простой/сложный	
оксид»	28
1.4 Композиционные электролиты на основе сложных оксидов	29
1.4.1 Композиционные электролиты типа «сложный оксид–соль», «сложный	
оксид–простой оксид» и «сложный оксид–сложный оксид»	29
1.5 Композиционные электролиты на основе Ba ₂ In ₂ O ₅	32
1.5.1 Структурные особенности и электрические свойства Ва ₂ In ₂ O ₅	32
1.5.2 Создание композиционных электролитов на основе Ba ₂ In ₂ O ₅	36
Постановка задачи исследования	41
Глава 2. Экспериментальная часть	44
2.1 Синтез индивидуальных фаз	44
2.2 Приготовление композиционных образцов	47
2.3 Подготовка образцов для исследований	50
2.4 Исследования фазового состава	51
2.5 Исследование морфологии образцов	52

	50
2.6 Исследование плотности керамических образцов	52
2.7 Исследование термических свойств	54
2.8 Исследование локальной структуры и форм кислородно-водородных	групп
	54
2.9 Исследование электрических свойств	55
2.10 Измерение чисел переноса	60
Глава 3. Система Ba ₂ In ₂ O ₅ -Ba ₂ InNbO ₆	62
3.1 Фазовый состав	62
3.1.1 Рентгенофазовый анализ Ва ₂ In ₂ O ₅ и Ва ₂ InNbO ₆	62
3.1.2 Рентгенофазовый анализ образцов (1-x)Ва ₂ In ₂ O ₅ ·xBa ₂ InNbO ₆	63
3.2 Определение эвтектического состава	69
3.3 Морфология и микроструктура	70
3.3.1 Сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионный	
рентгеновский анализ Ba ₂ In ₂ O ₅ и Ba ₂ InNbO ₆	70
3.3.2 Сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионный	
рентгеновский анализ образцов (1-x)Ва ₂ In ₂ O ₅ ·xBa ₂ InNbO ₆	72
3.4 Термические свойства и масс-спектрометрия	77
3.5 Электрические свойства	82
3.5.1 Электрические свойства Ва ₂ InNbO ₆	82
3.5.2 Электрические свойства Ва ₂ In ₂ O ₅	88
3.5.3 Электрические свойства образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6$	90
3.6 Обсуждение природы композиционного эффекта	106
3.7 Перспективы практического применения	110
3.7.1 Химическая устойчивость	110
3.7.2 Испытания керамики в качестве чувствительного элемента пароводя	іного
сенсора резистивного типа	112
Глава 4. Система Ba ₂ In _{1.57} Al _{0.43} O ₅ -Ba ₂ InAlO ₅	113
4.1 Фазовый состав и микроструктура	113
4.1.1 Рентгенофазовый анализ	113

4.1.2 Сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионный	
рентгеновский анализ композиционных образцов	115
4.2 Термические свойства	120
4.3 Спектроскопические свойства	121
4.3 Электрические свойства	123
4.3.1 Электрические свойства Ba ₂ In _{1.57} Al _{0.43} O ₅ и Ba ₂ InAlO ₅	123
4.3.2 Электрические свойства композиционных образцов	127
Глава 5. Система Ba ₂ In ₂ O ₅ -Ba ₄ In ₆ O ₁₃	134
5.1 Фазовый состав и микроструктура	134
5.1.1 Рентгенофазовый анализ	134
5.1.2 Сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионный	
рентгеновский анализ	136
5.2 Термические свойства	140
5.3 Электрические свойства	142
5.3.1 Электрические свойства фазы Ва ₄ In ₆ O ₁₃	142
5.3.2 Электрические свойства композиционных образцов	151
Заключение	161
Выводы	170
Список сокращений и условных обозначений	173
Список литературных источников	176

введение

Актуальность темы исследования

Мировой тренд поддержания экосистемы планеты, акцентирующий внимание на рациональном использовании природных ресурсов и сокращении загрязнений экосферы, формирует тенденции сфере развития В энергоизвлечения и определяет задачи ученых-материаловедов. На протяжении последних 30-40 лет происходит разработка и внедрение альтернативных технологий получения энергии. К таким, в частности, относится водородная энергетика, где В качестве топлива используются водород ИЛИ водородсодержащие газы [1]. Источником электрического тока может служить твердооксидный топливный элемент (ТОТЭ) с протонной или кислородноионной мембраной. электролитической Внимание исследователей сфокусировано на поиске электролитического материала с оптимальными для работы характеристиками: высокой ионной (кислородно-ионной или протонной) проводимостью, высокой химической И термической устойчивостью, механической прочностью, сниженной рабочей температурой. Кроме этого, электролитические материалы с кислородно-ионной и протонной типами проводимости могут быть использованы в качестве функциональных материалов других электрохимических устройств – электролизеры, сенсорные элементы.

Для создания электролитов со средне- или высокотемпературным режимами работы используются сложные оксиды с перовскитной или подобной структурой. Некомплектность по кислородной подрешетке определяет возможность диссоциативного внедрения молекул воды в структуру оксида и образования протонных дефектов, соответственно, протонной проводимости. В литературе описан индат бария $Ba_2In_2O_5$ [2–23] со структурой браунмиллерита, электропроводность Ba₂In₂O₅ определяется кислородно-ионным переносом в сухой атмосфере и протонным – во влажной или водородсодержащей атмосферах. Наличие структурного перехода «порядок-беспорядок», сопровождающего повышение симметрии с ромбической на тетрагональную, обеспечивает высокую ионную проводимость Ba₂In₂O₅ при температурах

>925 °C. Интерес представляет стабилизация высокопроводящей модификации $Ba_2In_2O_5$ к более низким температурам. Широко описанный спектр физикохимических свойств и подходов к оптимизации электропроводности $Ba_2In_2O_5$ определяет его в качестве удобного модельного объекта для исследования влияния различных методов допирования на протонный транспорт.

настоящее время оптимизация электрических свойств Ba₂In₂O₅ В достигается с помощью использования двух принципиально различных подходов. Наиболее изученным является метод гомогенного допирования с изои/или гетеровалентным замещением по катионной [19–20] или анионной [21] подрешетке, при котором формируются твердые растворы. Другой подход – метод гетерогенного допирования, при его использовании увеличение 100 - 1000электропроводности электролитов достигает раз [25], ЧТО обуславливает перспективность применения соответственно, его И, практическую значимость. Использование метода гетерогенного допирования подразумевает формирование композиционных материалов на основе электролитических материалов. При этом класс композиционных электролитов «сложный оксид-сложный оксид» представлен ограниченным количеством источников [24]. Фундаментальный интерес обуславливает литературных расширение систематических исследований комплекса физико-химических свойств сложнооксидных композиционных систем. Данная работа посвящена изучению влияния метода гетерогенного допирования на электрические свойства индата бария Ba₂In₂O₅ и твердых растворов на его основе с различными гетерогенными допантами.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Программы развития Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина в соответствии с программой стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

Степень разработанности темы

Количество работ свойств по систематическому изучению композиционных систем «сложный оксид-сложный оксид» ограничено. Например, в работе [24] изучены композиционные электролиты на основе индата бария Ba₂In₂O₅ в квазибинарной эвтектической системе, дано объяснение природы возникновения композиционного эффекта проводимости. В работе [25] по электропроводности получены первичные данные композиционных эвтектических электролитов с добавкой Ba₂InNbO₆, при этом эффект увеличения их электрической проводимости не раскрывается. Настоящая работа посвящена исследованию свойств композиционных систем на основе Ba₂In₂O₅ и направлена на комплексное изучение эффективности метода гетерогенного допирования на транспортные свойства индата бария Ba₂In₂O₅ и твердых растворов на его основе с различными гетерогенными допантами.

Цель работы

Установить закономерности влияния гетерогенного допанта на электрические свойства индата бария Ba₂In₂O₅ и твердых растворов на его основе, а также анализ композиционного эффекта в эвтектических композитах.

В рамках сформулированной цели были поставлены следующие задачи:

– синтез индивидуальных соединений $Ba_2In_2O_5$, Ba_2InNbO_6 , Ba_2InAlO_5 , $Ba_4In_6O_{13}$; получение композиционных образцов в системах $Ba_2In_2O_5$ – Ba_2InNbO_6 , $Ba_2In_2O_5$ – Ba_2InAlO_5 и $Ba_2In_2O_5$ – $Ba_4In_6O_{13}$ методом *in situ* и/или методом смешения;

 аттестация фазового состава образцов и их микроструктуры; оценка плотностных характеристик керамических образцов;

 изучение термических свойств образцов, определение фактической степени гидратации;

– исследование общей электропроводности для образцов в зависимости от температуры, парциального давления паров воды и кислорода;

определение ионных чисел переноса, дифференциация проводимости на парциальные вклады;

 установление причин влияния метода гетерогенного допирования на электрические свойства композиционных электролитов; расчет электропроводности композиционных электролитов в системе Ba₂In₂O₅– Ba₂InNbO₆ с помощью математических моделей.

Научная новизна

Впервые изучены электрические свойства индивидуальных фаз Ba₂InNbO₆, Ba₂InAlO₅, Ba₄In₆O₁₃ и установлена природа доминирующего типа проводимости, произведена дифференциация общей проводимости на парциальные вклады.

Для систем Ba₂In₂O₅–Ba₂InNbO₆, Ba₂In₂O₅–Ba₂InAlO₅ впервые установлена температура эвтектики и построен фрагмент диаграммы состояния.

Изучены электрические свойства образцов композиционных $(1-x)Ba_2In_2O_5 \cdot xBa_2InNbO_6$, $(1-z)Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot zBa_2InAlO_5$ И $(1-z)Ba_2In_2O_5 zBa_4In_6O_{13}$ в зависимости от парциального давления паров воды и/или кислорода. Установлена природа доминирующей проводимости композиционных образцов, определены ионные числа переноса, произведена дифференциация общей проводимости.

Обнаружен композиционный эффект проводимости. Выявлены закономерности влияния природы гетерогенного допанта и его дисперсности, метода приготовления композита на величину композиционного эффекта.

Для композиционных образцов в системе Ba₂In₂O₅–Ba₂InNbO₆ выполнен расчет электропроводности для описания композиционного эффекта в рамках различных моделей.

Теоретическая и практическая значимость работы

Полученные в работе данные по электрическим свойствам сложных оксидов носят справочный характер.

Данные по электрическим свойствам композиционных образцов носят как фундаментальный, так и прикладной характер. Установлено влияние природы и дисперсности гетерогенного допанта на величину композиционного эффекта, показано влияние условий приготовления композиционных образцов на величину композиционного эффекта.

Показано, что керамика на основе композиционной системы Ba₂In₂O₅– Ba₂InNbO₆ является перспективным материалом для чувствительного элемента пароводяного датчика резистивного типа.

Установленные закономерности могут быть использованы при прогнозировании электрических свойств композиционных электролитов в других композиционных эвтектических системах типа «сложный оксид– сложный оксид».

Развитый подход к формированию микроструктуры композиционных эвтектических электролитических материалов, приводящий к увеличению ионной проводимости, может представлять интерес для развития методов достижения требуемых свойств для эксплуатации электролитических мембранных материалов.

Методология и методы исследования

Синтез индивидуальных соединений проводили твердофазным или растворным методами. Приготовление композиционных образцов проводили in situ, при одновременном твердофазном синтезе методом исходных компонентов, или методом смешения. Фазовую аттестацию образцов проводили методом рентгенофазового анализа, уточнение параметров элементарных ячеек проводили методом полнопрофильного анализа Ритвельда по бесструктурной модели Ле Бейла с помощью программного обеспечения FullProf. Для определения локальной структуры и форм кислородно-водородных групп использовали методы спектроскопии комбинационного рассеивания и метода инфракрасной спектроскопии, соответственно. Аттестацию микроструктуры и морфологии порошков или керамических образцов проводили методом сканирующей электронной микроскопии, элементный состав образцов

энергодисперсионного определяли методом рентгеновского анализа. Определение возможности диссоциативного внедрения молекул воды анализа. Плотностные проводили методом термогравиметрического образцов были характеристики керамических изучены методом гидростатического взвешивания. Электрические свойства изучены методом электрохимического импеданса при варьировании температуры и при различном парциальном давлении кислорода, паров воды, в атмосфере влажного углекислого газа. Ионные числа переноса для образцов определены методом ЭДС.

Положения, выносимые на защиту

данные рентгенофазового анализа о влиянии гетерогенного допирования на структурные свойства Ba₂In₂O₅ в квазибинарных эвтектических системах Ba₂In₂O₅–Ba₂InNbO₆, Ba₂In₂O₅–Ba₂InAlO₅ и Ba₂In₂O₅–Ba₄In₆O₁₃;

сканирующей электронной микроскопии о влиянии данные гетерогенного допирования на морфологию Ba₂In₂O₅ и микроструктуру композиционных образцов различной температурой обработки с В квазибинарных эвтектических системах Ba₂In₂O₅–Ba₂InNbO₆, $Ba_2In_2O_5 Ba_2InAlO_5$ и $Ba_2In_2O_5$ – $Ba_4In_6O_{13}$;

данные термогравиметрического анализа образцов (1-x)Ва₂In₂O₅·xBa₂InNbO₆ (x=0.00−1.00), (1-z)Ва₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·zBa₂InAlO₅ (z=0.00−1.00) и (1-z)Ва₂In₂O₅·zBa₄In₆O₁₃ (z=0.00−1.00);

– результаты импедансной спектроскопии для образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6$ (x=0.00–1.00), $(1-z)Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 zBa_2InAlO_5$ (z=0.00–1.00) и (1–z)Ba_2In_2O_5 zBa_4In_6O_{13} (z=0.00–1.00) в интервале температур 200 – 900 °C, парциального давления кислороды 10⁻¹⁶–0.21 атм, парциального давления паров воды $3 \cdot 10^{-5}$ –0.02 атм; результаты определения ионных чисел переноса методом ЭДС в градиенте парциального давления кислорода и/или паров воды;

 Обсуждение природы композиционного эффекта проводимости в системах Ba₂In₂O₅-Ba₂InNbO₆, Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅-Ba₂InAlO₅ и Ba₂In₂O₅-Ba₄In₆O₁₃.

Степень достоверности и апробация результатов работы

Достоверность результатов работы определялась комплексным подходом к выбору методов исследования; всесторонним анализом полученных теоретических и экспериментальных результатов; апробацией работы на международных и российских конференциях, публикациями в рецензируемых журналах. Основные результаты работы представлены на следующих конференциях: Российских молодежных научных конференциях «Проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2016–2022); Международном Совещании «Фундаментальные проблемы ионики твердого тела» (г. Черноголовка, 2016, 2018, 2020); Менделеевском съезде по общей и химии (Екатеринбург, 2016); Международном симпозиуме прикладной "Порядок, беспорядок и свойства оксидов" (Сочи, 2016, 2017); Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2017); Всероссийской конференции "Керамика и композиционные материалы" (Сыктывкар, 2016, 2021); Всероссийской международной научнопрактической конференции с международным участием «Экологобезопасные и ресурсосберегающие технологии И материалы» (Улан-Удэ, 2017); Международной молодежной научной конференции «Физика. Технологии. Инновации.» (Екатеринбург, 2018, 2021); Всероссийской научной конференции с международным участием «Байкальский материаловедческий форум» (Улан-Удэ, 2018, 2022); Всероссийской молодежной научной конференции с элементами научной школы – «Функциональные материалы: синтез, свойства, применение» (Санкт-Петербург, 2018); Всероссийской конференции с международным участием «Горячие точки химии твердого тела: от новых идей (Новосибирск, 2019); материалам» Международной научной к новым конференции «Полифункциональные химические материалы и технологии» (Томск, 2019); Всероссийской конференции с международным участием «Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах» (Воронеж, 2021).

Личный вклад автора

Все результаты, приведенные в диссертации, получены самим автором или при его непосредственном участии. Обсуждение полученных результатов и написание статей проводилось совместно с научным руководителем и соавторами работ.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, в том числе 3 статьи опубликованы в рецензируемых научных журналах, индексируемых в базах Scopus и Web of Science, и 13 тезисов докладов на конференциях международного и российского уровня.

Структура диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, заключения, основных выводов и списка литературы, содержащего 127 библиографических ссылок. Текст работы изложен на 188 страницах, включает в себя 133 рисунка и 8 таблиц.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Композиционные электролиты и композиционный эффект

В данной главе приводится обзор литературных источников по теме композиционных электролитов. Создание композитов (метод гетерогенного допирования) рассматривается как способ оптимизации электрических свойств ионных проводников, подчеркивается перспективность данного метода. Показаны основные тенденции изменения электропроводности композитов. Рассмотрено теоретическое обоснование возникновения композиционного эффекта (КЭ) проводимости.

1.1.1 Создание композиционных электролитов для оптимизации электрических свойств ионных проводников

Первая работа по изучению электрических свойств композиционных электролитов была опубликована Лиангом в 1973 году [26]. Установлено, что при приготовлении композиционных электролитов в системе на основе LiI с добавкой изолятора γ -Al₂O₃ происходит существенное увеличение Ha электропроводности. рисунке 1.1 приведены температурные (см. рисунок 1.1а) и концентрационные (см. рисунок 1.1б) зависимости общей электропроводности. Максимальное увеличение электропроводности наблюдается при 25 °C и достигает четырех порядков величины по сравнению со значениями для исходных иодида лития и γ-Al₂O₃.



Рисунок 1.1 – Температурная (а) и концентрационная (б) зависимости проводимости для композиционных образцов в (1–*x*)LiI·*x*(γ-Al₂O₃) [26]

В дальнейшем композиционные электролиты на основе аналогичных систем «ионная соль-изолятор» были широко изучены (см. раздел 1.2). В наблюдался большинстве систем эффект значительного увеличения электропроводности ионного типа, который впоследствии назвали эффектом (КЭ). Подход композиционным создания композиционных электролитов называется методом гетерогенного допирования.

1.1.2 Классификация композиционных электролитов по типу систем «ионный проводник-изолятор»

Ha основании литературных источников, опубликованных В продолжительном временном интервале [25–87], композиционные электролиты можно классифицировать по типу компонентов, которые используются в системах «матрица-добавка». При этом стоит отметить, что определяющей характеристикой матричной фазы является наличие ионной проводимости со средними или высокими значениями. Свойства добавки, наоборот, должны ограничиваться низкими значениями проводимости, добавка выступает в качестве изолятора. Таким образом, классифицировать композиционные электролиты можно по типу системы «ионный проводник-изолятор», где ионный проводник (соль, простой или сложный оксид) является матричной фазой, а изолятор выступает в качестве непроводящей добавки (по сравнению со значениями ионной проводимости для матричной фазы).

В литературе встречаются работы с описанием композиционных электролитов на основе систем, где в качестве матрицы используются ионные соли [26–52]. В качестве непроводящей добавки могут выступать простые вещества [27, 28], соли [29–32], простые и сложные оксиды [33–52]. Данный класс композиционных электролитов является наиболее изученным. Авторами указанных работ установлены факторы, влияющие на величину КЭ. Отмечено влияние ряда факторов на наблюдаемый КЭ: дисперсность компонентов в системах «ионная соль–добавка», природа матричной фазы и гетерогенной добавки, режимы предварительной обработки и т.д. [34–36]. На основе

экспериментальных данных для композитов типа «ионная соль–простой оксид» представлены модели описания композиционного эффекта [33, 38–50].

В последние 10–15 лет развивается изучение двух классов композиционных электролитов на основе простых [53–59] и сложных оксидов. К сожалению, исследования композиционных электролитов на основе оксидных или сложнооксидных систем затруднены подбором подходящей гетерогенной добавки. Высокие значения ионной проводимости для матричной фазы достигаются лишь в средне- или высокотемпературных интервалах, что может приводить к нарушению условия химической инертности между компонентами композиционного электролита [60–70]. Авторами работ [24, 70] отмечена перспективность использования метода гетерогенного допирования на основе оксидных систем эвтектического типа. Основные тенденции возникновения композиционного эффекта в композиционных системах на основе оксидных и сложнооксидных матричных фаз совпадают с системами типа «ионная соль–простой оксид», однако из-за специфики подобных систем в литературе зачастую выдвигаются только косвенные предположения о природе композиционного эффекта.

1.2 Композиционные электролиты на основе ионных солей

1.2.1 Композиционные электролиты типа «ионная соль-простое вещество»

В работах [27, 28] изучены композиционные системы на основе AgI [27] и LiClO₄ [28] с гетерогенной добавкой алмазов в нанодисперсном состоянии (С_{НЛ}). В обоих случаях авторы отмечают отсутствие химического взаимодействия между основной фазой и алмазами. Введение в качестве добавки алмазов в нанодисперсном состоянии приводит к появлению композиционного эффекта. Эффект увеличения общей электропроводности достигает трех порядков величины. На рисунке 1.2 представлена концентрационная зависимость для образцов (1-x)AgCl·xC_{HЛ} [27]. Максимум проводимости наблюдается для 0.2AgCl·0.8C_{HЛ}. В работе [28] образца температурные зависимости электропроводности не представлены, для образца 0.3LiClO₄·0.7C_{HD} значение электропроводности составляет 10⁻⁴ Ом⁻¹см⁻¹. Авторы этих работ предполагают,

что введение наноалмазов в матрицу AgI приводит к стабилизации модификаций β -AgI, γ -AgI [27], локализующейся в межзеренном пространстве индивидуальных фаз AgI и C_{Hд}. В случае перхлората лития [28] выдвинуто предположение о возможности частичного разложения LiClO₄ с образованием ионной соли LiCl в аморфном виде на поверхности наноалмазов, которые, вероятно, выступают катализатором процесса разложения. При этом анализ рентгенограмм подтвердил отсутствие LiCl в композиционных образцах (1–*x*)LiClO₄·*x*C_{HД}.



Рисунок 1.2 – Концентрационная зависимость общей электропроводности образцов в системе (1–*x*)AgCl·*x*C_{HД} [27]

1.2.2 Композиционные электролиты типа «ионная соль-соль»

В работах [29–33] проведено изучение композиционных систем на основе протонпроводящих гидрофосфатов щелочноземельных элементов и их смесей с добавкой пирофосфата кремния. Введение добавки SiP₂O₇ приводит к стабилизации высокотемпературной модификации CsH₂PO₄ [29]. Максимальное увеличение электропроводности при температурах ниже 200°C при влажности воздуха 30% наблюдается для образца с 20 мол.% пирофосфата кремния (см. рисунок 1.3а). Увеличение влажности атмосферы приводит к увеличению электропроводности при температурах ниже 200 °C для всех композитов (33– 67 мол.% добавки SiP₂O₇) на 4 порядка величины. Выдвинуто предположение, что причиной КЭ является формирование фазы $CsH_5(PO_4)_2$ на границе контакта зерен матрицы и добавки, однако авторы работы ввиду отсутствия доказательств наличия этой фазы отказались от этой идеи. Авторы работ [30–32] изучали электропроводность композиционных образцов на основе CsH₅(PO₄)₂. Гетерогенным допантом выступали добавки SiP₂O₇, TiP₂O₇ [30]. Композиционные образцы в системе CsH₅(PO₄)₂–SiP₂O₇ проявляют более высокие значения проводимости в сравнении с данными для CsH₅(PO₄)₂ (см. рисунок 1.36). Независимо от количества SiP₂O₇ эффект увеличения электропроводности в интервале температур 150–200 °C находится в пределах 1 порядка величины [31]. К причинам возникновения КЭ авторы работы относят межфазное взаимодействие матрицы и допанта, однако подтверждений не приводят. В работе [32] для композиционных образцов, различающихся предысторией получения фазы допанта, проведен расчет значений электропроводности с использованием приближения эффективной среды. Сравнение модельной и экспериментальной кривой подтверждает образование третьей фазы в данных условиях приготовления композитов.



Рисунок 1.3 – Политермы электропроводности образцов в системах на основе CsH_2PO_4 [29] (a) и $CsH_5(PO_4)_2$ [31, 32] (б) с допантом SiP_2O_7

1.2.3 Композиционные электролиты типа «ионная соль-простой оксид»

В монографии Уварова Н.Ф. подробно рассмотрены физико-химические свойства различных композиционных систем «ионная соль–простой оксид» [33]. Приведены установленные закономерности изменения физико-химических свойств матричной фазы в композиционных системах «ионная соль–простой оксид», проведена систематизация по типу ионной проводимости. Внимание автора акцентируется на роли физико-химического спектра свойств гетерогенной добавки как одного из факторов, определяющего величину композиционного эффекта. К основным причинам возникновения КЭ относят стабилизацию высокотемпературных (высокопроводящих) модификаций матриц и/или их аморфизацию на поверхности или в зернограничной области с гетерогенным допантом вследствие межфазных взаимодействий между матрицей и допантом.

В данном разделе литературного обзора будут рассмотрены аспекты влияния свойств гетерогенного допанта на свойства композиционных электролитов, а также рассмотрены модели возникновения КЭ.

Типичный вид концентрационных зависимостей электропроводности композиционных электролитов «ионная соль – простой оксид»

На рисунке 1.4 представлена типичная концентрационная зависимость электропроводности для композиционного образца [33].



Рисунок 1.4 – Концентрационная зависимость электропроводности образцов (1–*x*)AgCl·*x*Al₂O₃ при комнатной температуре [33]

При анализе зависимости можно выделить три участка, соответствующих изменению мольной доли гетерогенного допанта. Первая область до 30 мол.% добавки, в которой наблюдается резкое увеличение электропроводности. В данном случае, с точки зрения микроструктурных изменений, происходит образование высокопроводящей поверхностной фазы. В области от 30 до 70 мол.% наблюдается плато проводимости. Рост электропроводности компенсируется увеличением содержания в композиционном электролите непроводящей фазы добавки. При дальнейшем увеличении содержания добавки

(от 70 мол.%) наблюдается снижение электропроводности: количественное преобладание непроводящей добавки увеличивает прерывистость путей переноса.

Влияние химической природы добавки на электропроводность композиционных электролитов

На примере композиционных электролитов на основе гидросульфата цезия показана роль природы гетерогенного допанта [34]. На рисунке 1.5 приведены температурные и концентрационные зависимости электропроводности для систем «ионная соль-простой оксид». Гетерогенное композиционных допирование, где в качестве добавки используются оксиды кремния (IV), титана (IV) и алюминия, приводит к возникновению композиционного эффекта в системах «CsHSO₄-простой оксид». Однако величина этого композиционного эффекта различна и зависит от природы допирующего оксида. Так, в соответствии с увеличением кислотной природы оксида в ряду $Al_2O_3 < TiO_2 < SiO_2$, происходит рост величины КЭ. При этом основная природа оксида приводит к нарушению инертности компонентов композита, в случае оксидов алюминия и титана (IV) происходит химическое взаимодействие с матрицей. В межзеренной области образуются фазы, обладающие низкой проводимостью, что отражается на проводимости композиционных образцов.



Рисунок 1.5 – Температурные (а) и концентрационные (б) зависимости электропроводности композитов в системе CsHSO₄–оксид [34]

Влияние дисперсности гетерогенной добавки на электропроводность композиционных электролитов

На основе кислых солей гидросульфата [35] и дигидроортофосфата [36] цезия исследовано влияние дисперсности гетерогенного допанта на рост проводимости. Установлено, что повышение дисперсности диоксида титана приводит к более выраженному композиционному эффекту [35]. На рисунке 1.6а представлена концентрационная зависимость электропроводности для композиционной системы CsHSO₄-TiO₂. Рост электропроводности в области с содержанием допанта (до 30 мол.%) авторы работы объясняют НИЗКИМ стабилизацией разупорядоченной модификации матричной фазы CsHSO₄ на поверхности TiO₂, что подтверждается данными дифференциальнотермического анализа И данными рентгеновских исследований. Это соответствует ранней работе [37], где были исследованы композиты в системе CuCl-Al₂O₃. Однако авторы работы [36] не обнаружили корреляции между дисперсностью гетерогенной добавки и величиной композиционного эффекта в системе CsH₂PO₄–SiO₂. Увеличение дисперсности оксида кремния (IV) приводит к снижению электропроводности (см. рисунок 1.66), при этом полученные результаты не являются воспроизводимыми.



Рисунок 1.6 – Концентрационные зависимости электропроводности (а) для образцов (1–*x*)CsHSO₄–*x*TiO₂ [35] и температурная зависимость электропроводности (б) композитов в системе (1–*x*)CsH₂PO₄–*x*SiO₂ [36] (б) с различной удельной поверхностью гетерогенного допанта

Механизмы возникновения композиционного эффекта

Появление работ с описанием композиционного эффекта также дало развитие теоретическому обоснованию этого явления. Первые попытки описания ионной проводимости композиционных электролитов даются на основании работ Френкеля Я.И. [38] с позиции дефектообразования ионного кристалла. Образование атомных дефектов (рассмотрение дефектов Шоттки и Френкеля) в случае равенства их химических потенциалов приводит к сохранению электронейтральности кристалла. В случае различия химических потенциалов (в реальном ионном кристалле образование разнородных атомных дефектов является конкурентным процессом, зависящим от химического потенциала и, соответственно, энергетики образования дефекта) происходит увеличение концентрации объемных или поверхностных дефектов одного типа и образование избыточного заряда. Компенсация избыточного заряда протекает с образованием диффузного слоя, который обеспечивает электронейтральность всего кристалла, при этом возникает двойной электрический слой (ДЭС).

Развитие модели Френкеля привело к появлению двух точек зрения на природу поверхностного заряда ионного кристалла, в которых были найдены предпосылки для формирования взглядов на природу КЭ. Это модель Френкеля-Кливера [39–41] и теория Гегузина-Лифшица [42, 43], характеризующие образование ДЭС ионного кристалла как возникновение дефектов в объеме или в поверхностном слое кристалла, соответственно.

Применительно к композиционным электролитам проекцию модели ДЭС показал Майер Й. На примере систем «ионная соль–простой оксид» или «МХ– А» [44–47] было показано формирование ДЭС на обоих компонентах композита. Вследствие межфазного взаимодействия, приводящего к адгезии компонентов композиционного электролита, и значительной роли в поверхностных явлениях величины поляризующего действия катиона и поляризуемости аниона, происходит образование плотного слоя катионных вакансий ионной соли, который при повышении температуры трансформируется в диффузный слой. При этом образование катионных вакансий ионной соли оказывает особое влияние на дальнейшее формирование свойств самой ионной соли и композиционных электролитов.

Эти взгляды послужили предпосылками для формулировки модели пространственного заряда, нашедшей свое начало в работах Джоу Т. и Вагнера Дж. [48] и развитие в работах Майера Й. [44–47, 49, 50]. Учитывая малую подвижность плотного слоя, связанного с оксидной поверхностью А, проводимость ионной соли определяется диффузным слоем дефектов. При этом наблюдается роль поверхности в величине концентрации дефектов: при комбинировании граничных условий для возникновения ДЭС (его отсутствие, его обогащение катионными вакансиями или, наоборот, обогащение анионными вакансиями) и модельных процессов дефектообразования для композиционных электролитов типа «МХ-А» формулируется понятие «степени влияния» поверхности, которое может приводить к значительному росту концентрации дефектов диффузного слоя. Дальнейшее предположение, которое помогло сформировать более полную картину изменения ионной проводимости композиционных электролитов, стало равенство подвижности дефектов диффузного слоя и их подвижности в объеме кристалла. Обоснование этого пренебрежении лежит В влияния приповерхностных дефектов на кристаллическую структуру вследствие их незначительной концентрации. ДЭС В перпендикулярном направлении поверхности кристалла должен препятствовать переносу ионов вследствие повышенного сопротивления одного из слоев из-за низкой концентрации наиболее подвижных носителей. При незначительном сопротивлении плотного слоя из-за его малой толщины, барьерным слоем считается обедненный по наиболее подвижным дефектам диффузный слой.

Оценка значений электропроводности композиционных электролитов в зависимости от концентрации гетерогенного допанта

Для математического расчета электропроводности Майер представил микроструктуру композитов следующим образом (см. рисунок 1.7). Матричная фаза ионной соли покрыта слоем частиц оксидной добавки. Межфазное

взаимодействие приводит к перекрыванию образующихся на поверхности компонентов ДЭС.



Рисунок 1.7 – Схема представления микроструктуры композиционного образца [44-47]

С учетом приблизительного расчета объемной доли двойных электрических слоев было предложено уравнение для расчета электропроводности:

$$\sigma = (1 - f)\sigma_{\infty} + 3e\beta_L \frac{2\lambda_D}{L} f v_V \sqrt{n_{\infty} n_{V0}}, \qquad 1.1$$

где f – объемное содержание гетерогенного допанта; β_L – доля ДЭС, принимающих участие в проводимости; $2\lambda_D/L$ – объемная доля единичного ДЭС; n_{V0} – концентрация катионных вакансий; σ_{∞} и n_{∞} – объемные электропроводность и концентрация вакансий, соответственно; v_V – подвижность вакансий.

С помощью этого уравнения удалось удовлетворительно описать экспериментальные данные для систем на основе AgCl, TlCl и AgBr с добавкой изолятора оксида алюминия.

Однако дальнейшие исследования выявили некоторые недостатки теории Майера. Было установлено, что межфазное взаимодействие компонентов композиционного электролита может приводить к образованию специфических фаз, либо аморфизации матричной фазы, что также обусловливало увеличение ионной проводимости композитов.

Типичный ход концентрационной зависимости электропроводности (см. рисунок 1.4) композита проходит через максимум в области до 30 мол.% добавки, в области от 30 до 70 мол.% значения электропроводности сохраняются на одном уровне, затем наступает резкое снижение электропроводности. Прогнозирование хода зависимости может привести к двум результатам. С учетом того, что в качестве добавки используется изолирующий оксид, ход зависимости должен выглядеть иначе: при увеличении содержания добавки электропроводность должна падать вследствие преобладания непроводящей фазы. Либо, с учетом возникновения в межфазной области компонентов высокопроводящего слоя, ход зависимости должен достигать максимума в области объемной доли с преобладанием непроводящей добавки. Однако экспериментальные данные не совпадают с этими теоретическими взглядами.

Для описания различных областей концентрационных зависимостей электропроводности могут использоваться модель эффективной среды или теория перколяции. В случае модели эффективной среды в электропроводности учитывается вклад распределения электрического поля компонента в объеме композита. Описание концентрационной зависимости наблюдается наиболее точно в граничных условиях: мольная доля добавки стремится к 0, что соответствует области с малыми добавками, или к 1 – области больших добавок. При этом нельзя пренебрегать тем фактором, что увеличение доли добавки взаимодействию приводит К некоторому этих частиц И отсутствию изолированности между ними. В таком случае компоненты композита «эффективной среде» размещаются В co средней диэлектрической проницаемостью. В теории перколяции вводится понятие перколяционного порога (порога протекания). Это понятие определяется значением концентрации добавки, при достижении которой значения электропроводности начинают резко Увеличение электропроводности меняться. обусловлено образованием непрерывного проводящего кластера в точке перколяционного перехода. На концентрационной зависимости выделяют три области, в которых значение порога перколяции больше, равно или меньше значения объемной доли гетерогенной добавки. Данная модель хорошо описывает проводимость композитов в области порога перколяции, но не предельные случаи количественного содержания допанта.

1.2.4 Композиционные электролиты типа «ионная соль – сложный оксид»

Авторами работ [51, 52] изучены композиционные электролиты в системе «ионная соль–сложный оксид». На рисунке 1.8 приведены концентрационные зависимости электропроводности композитов в системах CsH_2PO_4 – $SrZrO_3$ [51] и $CsNO_2$ –MgAlO_2 [52]. Установленный композиционный эффект проводимости достигает 2–4 порядков величины в зависимости от температуры съемки. О природе КЭ говорят только в работе [51], к причинам возникновения относят аморфизацию матричной фазы CsH_2PO_4 на поверхности $SrZrO_3$ вследствие межфазного взаимодействия. При этом индифферентность по отношению друг к другу исходных фаз подтверждена рентгеновскими исследованиями, а увеличение электропроводности обусловлено аморфизацией матрицы CsH_2PO_4 на поверхности допанта $SrZrO_3$, что подтверждено методом сканирующей электронной микроскопии.



Рисунок 1.8 – Концентрационные зависимости электропроводности для образцов в системе CsH₂PO₄ – SrZrO₃ [51] и CsNO₂ – MgAlO₂ [52].

Таким образом, в разделе 1.2 рассмотрены композиционные электролиты в системах «ионная соль–добавка», где добавкой выступают простые вещества, соли, простые и сложные оксиды. Основным классом композиционных электролитов стали системы «ионная соль–простой оксид», для которых были рассмотрены эффекты, возникающие при гетерогенном допировании и представлены модели описания КЭ. Стоит отметить, что наблюдаемые концентрационные зависимости обладают схожим характером. Для всех систем наблюдается максимум проводимости, однако в системах «ионная соль–простой или сложный оксид» максимум чаще всего достигается в области < 30 мол.%, реже до 10 мол.%. Вероятно, аналогичное поведение электропроводности должно наблюдаться и в других системах, например с оксидной/сложнооксидной матрицей.

1.3 Композиционные электролиты на основе простых оксидов

1.3.1 Композиционные электролиты типа «простой оксид – соль»

В работах [53–55] рассмотрены композиты на основе простых допированных оксидов Nd_{0.2}Ce_{0.8}O_{1.9} [53], Ce_{0.8}Gd_{0.2}O_{2-δ} [54] и Ce_{0.8}Sm_{0.1}Nd_{0.1}O_{2-δ} [55], где в качестве гетерогенного допанта выступают смеси (0.5Li-0.5Na)₂CO₃ [53], (Li/Na)₂SO₄ [54] или La_{9.33}Si₆O₂₆ [55]. В целом КЭ наблюдается во всех названных системах. Однако две работы [53, 54], где в качестве гетерогенной добавки используются смеси карбонатов или сульфатов, стоит рассмотреть отдельно. Было проведено комплексное исследование электрических свойств: получены зависимости электропроводности от pO_2 , произведен расчет чисел переноса [53], произведен подробный анализ годографов [54]. На рисунке 1.9 представлены изотермическая зависимость электропроводности от pO_2 системы Nd_{0.2}Ce_{0.8}O_{1.9}-(0.5Li-0.5Na)₂CO₃ [53] и концентрационная зависимость электропроводности для $Ce_{0.8}Gd_{0.2}O_{2-\delta} - (Li/Na)_2SO_4$ [54]. Композит системы (0.75 мас.%)Nd_{0.2}Ce_{0.8}O_{1.9}·(0.25 мас.%)(0.5Li-0.5Na)₂CO₃ во всех исследуемых условиях обладает более высокой электропроводностью по сравнению с Nd_{0.2}Ce_{0.8}O_{1.9} [53]; для системы Ce_{0.8}Gd_{0.2}O₂₋₆-(Li/Na)₂SO₄ оптимальными свойствами обладает образец с 20 мас.% (Li/Na)₂SO₄. Однако в названных системах не совсем понятен механизм изменения ионной проводимости, поскольку и фаза матрицы, и фазы допантов могут проявлять ионную проводимость при высокой температуре. При этом исследователи оговариваются о мультиионной проводимости фаз допантов по кислороду, протонам, катионам щелочных элементов, по анионам CO₃²⁻ или SO₄²⁻. Четкого представления о природе КЭ авторы не дают, также не совсем ясен эффект изменения ионной проводимости матрицы при гетерогенном допировании.



Рисунок 1.9 – Зависимость электропроводности от pO_2 образцов в системе Nd_{0.2}Ce_{0.8}O_{1.9}–(0.5Li-0.5Na)₂CO₃ [53] в атмосфере с различной влажностью (а) и концентрационная зависимость электропроводности при 550 °C для образцов в системе Ce_{0.8}Gd_{0.2}O_{2-δ}–(Li/Na)₂SO₄ [54] (б)

В композиционной системе $Ce_{0.8}Sm_{0.1}Nd_{0.1}O_{2-\delta}-La_{9.33}Si_6O_{26}$ [55] высокой ионной проводимостью обладает образец с 30 мас.% добавки. На рисунке 1.10 представлены концентрационные зависимости электропроводности и энергии активации, анализ зависимости электропроводности от парциального давления кислорода подтвердил ионный тип проводимости. Увеличение электропроводности при 500°C для образца с 30 мас.% происходит на 37% в сравнении с проводимостью матричной фазы $Ce_{0.8}Sm_{0.1}Nd_{0.1}O_{2-\delta}$. Природу композиционного эффекта авторы работы связывают с разупорядочением точечных дефектов на границах зерен с уменьшением энергии их миграции.



Рисунок 1.10 – Концентрационная зависимость электропроводности (а) и E_A (б) для образцов в системе Ce_{0.8}Sm_{0.1}Nd_{0.1}O_{2- δ}-La_{9.33}Si₆O₂₆ [55]

1.3.2 Композиционные электролиты типа «простой оксид – простой/сложный оксид»

Авторы работ [56-59] изучали электрические свойства композитов в системах «простой оксид-простой оксид» $Ce_{0.8}Sm_{0.2}O_{2-\delta}-Y_2O_3$ [56], $Zr_{1.92}Y_{0.08}O_{1.96}-Ce_{0.8}Sm_{0.2}O_{1.9}$ [57] «простой И оксид-сложный оксил» Се_{0.85}Sm_{0.15}O_{1.92}–ВаСе_{0.83}Y_{0.17}O_{3-б} [58, 59]. На рисунках 1.11 и 1.12 представлены зависимости электропроводности от температуры [56–59]. Установлено увеличение электропроводности композитов, изменение E_A по сравнению с исходными компонентами, проведен анализ годографов. К причинам увеличения электропроводности авторы работ относят уменьшение зернограничного вклада электропроводности за счет высокодисперсного характера композитов. Это взаимодействию приводит к межфазному исходных компонентов И, соответственно, увеличению концентрации ионных дефектов в зернограничном пространстве, что обусловливает увеличение ионной проводимости. Также стоит отметить, что композиционный эффект проводимости чаще всего наблюдается в системах «ионный проводник-изолятор», в представленных работах оба компонента обладают высокой ионной проводимостью. Эффект увеличения ионной проводимости является не таким значительным как в случае введения изолирующей добавки.



Рисунок 1.11 – Температурные зависимости электропроводности образцов для систем: Ce_{0.8}Sm_{0.2}O_{2-δ}-Y₂O₃ [56] (a), Zr_{1.92}Y_{0.08}O_{1.96}-Ce_{0.8}Sm_{0.2}O_{1.9} [57] (б)



Рисунок 1.12 – Температурные зависимости электропроводности образцов для системы Ce_{0.85}Sm_{0.15}O_{1.92}–BaCe_{0.83}Y_{0.17}O_{3-δ} [58] (а) и [59] (б)

Рассмотрение опубликованных источников [53–59] показало наличие эффекта увеличения проводимости в композиционных системах «простой оксид–соль» и «простой оксид–простой/сложный оксид». При этом он не так выражен как в случае композиционного эффекта проводимости для композиционных систем «ионный проводник–изолятор».

1.4 Композиционные электролиты на основе сложных оксидов

1.4.1 Композиционные электролиты типа «сложный оксид–соль», «сложный оксид–простой оксид» и «сложный оксид–сложный оксид»

В работах [60–62] изучены системы на основе иттрий-допированного церата бария с гетерогенной добавкой вольфрамата или ортофосфата бария: BaCe_{1-x}Y_xO_{3-δ}–BaWO₄ [60, 61], BaCe_{0.9}Y_{0.1}O_{3-δ}–Ba₃(PO₄)₂ [62]. Гетерогенное допирование в обоих случаях не приводит к улучшению электрических свойств, наоборот, проводимость композиционных образцов ниже допированного церата бария, выступающего в роли матричной фазы.

В работах [63–66] в качестве гетерогенного допанта используются карбонаты и их смеси $BaCe_{0.7}Zr_{0.1}Y_{0.2}O_{3-\delta}-2Li_2CO_3:1Na_2CO_3$ [63], $BaZr_{0.8}Y_{0.2}O_{3-\delta}-(Li_2CO_3-38 \text{ мол.}\% \text{ K}_2CO_3)$ или ($Li_2CO_3-48 \text{ мол}\% \text{ Na}_2CO_3$) [64], $SrCe_{0.9}Yb_{0.1}O_{3-\delta}-(Li/K)_2CO_3$ [65], либо системы на основе $SrCe_{0.9}Yb_{0.1}O_{3-\delta}$ с добавкой хлоридов NaCl-CaCl₂ [65], (Na/K)Cl, (NaCl-BaCl₂) [66]. В целом, полученные результаты коррелируют с результатами для систем на основе простых оксидов:

композиционные электролиты обладают высокой ионной проводимостью, что подтверждается комплексом исследований электрических свойств, однако также не объясняется, за счет чего изменяется ионная проводимость матричной фазы.

В работах [67–69] исследованы системы $BaCe_{0.7}In_{0.3}O_{3-\delta}-Gd_{0.1}Ce_{0.9}O_{2-\delta}$ [67], $BaZr_{0.85}Y_{0.15}O_{3-\delta}-Nd_{0.1}Ce_{0.9}O_{2-\delta}$ [68], $Li_{6.4}La_3Zr_{1.4}Ta_{0.6}O_{12}-MgO$ [69]. Авторы работ отмечают сохранение высокой ионной проводимости при гетерогенном допировании, а также эффекты снижения зернограничной составляющей проводимости, увеличения протонной проводимости и т.д. Композиционного эффекта в рассмотренных системах не наблюдается.

В работе [70] рассматриваются композиционные электролиты на основе димолибдата лантана в оксометаллатной эвтектической системе $La_2Mo_2O_9$ – $La_2Mo_3O_{12}$ [70]. Композиционные образцы $(1-x)La_2Mo_2O_9 \cdot xLa_2Mo_3O_{12}$ демонстрируют увеличение объемной электропроводности (см. рисунок 1.13). Максимальный эффект увеличения электропроводности достигается для образца с 10 мол.% допанта и составляет один порядок величины. Авторы работы [70] связывают возникновение композиционного эффекта с формированием новой фазы на поверхности зерен исходных компонентов $La_2Mo_2O_9$ и $La_2Mo_3O_{12}$. Образование фазы $La_5Mo_3O_{16}$ приводит к дополнительному эффекту разупорядочения поверхности основной фазы $La_2Mo_2O_9$. К основному фактору, определяющему поведение электропроводности композиционных образцов в системе $La_2Mo_2O_9$ – $La_2Mo_3O_{12}$, авторы работы относят высокую электропроводность $La_5Mo_3O_{16}$.



Рисунок 1.13 – Концентрационная зависимость объемной проводимости образцов в системе La₂Mo₂O₉–La₂Mo₃O₁₂ [70]

Концепция образования новой поверхностной неавтономной фазы в композиционных системах последовательно развивается в работах А.Я. Неймана с сотрудниками [71–80]. Так, в эвтектических композитах на основе MeW(Mo)O₄-W(Mo)O₃ и Ln₂(WO₄)₃-WO₃ эффект увеличения проводимости объясняется образованием высокопроводящих наноразмерных слоев на фаз межфазного границах раздела как результат поверхностного взаимодействия. Например, в системе Sm₂(WO₄)₃-WO₃ на основе результатов просвечивающей электронной микроскопии показано образование фазы промежуточного состава Sm₂W₆O₂₁, которая не представлена на фазовой диаграмме Sm₂O₃-WO₃. Очевидно, для поверхностных состояний реализуются иные термодинамические условия, и это обеспечивает формирование новых фаз на границах раздела.

Иной подход разрабатывается для композиционных электролитов на основе Bi₂CuO₄–Bi₂O₃, BiVO₄–V₂O₅ и ZnO–Bi₂O₃, ZrV₂O₇–V₂O₅ *с жидкоканальной зернограничной структурой* (ЖЗГС) [81–87]. Формирование композитов происходит при нагревании выше температуры плавления эвтектики. Для таких систем показано, что межзеренные жидкие каналы являются ускоренными диффузионными путями для ионов кислорода, композиты проявляют кислородно-ионный тип проводимости только выше температуры плавления эвтектики. Ниже этой температуры (когда фазы твердые) кислородно-ионная проводимость в композитах не обнаружена.

Таким образом, для композиционных электролитов типа «сложный оксид– простой/сложный оксид» возможна реализация КЭ ионной проводимости. При этом, различные научные группы, изучающие разные композиционные системы, используют разные подходы. Если проводить сопоставление с ранее описанными композиционными солевыми системами (см. раздел 1.2), то для оксидных композиционных систем метод гетерогенного допирования обычно не используют для стабилизации высокотемпературных модификаций. В этой связи интерес представляет структура браунмиллерита, характеризующаяся высоким кислородным дефицитом, но упорядоченным расположением вакансий кислорода. Возможность стабилизации ее высокопроводящих разупорядоченных модификаций имеет как фундаментальный, так и практический интерес.

В разделе 1.5 будут рассмотрены композиционные электролиты типа «сложный оксид–сложный оксид» на основе индата бария Ba₂In₂O₅.

1.5 Композиционные электролиты на основе Ba₂In₂O₅

1.5.1 Структурные особенности и электрические свойства $Ba_2In_2O_5$

С позиции кристаллохимии установлено, что структура индата бария содержит 16.7% кислородно-ионных вакансий от общего числа анионных позиций. Эти структурные особенности предопределяют наличие кислородноионного типа проводимости. Вследствие термической активации в кислородной подрешетке могут происходить эффекты упорядочения-разупорядочения, поэтому для индата бария характерно наличие структурного перехода (см. рисунок 1.14).



ромбическая тетрагональная кубическая Рисунок 1.14 – Структурные модификации индата бария [2]

Известно, что при температурах ниже 930°С Ва₂In₂O₅ описывается структурой типа браунмиллерита, в которой последовательно чередуются слои полиэдров вакансии кислорода находятся в $[InO_6]$ И $[InO_4],$ слоях тетраэдров, упорядоченные кристаллографических вдоль одного ИЗ направлений. Повышение температуры (>930 °C) приводит к разупорядочению в кислородной подрешетке, $Ba_2In_2O_5$ описывается структурой дефектного перовскита.

До 1024 °С вакансии кислорода разупорядочены в слоях тетраэдрических позиций индия (тетрагональная симметрия), выше – вакансии кислорода разупорядочены по трем кристаллографическим направлениям (кубическая симметрия).

В таблице 1.1 приведены литературные данные по группам симметрии и параметров элементарной ячейки ромбической и тетрагональной модификации Ba₂In₂O₅.

Таблица 1.1 Группа симметрии и параметры элементарной ячейки индата бария Ba₂In₂O₅

Ba ₂ In ₂ O ₅	Приме- чание	пр.гр.		а	b	С
	[14]	46	Ibm2	6.086(7)	16.784(2)	5.969(6)
	[5]	46	Ima2	16.713(0)	6.089(0)	5.954(0)
	[15]	46	Ima2	16.719(1)	6.083(3)	5.956(3)
	[16]	46	Ibm2	6.095(6)	16.711(2)	5.960(1)
	[17]	46	Ima2	16.719(1)	6.083(3)	5.956(3)
	[14]	74	Icmm	6.086(4)	16.790(4)	5.969(7)
	[14] 975 K	74	Icmm	6.096(1)	16.867(7)	5.996(2)
	[14] 975 K	74	Icmm	6.096(1)	16.861(8)	5.965(8)
	[18]	74	Іста	6.089(2)	16.736(8)	5.963(2)
	[19]	74	Icmm	6.100(1)	16.723(3)	5.961(1)
	[20]	74	Icmm	6.095(6)	16.726(9)	5.963(5)
	[21]	74	Icmm	6.089(2)	16.736(8)	5.963(2)
	[22]	74	Icmm	6.087(8)	16.744(2)	5.965(6)
	[23]	74	Icmm	6.088(2)	16.754(2)	5.958(7)
	[14] 1223 K	108	I4cm	6.046(8)	6.046(8)	17.111(6)
	[14] 1223 K	108	I4cm	6.049(0)	6.049(0)	17.082(9)
	[14]	108	I4cm	6.034(8)	6.034(8)	17.068(8)
	[14] 1235 K	139	I4/mmm	6.035(1)	6.035(1)	17.064(1)
	[14] 1235 K	139	I4/mmm	6.034(8)	6.034(8)	17.068(8)

Наличие вакансий кислорода определяет возможность внедрения молекул воды в структуру сложного оксида. При этом возникают дефекты протонного типа, вследствие чего в атмосфере с повышенным парциальным давлением паров воды появляется протонная проводимость. В соответствии с квазихимическим подходом появление протонов возможно описать следующим уравнением:

$$V_{0}^{\times} + H_{2}O + 2O_{0}^{\times} \Leftrightarrow O_{i}^{"} + 2(OH)_{0}^{\bullet}, \qquad (1.2)$$

где V_0^{\times} – структурная вакансия кислорода; O_0^{\times} – кислород в регулярной позиции; $O_i^{"}$ – кислород, встроившийся в структурную вакансию; $(OH)_0^{\bullet}$ – протон, локализованный на ионе кислорода.

Максимально внедряющееся количество воды при температуре 300–550°C составляет 1 моль H₂O в пересчете на формульную единицу Ba₂In₂O₅, что соответствует полному заполнению вакансий кислорода. При более низких температурах наблюдается структурно-химическая трансформация индата бария с образованием оксигидратной фазы состава Ba₂In₂O₄(OH)₂ [14], которая описывается тетрагональной симметрией (пр.гр. *P4/mmm*, *a* = 4.182(7) Å, *c* = 8.961(7) Å) [5, 14–23].

Структурный переход индата бария, обусловленный вакансионным разупорядочением, отражается на величине электропроводности [17]. На рисунке 1.15 приведена температурная зависимость общей электропроводности индата бария Ba₂In₂O₅ в атмосферах с различной влажностью. В соответствии с типом структуры на температурной зависимости общей электропроводности индата бария выделяют два участка, соответствующих низкопроводящей (ромбическая структура) и высокопроводящей (тетрагональная или кубическая структуры) модификациям с различным упорядочением в кислородной подрешетке. Структурный переход «порядок–беспорядок» на температурной зависимости общей электропроводности сопровождается скачком проводимости. Во влажной атмосфере в температурной области, где возможен процесс внедрения воды, наблюдается повышение значений электропроводности вследствие возникновения протонного вклада проводимости.



Рисунок 1.15 – Политермы электропроводности в сухом (закрытые символы) и влажном (открытые символы) воздухе для Ba₂In₂O₅ [17]

При анализе зависимостей общей электропроводности от парциального давления кислорода (см. рисунок 1.16) установлено, что при температурах выше 900 °C доминирует ионная проводимость [18]. В этой области температур определены кислородно-ионные числа переноса, составляющие примерно единицу, кислородно-ионная проводимость является доминирующей. При снижении температуры наблюдается появление положительного угла наклона зависимостей, сообщающего о появлении электронной (*p*-типа) проводимости. Доля ионной проводимости снижается, при температуре 600 °C составляет порядка 20%.



Рисунок 1.16 – Изотермические зависимости общей электропроводности от парциального давления кислорода для Ba₂In₂O₅ в сухой атмосфере [18]

Для исследователей интерес стабилизация представляет высокопроводящей модификации Ba₂In₂O₅ до более низких температур, в том числе для повышения энергоэффективности при использовании его в качестве электролитической мембраны твердооксидных топливных элементов. Улучшения электрических свойств индата бария можно добиваться методами гомогенного изо- и гетеровалентного допирования, а также допированием в анионной подрешетке, что широко описано в литературе [19-23]. Использование этих методов не всегда приводит к существенному улучшению термической или химической стабильности. В данной работе для улучшения физико-химических свойств Ba₂In₂O₅ использовался метод гетерогенного допирования.

1.5.2 Создание композиционных электролитов на основе Ba₂In₂O₅

Работы по изучению композиционных электролитов на основе систем «сложный оксид-сложный оксид» представлены в ограниченном количестве. При этом в литературе для индата бария Ba₂In₂O₅ описан метод гетерогенного допирования в единственной статье [24]. В работе [24] рассматриваются композиционные электролиты на основе Ba₂In₂O₅ с гетерогенным допантом Ba_2InTaO_6 . Эвтектический характер сложнооксидной системы Ba₂In₂O₅-Ba₂InTaO₆ обеспечивает инертность компонентов композиционного электролита при его приготовлении. Композиционные образцы демонстрируют значительное увеличение электропроводности, величина композиционного эффекта достигает 2-3 порядков величины в сравнении со значениями электропроводности матричной фазы Ba₂In₂O₅ (см. рисунок 1.17). В работе [24] установлены причины его возникновения, приведены доказательства. Авторы объясняют природу композиционного эффекта для системы Ba₂In₂O₅-Ba₂InTaO₆ следующим образом: эвтектический характер компонентов композиционного электролита при его обработке выше температуры эвтектики приводит к формированию особой микроструктуры, на зернах индата бария наблюдается появление слоя частично аморфизованной фазы эвтектического состава. При этом размер зерен Ba₂In₂O₅ вследствие частичного перехода в расплав и повторной кристаллизации уменьшается, что приводит к стабилизации высокопроводящей модификации
Ва₂In₂O₅. Для системы с гетерогенным допантом индатом-ниобатом бария получены первичные данные, наблюдаются похожие эффекты для электрической проводимости [25], но системных исследований не было проведено.



Рисунок 1.17 – Концентрационные зависимости общей электропроводности в атмосфере с различной влажностью образцов Ba₂In₂O₅–Ba₂InTaO₆ [24]

При композиционных рассмотрении электролитов на основе [24, 70] показано, что метод гетерогенного сложнооксидных матриц допирования обладает некоторыми ограничениями. Эффект значительного увеличения электропроводности наблюдается только в системах эвтектического типа «сложный оксид-сложный оксид». Авторы работ [24, 70] приводят подробное обоснование причин его возникновения. Создание композиционных образцов в квазибинарных эвтектических системах позволяет значительно увеличить кислородно-ионную и протонную проводимость, химическую стабильность и т.д.

Авторы работ [88–90] проводили изовалентное допирование $Ba_2In_2O_5$ катионами алюминия. При этом была определена область гомогенности твердых растворов $Ba_2In_{1-y}Al_yO_5$, достигающая значения *y*=0.40. При увеличении содержания алюминия происходит появление второй фазы Ba_2InAlO_5 . В работе [90] область гомогенности была уточнена: *y*=0.43, формула соответствующего твердого раствора $Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5$. Отсутствие химического взаимодействия

между граничным твердым раствором Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ и фазой Ba₂InAlO₅, вероятно, обусловлено эвтектическим характером квазибинарной системы $Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 - Ba_2InAlO_5.$ Фаза Ва₂InAlO₅ может выступать в качестве гетерогенного допанта для $Ba_2In_2O_5$, в системе $Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5$ - Ba_2InAlO_5 возможно возникновение КЭ. В литературе [89] структура Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ описывается тетрагональной симметрией (пр.гр. *I4cm*), также изучены ее электрические свойства, электропроводность твердого раствора при 500 °C достигает значений 7.5·10⁻⁵ Ом⁻¹см⁻¹ в сухой и 1.9·10⁻⁴ Ом⁻¹см⁻¹ во влажной атмосферах. По структуре фазы Ba₂InAlO₅ в литературе [91, 92] имеются различные данные. Структура фазы описывается гексагональной (пр.гр. *P6*₃/*mmc*) [91] или кубической симметрией (пр.гр. *Pm3m*) [92] в зависимости от методики синтеза. Данные по электропроводности Ba₂InAlO₅ отсутствуют.

В соответствии с диаграммой состояния [93] ВаO–In₂O₃ индат бария $Ba_2In_2O_5$ образует квазибинарную эвтектическую систему с индатом бария состава $Ba_4In_6O_{13}$ (см. рисунок 1.18). Фаза $Ba_4In_6O_{13}$ также может выступать в качестве гетерогенного допанта для $Ba_2In_2O_5$, в системе $Ba_2In_2O_5$ – $Ba_4In_6O_{13}$ возможно возникновение композиционного эффекта.



Рисунок 1.18 – Диаграмма состояния BaO–In₂O₃ [93]

Ва₄In₆O₁₃ существует в двух полиморфных модификациях [93]. Низкотемпературная модификация (ромбической сингония, пр.гр. Стт2) с параметрами элементарной ячейки: a = 11.915(3) Å, b = 11.872(3) Å, Å. 1325°С происходит 20.57(1)При температуре переход в модификацию, характеризующуюся высокотемпературную моноклинной сингонией (пр.гр. P21/m); a = 15.187(3) Å, b = 24.527(2) Å, c = 4.1867(7) Å, $\gamma =$ 114.66(1) Å. В работе [94] структура индата бария Ва₄In₆O₁₃ представлена в виде чередующихся слоев перовскитного типа "Ва₂In₂O₆-", состоящих из октаэдров $[InO_6]$, и блоков "Ba₂In₄O₇-" (см. рисунок 1.19), где атом индия координирован пятью атомами кислорода [InO₅].



Рисунок 1.19 – Блочно-слоевое представление структуры Ва₄In₆O₁₃ [94]

Литература по электропроводности $Ba_4In_6O_{13}$ ограничена и данные противоречивы. На рисунке 1.20 представлена температурная зависимость общей проводимости для $Ba_4In_6O_{13}$ при различном парциальном давлении кислорода. Авторами работы не указана информация о контроле влажности атмосферы при электрических измерениях. Общая электропроводность $Ba_4In_6O_{13}$ сопоставима со значениями для $Ba_2In_2O_5$, вклады ионной и электронной проводимости практически равны [95].



Рисунок 1.20 – Температурная зависимость электропроводности фазы Ва₄In₆O₁₃ [95]

В разделах 1.2–1.4 был рассмотрен метод гетерогенного допирования применительно к матрицам различного типа. Наиболее широко изучены композиты на основе ионных солей с добавкой непроводящего оксида, показаны основные тенденции изменения электрических свойств при добавлении гетерогенной добавки, рассмотрена роль добавки, разобраны основные модели возникновения КЭ и модели, позволяющие описать концентрационные зависимости электропроводности композиционных электролитов. Оксидные и сложнооксидные системы с гетерогенной добавкой солевой или оксидной природой изучены мало, однако полученные результаты предполагают перспективность развития этого направления.

При рассмотрении композиционных систем с разной природой матричной и гетерогенной фаз акцент принципиально сделан на электрические свойства. Однако в большинстве работ отмечается положительное влияние введения гетерогенного допанта также и на плотностные характеристики керамики, микроструктуру образцов, их химическую, термическую, механическую стабильность и т.д.

Таким образом, метод гетерогенного допирования является перспективным подходом, использование которого позволяет получать композиционные электролиты с улучшенным спектром физико-химических свойств.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

При анализе литературы была показана перспективность оптимизации электрических свойств ионных проводников с помощью метода гетерогенного Метод гетерогенного допирования предполагает создание допирования. Особенностью композиционных электролитов. ЭТОГО метода является возможность возникновения композиционного эффекта проводимости – электропроводность композиционных образцов может быть выше на несколько порядков величины по сравнению с проводимостью исходных компонентов. Этот метод модифицирования свойств достаточно хорошо описан и успешно использован лля солевых систем типа «соль-инертная добавка Α (простой/сложный оксид)». При этом морфологические характеристики компонента А практически полностью определяют размерные параметры и транспортные свойства таких композитов. Наименее изученным классом композиционных электролитов являются системы типа «сложный оксидпростой/сложный оксид» ввиду трудности подбора гетерогенного допанта. Для систем типа «сложный оксид-простой оксид А» основной литературный материал ограничен описанием подбора второй фазы А, как спекающей добавки. С точки зрения реализации композиционного эффекта в таких системах трудность сопряжена с возможностью образования каких-либо непроводящих фаз, в соответствии с диаграммой состояния. Этого недостатка можно избежать при подборе второго компонента, который характеризуется эвтектическим характером взаимодействия с матричной фазой. С этой точки зрения интерес для исследования могут представлять композиционные системы типа «сложный оксид'-сложный оксид"». Хотя В литературе описаны квазибинарные эвтектические композиционные системы типа «сложный оксид'-сложный оксид"», но эти данные разрознены и нет системных исследований относительно влияния на электропроводность температуры обработки композита, природы гетерогенного допанта с точки зрения типа проводимости, а также его дисперсности.

Индат бария состава Ba₂In₂O₅ является хорошо изученным соединением. Наличие структурных вакансий кислорода определяет кислородно-ионный тип проводимости в сухой атмосфере и протонный тип проводимости во влажной или водородсодержащей атмосферах. При этом наличие структурного перехода типа «порядок-беспорядок», сопровождающийся повышением симметрии элементарной ячейки с ромбической на тетрагональную, обеспечивает высокую ионную проводимость Ba₂In₂O₅, сопоставимую с проводимостью лучших проводников. Однако этот переход реализуется достаточно при высоких температурах выше 925 °C. Так, для композиционных электролитов на основе индата бария Ba₂In₂O₅ в единственной работе [24] было показано наличие композиционного эффекта в квазибинарной эвтектической системе Ba₂In₂O₅- Ba_2InTaO_6 . Для матричной фазы зафиксирована стабилизация высокопроводящей модификации при комнатной температуре вследствие размерного эффекта.

В настоящей работе индат бария Ba₂In₂O₅ выбран в качестве матричного компонента композиционных электролитов. Для индата бария хорошо описаны электрические свойства, структурные И подходы к оптимизации электропроводности Ba₂In₂O₅, что определяет Ba₂In₂O₅ в качестве удобного модельного объекта. В литературе описаны результаты по гомогенному допированию индата бария алюминием, в ходе замещения образуются твердые растворы с граничным составом Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅, при увеличении концентрации формируется двухфазная система $Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5$ - Ba_2InAlO_5 . алюминия Отсутствие системных данных по комплексному исследованию физикохимических свойств композиционных электролитов типа «сложный оксид'сложный оксид"» обуславливают фундаментальный интерес по изучению метода гетерогенного возможностей и перспективности использования допирования.

Для гетерогенного допирования индата бария Ba₂In₂O₅ и твердых растворов на его основе были выбраны следующие гетерогенные допанты: индат-ниобат бария Ba₂InNbO₆, индат-алюминат бария Ba₂InAlO₅ и индат бария

состава Ba₄In₆O₁₃. Их выбор обусловлен предполагаемым или доказанным эвтектическим характером квазибинарных систем состава Ba₂In₂O₅–Ba₂InNbO₆, Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅–Ba₂InAlO₅ и Ba₂In₂O₅–Ba₄In₆O₁₃. При этом ограниченное количество литературных данных для фаз Ba₂InNbO₆ и Ba₄In₆O₁₃ дает возможность предположить отличие природы проводимости этих фаз от индата бария. Это формирует дополнительный фундаментальный интерес при изучении эффективности метода гетерогенного допирования с различной природой проводимости гетерогенного допанта. В случае системы с алюминатом Ba₂InAlO₅ интерес представляет возможность одновременного гомогенного и гетерогенного допирования.

Поэтому целью настоящей работы стало установление закономерностей влияния гетерогенного допанта на электрические свойства индата бария Ba₂In₂O₅ и твердых растворов на его основе, а также анализ композиционного эффекта в эвтектических композитах.

В рамках сформулированной цели были поставлены следующие задачи:

– синтез индивидуальных соединений $Ba_2In_2O_5$, Ba_2InNbO_6 , Ba_2InAlO_5 , $Ba_4In_6O_{13}$; получение композиционных образцов в системах $Ba_2In_2O_5$ – Ba_2InNbO_6 , $Ba_2In_2O_5$ – Ba_2InAlO_5 и $Ba_2In_2O_5$ – $Ba_4In_6O_{13}$ методом *in situ* и/или методом смешения;

 аттестация фазового состава образцов и их микроструктуры; оценка плотностных характеристик керамических образцов;

 изучение термических свойств образцов, определение фактической степени гидратации;

 исследование общей электропроводности для образцов в зависимости от температуры, парциального давления паров воды и кислорода; определение ионных чисел переноса, дифференциация проводимости на парциальные вклады;

 установление причин влияния метода гетерогенного допирования на электрические свойства композиционных электролитов; расчет электропроводности композиционных электролитов в системе Ba₂In₂O₅– Ba₂InNbO₆ с помощью математических моделей.

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Синтез индивидуальных фаз

Для синтеза индивидуальных сложнооксидных фаз Ba₂In₂O₅, Ba₂InNbO₆, Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅, Ba₂InAlO₅ и Ba₄In₆O₁₃ использовали твердофазную технологию. Сложный оксид Ba₂InNbO₆ был также получен растворным методом.

Твердофазная технология

Синтез исходных веществ по твердофазной технологии производили в соответствии со следующими уравнениями химических реакций:

$$2BaCO_3 + In_2O_3 \xrightarrow{t} Ba_2In_2O_5 + 2CO_2, \qquad (2.1)$$

$$4\text{BaCO}_{3} + \text{In}_{2}\text{O}_{3} + \text{Nb}_{2}\text{O}_{5} \xrightarrow{t} 2\text{Ba}_{2}\text{InNbO}_{6} + 4\text{CO}_{2}, \qquad (2.2)$$

$$4BaCO_{3} + 1.57In_{2}O_{3} + 0.43Al_{2}O_{3} \xrightarrow{t} 2Ba_{2}In_{1.57}Al_{0.43}O_{5} + 4CO_{2}, \qquad (2.3)$$

$$4BaCO_3 + In_2O_3 + Al_2O_3 \xrightarrow{t} 2Ba_2InAlO_5 + 4CO_2, \qquad (2.4)$$

$$4BaCO_3 + 3In_2O_3 \xrightarrow{t} Ba_4In_6O_{13} + 4CO_2$$
(2.5)

Для синтеза использовали карбонаты и оксиды металлов; их названия, квалификация и режимы термообработки приведены в таблице 2.1.

Tac	5лица 2.1	-X	арактеристика	исходных	реагентов и	режимы и	х предоб	рабо	гки.
	,		1 1	7 1	1	1	1 ' '	1	

Название вещества	Формула	Квалификация	Режим термообработки	
Карбонат бария	BaCO ₃	ОСЧ 7-4	600 °С, 3 часа	
Оксид индия (III)	In ₂ O ₃	ОСЧ 12-3	600 °С, 3 часа	
Оксид ниобия (V)	Nb ₂ O ₅	ОСЧ 8-2	600 °С, 3 часа	
Оксид алюминия	Al_2O_3	ОСЧ 12-3	300 °С, 3 часа	

Навески обработанных в условиях, приведенных в таблице 2.1, карбонатов и оксидов металлов брали на аналитических лабораторных весах ALC–210d4 (ACCULAB, Германия) с точностью ±10⁻⁴ г. Для гигроскопичного карбоната бария использовали метод «горячих навесок»: предварительно выдержанный в течение 180 минут при 600 °C карбонат помещали в бюкс с известной массой, охлаждали до комнатной температуры и проводили взвешивание.

Смешанные в соответствии со стехиометрическими соотношениями карбонат бария и оксиды металлов подвергали продолжительным высокотемпературным отжигам. Перед началом синтеза и после каждой стадии термообработки реакционные смеси подвергали гомогенизации в среде этанола в течение 60 минут. В таблице 2.2 представлены температуры стадий отжига и их длительность.

Damaatina	Стадия							
Бещество	1	2	3	4				
BaoInoOc	800 °C, 24	1000 °C, 24	1200 °C, 12	1300 °C, 12				
Da2111205	часа	часа	часов	часов				
BasInNbO	800 °C, 24	1000 °C, 24	1200 °C, 12	1300 °C, 12				
	часа	часа	часов	часов				
BaoInt or Ala 40 Oc	800 °C, 24	1000 °C, 24	1100 °C, 12	1200 °C, 12				
Da21111.57A10.43O5	часа	часа	часов	часов				
BasInAlOc	800 °C, 24	1000 °C, 24	1100 °C, 12	1200 °C, 12				
Da2mAiO5	часа	часа	часов	часов				
Bailni	800 °C, 10	1000 °C, 10	1200 °C, 24					
Da4116013	часа	часа	часа					

Таблица 2.2 – Стадии температурных отжигов и их продолжительность.

Растворная технология

Фаза Ва₂InNbO₆ была дополнительно синтезирована по растворной технологии с использованием нитрат-органического метода. В таблице 2.3 приведены используемые для синтеза химические соединения с указанием квалификации.

Таблица 2.3 – Характеристика исходных реагентов

			Режим
Название вещества	Формула Квалификация		термообработки
Нитрат бария	$Ba(NO_3)_2$	ХЧ	150 °С, 3 часа
Оксид индия (III)	In_2O_3	ОСЧ 12-3	600 °С, 3 часа
Оксид ниобия (V)	Nb_2O_5	ОСЧ 8-2	600 °С, 3 часа
Сульфат аммония	$(NH_4)_2SO_4$	ЧДА	_
Раствор аммиака	NH ₃ ·H ₂ O	ЧДА	_
Серная кислота	H_2SO_4	ХЧ	_
Оксалат аммония	$(NH_4)_2C_2O_4$	ХЧ	_
Азотная кислота	HNO ₃	ОСЧ 8-4	_
Лимонная кислота	$C_6H_8O_7$	ХЧ	_
Глицерин	$C_3H_8O_3$	ЧДА	_

Основные этапы синтеза:

1) Растворение оксида ниобия

Растворение оксида ниобия (V) осуществляли с помощью концентрированной серной кислоты и сульфата аммония через получение сульфатного комплекса по уравнению химической реакции:

$$Nb_{2}O_{5} + 3(NH_{4})_{2}SO_{4} + 3H_{2}SO_{4} \xrightarrow{t} 2(NH_{4})_{3}[NbO(SO_{4})_{3}] + 3H_{2}O$$
(2.6)

Полученный раствор декантировали, отделяя от частично нерастворенного оксида ниобия (V). Проводили осаждение ниобиевой кислоты (гидратированного оксида ниобия) из раствора при помощи аммиака по следующему уравнению химической реакции:

$$2(\mathrm{NH}_4)_3[\mathrm{NbO}(\mathrm{SO}_4)_3] + 6\mathrm{NH}_3 \cdot \mathrm{H}_2\mathrm{O} \longrightarrow \mathrm{Nb}_2\mathrm{O}_5 \cdot 3\mathrm{H}_2\mathrm{O} \downarrow + 6(\mathrm{NH}_4)_2\mathrm{SO}_4$$
(2.7)

Для удаления адсорбированных сульфат-анионов гелеобразный осадок подвергали многократному отстаиванию в дистиллированной воде с последующим фильтрованием. После каждой процедуры отмывки осадка пробу фильтрата проверяли на наличие сульфат-ионов путем проведения качественной реакции: $Ba^{2+} + SO_4^{2-} = BaSO_4 \downarrow$. При отсутствии признаков реакции отмывку осадка прекращали.

Осадок ниобиевой кислоты переводили в растворимый оксалатный комплекс по следующему уравнению химической реакции:

$$Nb_{2}O_{5} \cdot 3H_{2}O + 6(NH_{4})_{2}C_{2}O_{4} + 12HNO_{3} \xrightarrow{t} 2H_{3}[NbO(C_{2}O_{4})_{3}] + 12NH_{4}NO_{3} + 6H_{2}O \qquad (2.8)$$

Определение содержания в полученном растворе ниобия в пересчете на оксид ниобия (V) проводили в несколько параллелей весовым методом по схеме: 1) отбор аликвоты (1 мл раствора); 2) нанесение аликвоты на бумажный фильтр «синяя лента»; 3) сушка фильтра; 4) озоление фильтра на плитке; 5) прокаливание остатка для обеззоливания в муфельном шкафу при температуре 600 °C; 6) взвешивание сухого остатка.

2) Растворение нитрата бария и оксида индия (III)

Расчет навесок нитрата бария и оксида индия (III) проводили в соответствии с точным объемом Nb-содержащего раствора и результатом его

весового анализа в пересчете на Nb_2O_5 . Растворение предобработанных $Ba(NO_3)_2$ и In_2O_3 проводили в воде и в водном растворе азотной кислоты, соответственно.

3) Синтез индата-ниобата бария

Далее получали рабочий раствор с помощью сливания растворенных форм Nb⁵⁺, Ba²⁺ и In³⁺ с добавлением лимонной кислоты и глицерина, которые выступают в качестве хелатирующих агентов и органического топлива, а также выступают в качестве полимеров для образования полимерно-солевой композиции. Расчет органической составляющей проводили в следующем соотношении: сумма катионов металлов, лимонной кислоты и глицерина составляло 1:0.5:1.5. Растворение органической компоненты проводили при умеренном нагревании. Рабочий раствор помещали на водяную баню и проводили упаривание до сиропообразного состояния. Продолжение нагревания приводило к самовоспламенению смеси. Сухой остаток после возгорания продукт синтеза, остатки исходных оксидов и неполного сгорания органики. Уравнение химической реакции процесса горения может быть представляено следующим образом:

$$H_{3}[NbO(C_{2}O_{4})_{3}] + In(NO_{3})_{3} + 2Ba(NO_{3})_{2} + C_{6}H_{8}O_{7} + C_{3}H_{8}O_{3} + \frac{3}{4}O_{2} \xrightarrow{t} \\ \xrightarrow{t} Ba_{2}InNbO_{6} + 15CO_{2} + \frac{19}{2}H_{2}O + \frac{7}{2}N_{2}$$
(2.9)

Сухой остаток дополнительно отжигали при температуре 1000 °С в течение 300 минут, при этом происходило завершение процесса синтеза Ba₂InNbO₆.

2.2 Приготовление композиционных образцов

Приготовление композиционных образцов проводили по схеме, представленной на рисунке 2.1. Использовали два метода: метод механического смешения индивидуальных сложнооксидных фаз, предварительно синтезированных по твердофазной или растворной технологии, и метод *in situ*, то есть при одновременном твердофазном синтезе компонентов композита в одной реакционной смеси.

Приготовление композиционных образцов:									
Ι	Метод <i>in situ</i> : одновременный твердофазный синтез исходных фаз в одной реакционной смеси	Метод механического смешения: смешение индивидуальных фаз с различной предысторией синтеза (*)							
II	Компактирование образцов методом изостатического прессования								
III	Обработка при температуре выше и/или ниже температуры эвтектики системы «сложный оксид – сложный оксид»								
(*)	использование различной технологии с 1) твердофазный метод 2) растворный метод	интеза гетерогенного допанта:							

Рисунок 2.1 – Схема приготовления композиционных образцов

Метод смешения

Композиционные образцы $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6$ (x=0.01-0.30) были приготовлены методом механического смешения. Основная фаза $Ba_2In_2O_5$ была получена твердофазным методом, а синтез фазы Ba_2InNbO_6 был проведен по твердофазной Ba_2InNbO_6 (т) или растворной Ba_2InNbO_6 (р) технологиям; обозначение композитов, соответственно, $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6$ (тт) и $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6$ (тр). Зашихтовку смесей производили в соответствии с заданным мольным соотношением компонентов, смесь гомогенизировали в среде этанола в агатовой ступке в течение 120 минут при постепенном добавлении второй фазы маленькими порциями в ходе первых 60 минут перетирания и предварительно отжигали при температуре 1000 °C 5 часов.

Memod in situ

Композиционные образцы составов $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6$, $(1-z)Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 zBa_2InAlO_5$ и $(1-z)Ba_2In_2O_5 zBa_4In_6O_{13}$ были получены методом *in situ*, при одновременном твердофазном синтезе компонентов в реакционной смеси, по следующим уравнениям химических реакций:

$$2\text{BaCO}_{3} + \frac{2-x}{2}\text{In}_{2}\text{O}_{3} + \frac{x}{2}\text{Nb}_{2}\text{O}_{5} \xrightarrow{t} (1-x)\text{Ba}_{2}\text{In}_{2}\text{O}_{5} \cdot x\text{Ba}_{2}\text{In}\text{NbO}_{6} + 2\text{CO}_{2}, \qquad (2.10)$$

$$2\text{BaCO}_{4} + \frac{1.57 - 0.57z}{10}\text{In}_{1}\text{O}_{4} + \frac{0.43 + 0.57z}{10}\text{Al}_{2}\text{O}_{5} \xrightarrow{t} (1-x)\text{Ba}_{2}\text{In}^{2}\text{O}_{5} \cdot x\text{Ba}_{2}\text{In}^{2}\text{Nb}_{6} + 2\text{CO}_{2}, \qquad (2.10)$$

$$\begin{array}{c} 2 & 1 \\ - \frac{t}{2} \\ -$$

$$(2+2z)BaCO_3 + (1+2z)In_2O_3 \xrightarrow{t} (1-z)Ba_2In_2O_5 \cdot zBa_4In_6O_{13} + (2+2z)CO_2$$
 (2.12)

Взятие навесок проводили способом, описанным в пункте 2.1. Зашихтованные в соответствующих мольных соотношениях смеси веществ подвергали стадийным отжигам, совпадающим по температурам и длительности с отжигами для индивидуальных сложных оксидов (см. таблицу 2.2).

Полученные порошки $(1-x)Ba_2In_2O_5 \cdot xBa_2InNbO_6$, $(1-z)Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 zBa_2InAlO_5$ и $(1-z)Ba_2In_2O_5 zBa_4In_6O_{13}$ с x, z=0.00-1.00 компактировали методом холодного статического прессования на гидравлическом прессе ПЛГ-12 (LabTools, Россия) в таблетки диаметром 7–10 мм, толщиной 2-4 мм при давлении пресса 4.0-7.0 МПа. Брикетированные образцы подвергали дополнительной термообработке. Для индивидуальных соединений температура дополнительной обработки превышала температуру последней стадии синтеза на 100 °С. Для композиционных образцов финальную $(1-x)Ba_2In_2O_5 \cdot xBa_2InNbO_6$ стадию отжига проводили при температурах ниже (1300 °C) и выше (1400 °C) температуры эвтектики квазибинарной системы $Ba_2In_2O_5-Ba_2InNbO_6$ ($t_{3BT}=1355$ °C). Для уточнения температуры эвтектики и определения эвтектического состава в квазибинарной системе Ba₂In₂O₅-Ba₂InNbO₆ были получены кривые охлаждения для образцов с 20-30 мол.% добавки Ba₂InNbO₆; съемку проводили в одинаковых условиях: скорость охлаждения составляла 2 °С/мин, масса образца составляла 3.5 г. Для композиционных образцов (1-z)Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·zBa₂InAlO₅ обработка также проводилась ниже (1220 °C) и выше (1270 °C) температуры эвтектики квазибинарной системы $Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5-Ba_2InAlO_5$ ($t_{3BT}=1255$ °C), которая была определена в настоящей работе по результатам съемки кривой охлаждения. На 2.2 представлена рисунке кривая охлаждения композиционного образца 0.52Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·0.48Ba₂InAlO₅.



Рисунок 2.2 – Кривая охлаждения композиционного образца 0.52Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·0.48Ba₂InAlO₅

Для композиционных образцов $(1-z)Ba_2In_2O_5 \cdot zBa_4In_6O_{13}$ финальную обработку керамики проводили при температуре 1350 °C, что ниже температуры эвтектики квазибинарной системы $Ba_2In_2O_5-Ba_4In_6O_{13}$ ($t_{3BT}=1375$ °C) [93]. Обработка композиционных образцов $(1-z)Ba_2In_2O_5 \cdot zBa_4In_6O_{13}$ выше температуры эвтектики приводила к плавлению порошков и брикетов, поэтому исследования таких образов не проводили.

2.3 Подготовка образцов для исследований

Индат бария Ba₂In₂O₅ и некоторые твердые растворы на его основе при взаимодействии с парами воды способны при низких температурах претерпевать структурно-химическую трансформацию, сопровождающуюся образованием оксигидратных фаз (см. главу 1, пункт 1.5.1), что может влиять на результаты исследований и их интерпретацию. В связи с этим образцы перед рядом исследований подвергали предварительной обработке в атмосферах с заданным парциальным давлением паров воды, получая либо безводные, либо полностью гидратированные формы.

Так, для проведения рентгеновских исследований образцы предварительно выдерживали в сухой атмосфере (*p*H₂O=3·10⁻⁵ атм.) Для проведения термогравиметрических исследований образцы предварительно выдерживали в

атмосфере с повышенным парциальным давлением паров воды (pH₂O=2·10⁻²) атм.) Использовали следующую схему обработки: проводили нагрев образца со скоростью 2 °С/мин в атмосфере заданной влажности, выдержку при 900 °С в течение 60 минут, охлаждение до 250 °С и выдержку в течение 60 минут. Далее образцы извлекали, переносили в высушенные емкости и герметично упаковывали. Установления определенного *p*H₂O достигали с помощью барботирования воздуха через систему склянок Тищенко (сухая атмосфера) или систему склянок Дрекселя (влажная атмосфера). Для задания сухой атмосферы использовали пентаоксид фосфора, для задания влажной атмосферы – насыщенный раствор бромида калия. Предотвращение карбонизации образцов в сухой и влажной атмосферах достигали пропусканием воздуха через реактив содержащий твердую щелочь, раствор 30%-го NaOH. «Аскарит», И соответственно.

Исследование электрических свойств проводили на керамических образцах. Перед исследованием торцы подготовленных брикетов шлифовали наждачной бумагой и покрывали дисперсной платиновой пастой. Вжигание электродов проводили при температуре на 50 °C выше максимальной температуры эксперимента в течение 60 минут.

2.4 Исследования фазового состава

Для контроля фазового состава образцов использовали метод порошковой рентгеновской дифракции. Измерения проводили на предварительно осушенных образцах (см. пункт 2.3) на дифрактометрах D8 Advance (Bruker, Германия) и EQUINOX 3000 (Thermo Scientific, Франция) при следующих инструментальных параметрах: CuK_α-излучение, напряжение на трубке 40 кВ, ток 40 мА. Рентгенограммы получены при комнатной температуре в диапазоне углов $2\Theta=10-80^{\circ}$. Обработка рентгенограмм проводилась методом полнопрофильного анализа Ритвельда по бесструктурной модели Ле Бейла с помощью программного обеспечения FullProf.

2.5 Исследование морфологии образцов

сканирующей Методом электронной микроскопии производили аттестацию морфологических особенностей образцов. Исследования проводились для порошков и/или керамических образцов, как с поверхности, так и со сколов. Съемка проводилась при 20 кВ во вторичных электронах I или II типа и обратноотраженных электронах; рабочее расстояние 15 мм. Для измерений использовали следующие модели электронных микроскопов: Еvo LS10 (Carl Zeiss NTS, Германия), JEOL JSM-6390LA (JEOL, Япония) с приставкой для энергодисперсионного анализа JED 2300 (JEOL, Япония), и Sigma VP (Carl Zeiss, Германия). Исследование выполнено с использованием оборудования УЦКП «Современные нанотехнологии» ИЕНиМ УрФУ. Также морфология и микроструктура объектов проанализированы при помощи электронного VEGA3 Чехия), сканирующего микроскопа (TESCAN, оснащенного системой AztecLive Standard Ultim Max 40 (Oxford Instruments) для энергодисперсионной проведения микроанализа методом рентгеновской спектроскопии (ЭДС). Съемку осуществляли при ускоряющем напряжении 20 кВ и рабочем расстоянии 15 мм.

2.6 Исследование плотности керамических образцов

Плотность керамических образцов определяли методом Удаление адсорбционной гидростатического взвешивания. воды перед измерением массы образца проводили выдержкой брикетов при температуре 150 °C, после определяли массу (m_1 – масса осушенного образца на воздухе). Осушенный образец помещали на 24 часа в керосин – химически инертную для образца среду. Далее фиксировали массу образца, полностью погруженного в керосин – гидростатическое взвешивание в керосине (m_2 – масса образца в керосине). После, вынув образец и удалив излишки керосина, проводили установление массы образца после выдержки в керосине, когда открытые поры образца заполнены керосином (m_3 – масса образца, выдержанного в керосине).

Вычисление кажущейся плотности ($\rho_{\kappa a \varkappa}$) в г/см³ проводили по формуле:

$$\rho_{\text{\tiny Kam}} = \frac{m_1}{m_3 - m_2} \cdot \rho_m, \qquad (2.13)$$

где $\rho_{\rm m}$ – плотность жидкости (плотность керосина 0.81 г/см³).

Вычисление открытой пористости (П_{откр}) в процентах проводили по формуле:

$$\Pi_{\rm orkp} = \frac{m_3 - m_1}{m_3 - m_2} \cdot 100\% \tag{2.14}$$

Общую пористость образцов (П_{обш}) в процентах вычисляли по формуле:

$$\Pi_{\text{otkp}} = \frac{\rho_{\text{HCT}} - \rho_{\text{kaw}}}{\rho_{\text{HCT}}} \cdot 100\%, \qquad (2.15)$$

где р_{ист} – рентгенографическая плотность материала, принимаемая за истинную плотность.

Истинная плотность композиционных образцов рассчитывалась в соответствии с объемными долями компонентов по следующей формуле:

$$\rho_{\rm \tiny HCT} = (1 - x)\varphi_1 + x\varphi_2, \tag{2.16}$$

где φ_1, φ_2 — объемная доля исходных фаз, входящих в состав композита, x — мольная доля основной фазы композиционного образца.

Закрытую пористость образцов ($\Pi_{_{3акр}}$) оценивали как разность $\Pi_{_{общ}}$ и $\Pi_{_{откр}}$:

$$\Pi_{\rm sakp} = \Pi_{\rm ofill} - \Pi_{\rm otkp}. \tag{2.17}$$

Методом гидростатического взвешивания определена плотность керамических образцов $(1-z)Ba_2In_2O_5 \cdot zBa_4In_6O_{13}$ с различным содержанием добавки $Ba_4In_6O_{13}$. Также были произведены расчеты пористости керамики (открытой, закрытой, общей). Определенные значения плотности и рассчитанные значения пористости приведены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 Значения пористости и относительной плотности для керамики на основе композиционных образцов (1–*z*)Ва₂In₂O₅·*z*Ba₄In₆O₁₃ (*z*=0.03–0.70)

Z	$ ho_{ m oth},\%$	$ ho_{{ m каж}}^{{ m гидp}},{ m \Gamma/cm}^3$	$ ho_{_{ m HCT}}, \Gamma/{ m cm}^3$	$ ho_{_{ m OTH}}^{_{ m FUZP}}$, % ³	Потк,%	Побщ,%	∏закр,%
z=0.03	88.49	5.66	6.40	88.36	5.30	11.64	6.34
<i>z</i> =0.10	91.25	5.86	6.45	90.82	6.29	9.18	2.89
z=0.20	88.77	6.15	6.51	94.51	0.55	5.49	4.94
z=0.30	91.97	5.88	6.55	89.67	2.05	10.33	8.28
<i>z</i> =0.32	99.99	6.486	6.487	99.98	0.00	$1 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$

2.7 Исследование термических свойств

Подтверждение и уточнение возможности взаимодействия образцов с молекулами воды в газовой фазе проводили методом термогравиметрического анализа. Исследования предварительно гидратированных образцов (см. пункт 2.3) проводили в режиме нагрева на синхронном термоанализаторе 409 PC analyzer (Netzsch, Германия) в атмосфере аргона. Интервал температур составлял 100–1000 °C, скорость нагрева – 10 °C/мин.

Термический анализ в режиме нагрева-охлаждения и в изотермическом режиме проводили на термогравиметрических весах Pyris 1 TGA (PerkinElmer, США) в атмосфере азота с различным pH_2O . Сухую атмосферу задавали пропусканием азота через цеолиты и пентаоксид фосфора ($pH_2O=3\cdot10^{-5}$ атм). Влажную атмосферу устанавливали, пропуская поток азота через воду и насыщенный раствор бромида калия ($pH_2O=0.02$ атм). Для установления промежуточных значений pH_2O использовали систему ротаметров PMR-011403 (AALBORG, США), с помощью которой производилось смешение необходимых объемов газов сухой и влажной атмосфер. Определение парциального давления паров воды осуществляли с помощью датчика влажности HIH-4000 (Honeywell, CША). Интервал температур составлял 100–1000 °С, скорость нагрева-охлаждения – 3–5 °С/мин.

2.8 Исследование локальной структуры и форм кислородноводородных групп

Изучение локальной структуры предварительно обработанных (гидратированных или осушенных) образцов проводили с помощью спектроскопии комбинационного рассеивания на спектрометре Alpha 300 AR (WiTec, Германия) Условия съемки: синий лазер, λ=488 нм, спектральный диапазон 10–2000 см⁻¹), 10кратное увеличение, выдержка 5 секунд. Исследование выполнено с использованием оборудования УЦКП «Современные нанотехнологии» ИЕНиМ УрФУ.

Идентификацию кислородно-водородных групп проводили с помощью инфракрасной спектроскопии на спектроскопе Nicolet 6700 (Thermo Fisher Scientific, США) с приставкой Smart Diffuse Reflectance. Условия съемки: метод диффузного отражения в диапазонах частот 50–600 см⁻¹ и 400–4000 см⁻¹.

2.9 Исследование электрических свойств

Исследование электрических свойств образцов проводили в двухконтактной ячейке, принципиальная схема которой приведена на рисунке 2.3. Измерение сопротивления осуществляли методом импедансной спектроскопии Elins Z-1000P (ООО «Элинс», Россия) в частотном диапазоне 1–10⁶ Гц.



Рисунок 2.3 – Фрагмент установки по изучению электрических свойств образцов.

где 1 – кварцевая трубка; 2 – алундовая ячейка; 3 – платиновые токоподводы; 4 – термопара; 5 – платиновые электроды; 6 – образец. Стрелками указано направление потока газа, с помощью которого задается влажность атмосферы

Метод электрохимического импеданса основан на измерении полного сопротивления цепи на переменном токе в широком диапазоне частот. Величина тока, проходящего через сопротивление *R* при приложении поля *U*, определяется законом Ома

$$I = U/R \tag{2.18}$$

и не зависит от частоты поля. Конденсатор блокирует прохождение постоянного тока; проходящий через него переменный ток описывается выражением:

$$I = i\omega CU, \tag{2.19}$$

где ω – угловая частота, *i* – мнимая единица *C* – емкость. Эти соотношения для *R* и *C* можно записать в виде:

$$I = U/Z^*(\omega), \tag{2.20}$$

где $Z^*(\omega)$ – полное сопротивление (импеданс) цепи, которое включает в себя действительную и мнимую части:

$$Z^*(\omega) = Z' - iZ''.$$
 (2.21)

В настоящей работе величину сопротивления образцов рассчитывали при обработке спектров импеданса методом эквивалентных схем с использованием программы ZView 2 (Version 2.6b, Scribner Associates, Inc.) в предположении «блочно-слоевой» модели образца. Данная модель широко используется для интерпретации данных, получаемых при исследовании поликристаллических материалов [96, 97]. Образец упрощенно рассматривается как совокупность равномерно расположенных кристаллитов кубической формы, одинаковых по полностью разделенных однородной размеру и межзеренной фазой. Подразумевается, что электрические характеристики границ зерен существенно свойств объема Выбор эквивалентной отличаются ОТ зерна. схемы обуславливался общим видом годографа импеданса.

Для поликристаллического образца со смешанной ионно-электронной проводимостью мнимую и действительную части импеданса представляют [98]:

$$Z' = \frac{R_{o5}}{\left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_{o5}}\right)^{2}\right]} + \frac{R_{r_{3}}}{\left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_{r_{3}}}\right)^{2}\right]} + \frac{R_{s_{31}}}{\left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_{s_{31}}}\right)^{2}\right]}$$
(2.22)

$$Z'' = \frac{R_{o6}\left(\frac{\omega}{\omega_{o6}}\right)}{\left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_{o6}}\right)^{2}\right]} + \frac{R_{r_{3}}\left(\frac{\omega}{\omega_{r_{3}}}\right)}{\left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_{r_{3}}}\right)^{2}\right]} + \frac{R_{sn}\left(\frac{\omega}{\omega_{sn}}\right)}{\left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_{sn}}\right)^{2}\right]}$$
(2.23)

В идеальном случае (см. рисунок 2.4а) годограф будет иметь вид неперекрывающихся между собой полуокружностей (либо наблюдается их частичное перекрытие). Высокочастотный вклад соответствует объемным свойствам образца (об), среднечастотный вклад относится к свойствам границ зерен (гз), низкочастотный – к электродным процессам или процессам, происходящим на границе раздела материал/электрод (эл). Каждый вклад на эквивалентной схеме (см. рисунок 2.4б) рассматривается как параллельно соединенные сопротивление и емкость.



(а) (б) Рисунок 2.4 – Модельный вид годографа (а) и эквивалентная схема для определения величины *R* образцов в соответствии с видом годографа (б)

При исследовании свойств реальных объектов вид годографа может меняться: фрагменты полуокружностей могут отсутствовать (см. рисунки 2.5а и 2.5в), сильно перекрываться и т.д. В этом случае используемые при обработке данных эквивалентные схемы меняются. Если центры наблюдаемых полуокружностей лежат ниже оси абсцисс, в указанные эквивалентные схемы, вместо емкости, вводят элемент постоянной фазы (*Q*), который выступает как мнимая емкость.



(в) (г) Рисунок 2.5 – Модельный вид годографов (а, в) и эквивалентные схемы для определения величины *R* образцов в соответствии с видом годографа (а, в)

Расчет удельной электропроводности осуществляли в соответствии с формулой:

$$\sigma_{\text{общ}} = \frac{1}{R} \cdot \frac{h}{S}, \qquad (2.24)$$

В логарифмическом виде:

$$\lg \sigma_{\rm obm} = \lg \left(\frac{h}{S}\right) - \lg R, \qquad (2.25)$$

где $\sigma_{\text{общ}}$ – общая удельная электропроводность, Ом⁻¹см⁻¹; *h* – высота образца, см; *S* – площадь поверхности образца, см²; *R* – сопротивление образца, Ом. Для расчета общей электропроводности учитывали влияние пористости керамики по формуле, предложенной в работе [99]:

$$\sigma = \sigma_{\text{ofm}} \frac{2}{\left[3\left(1 - \frac{\Pi_{\text{ofm}}}{100}\right) - 1\right]},$$
(2.26)

Исследования электрических свойств выполняли при варьировании следующих термодинамических параметров: температуры, парциального давления паров воды и кислорода. Установление температуры печи происходило с помощью терморегулятора ТП403 (Варта, Россия) с погрешностью измерений ±2 °C. Контроль температуры вблизи образца производили с помощью «ПП» измерителя-регулятора 2TPM1 (OBEH, Россия). термопары И Температурный интервал в исследуемых условиях составлял 200-950 °С. Установление влажности атмосферы добивались пропусканием воздуха через пентаоксид фосфора (сухая атмосфера, $pH_2O=3\cdot 10^{-5}$ атм.) или насыщенный раствор бромида калия (влажная атмосфера, *p*H₂O=2·10⁻² атм.). Для получения изотерм общей электропроводности в зависимости от парциального давления паров воды использовали потоки сухого и влажного газов, смешиваемые с помощью системы ротаметров PMR-011403 (AALBORG, CША). Значение pH_2O определяли с помощью датчика влажности HIH-4000 (Honeywell, США). Интервал парциального давления паров воды в исследуемых условиях составлял 3·10⁻⁵-2·10⁻² атм. Процессы карбонизации керамики предотвращали очисткой воздуха от углекислого газа в сухой и влажной атмосфере посредством пропускания через реактив «Аскарит», содержащий сухую щелочь, и 30%-й раствор гидроксида натрия, соответственно.

Задание парциального давления кислорода осуществляли с помощью выносных кислородного насоса и датчика, изготовленных на основе стабилизированного иттрием оксида циркония (IV). Интервал парциального давления кислорода в исследуемых условиях составлял 10^{-15} –0.21 атм. Контроль значений pO_2 в измерительной установке осуществляли регулятором Zirconia-M (ООО «Исследовательские технологии», Россия).

2.10 Измерение чисел переноса

Ионные числа переноса определяли методом ЭДС [100–105]. В ходе данного метода проводится измерение ЭДС гальванической ячейки:

$$p'O_2, p'H_2O(Pt)$$
 | твердый электролит | (Pt) $p"O_2, p"H_2O$ (2.27)

в качестве твердого электролита используется брикет исследуемого образца.

ЭДС гальванической цепи при возникновении градиента парциального давления кислорода и паров воды определяется формулой Нернста в следующем виде:

$$E = \frac{RT}{4F} t_{\text{HOH}} \ln \frac{p'O_2}{p''O_2} - \frac{RT}{2F} t_{\text{H}} \ln \frac{p'H_2O}{p''H_2O}$$
(2.28)

В случае электронно-ионной проводимости электролита ЭДС концентрационной ячейки в отсутствии градиента *p*H₂O уравнение 3.15 принимает вид:

$$E = \frac{RT}{4F} t_{\text{\tiny HOH}} \ln \frac{p'O_2}{p''O_2}$$
(2.29)

где E – измеренная ЭДС ячейки при заданном градиенте парциальных давлений кислорода; $t_{ион}$ – среднее значение суммы ионных чисел переноса; R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); T – рабочая температура, К; F – постоянная Фарадея, Кл; $p'O_2$, $p''O_2$ – парциальные давления кислорода в различных газовых пространствах ячейки, атм.

Теоретическое значение ЭДС в градиенте парциального давления кислорода рассчитывается по уравнению:

$$\left(E_{\rm reop}\right)^{p'O_2/p''O_2} = \frac{RT}{4F} \ln \frac{p'O_2}{p''O_2}$$
(2.30)

Среднее значение суммы ионных чисел переноса можно рассчитать по уравнению:

$$t_{_{\rm HOH}} = \frac{\left(E_{_{\rm Teop}}\right)^{p'O_2/p''O_2}}{E}$$
(2.31)

Суммарное число переноса ионов для соионных кислороднопротонных проводников:

$$t_{\rm HOH} = t_{\rm O2-} + t_{\rm H} \tag{2.32}$$

В случае электронно-ионной проводимости электролита ЭДС концентрационной ячейки в отсутствии градиента *p*O₂ уравнение 3.15 принимает вид:

$$E = -\frac{RT}{2F} t_{\rm H} \ln \frac{p' {\rm H}_2 {\rm O}}{p'' {\rm H}_2 {\rm O}}$$
(2.33)

где *p*'H₂O, *p*"H₂O – парциальные давления паров воды в различных газовых пространствах ячейки, атм.

Теоретическое значение ЭДС в градиенте парциального давления паров воды рассчитывается по уравнению:

$$\left(E_{\text{reop}}\right)^{p'H_2O/p''H_2O} = -\frac{RT}{2F}\ln\frac{p'H_2O}{p''H_2O}$$
(2.34)

Кажущееся протонное число переноса, включающее в себя перенос различных форм протон-содержащих частиц, рассчитывается по уравнению:

$$t_{\rm H} = \frac{\left(E_{\rm reop}\right)^{p'{\rm H}_2{\rm O}/p''{\rm H}_2{\rm O}}}{E}$$
(2.35)

Градиент парциального давления кислорода при проведении измерений задавали с помощью подачи на разные стороны образца чистого кислорода из баллона ($p'O_2=1$ атм.) и атмосферного воздуха, предварительно очищенного от углекислого газа ($p'O_2=0.21$ атм.). Градиент парциального давления паров воды задавали с помощью подачи на разные стороны образца влажного воздуха, пропущенного через насыщенный раствор KBr ($p'H_2O=1.94\cdot10^{-2}$ атм.) и насыщенный раствор LiCl ($p''H_2O=3.46\cdot10^{-3}$ атм.). Скорость подачи была постоянной, составляла 0.5 л/мин. Сепарацию электродных пространств обеспечивали тщательной пришлифовкой, механическим прижатием к алундовой трубе и приклейкой керамического образца с помощью пасты из смеси оксида алюминия и силикатного клея.

ГЛАВА 3. СИСТЕМА Ba₂In₂O₅-Ba₂InNbO₆

В данной главе представлены исследования композиционных образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 \cdot xBa_2InNbO_6$ с содержанием гетерогенного допанта x=0.01-0.90, полученных различными методами и с различной температурой обработки керамики. Поскольку характер фазовых равновесий в квазибинарной системе $Ba_2In_2O_5$ - Ba_2InNbO_6 является эвтектическим, то температура обработки образцов выбиралась, исходя из данных, представленных в разделе 3.2, а именно, при температурах ниже (1300 °C) и выше температуры эвтектики (1400 °C). Также подробно изучены транспортные свойства композиционных образцов с оптимальными электрическими характеристиками (x=0.20-0.30). Установлены факторы, обуславливающие возникновение композиционного эффекта.

3.1 Фазовый состав

3.1.1 Рентгенофазовый анализ Ва₂In₂O₅ и Ва₂InNbO₆

Методом порошковой рентгеновской дифракции получены рентгенограммы индивидуальных фаз Ba₂In₂O₅ и Ba₂InNbO₆. Установлено, что образцы являются однофазными. Бесструктурным методом Ле Бейла проведено уточнение параметров элементарной ячейки (см. рисунки 3.1 и 3.2). Структура ромбической $Ba_2In_2O_5$ симметрией (пр. Ibm2), описывается гр. параметры элементарной ячейки: *a*=6.079(5) Å, *b*=16.744(6) Å, *c*=5.950(2) Å, что хорошо согласуется с литературными данными [3].



Рисунок 3.1 – Рентгенограмма Ba₂In₂O₅, обработанная с использованием бесструктурной модели

Фаза Ba₂InNbO₆ характеризуется кубической симметрией с пр. гр. *Рm3m* (см. рисунок 3.2). Уточненные параметры элементарной ячейки для образцов Ba₂InNbO₆, полученных твердофазным и растворным методами, несколько разнятся, и составляют a=4.139(5) Å и a=4.146(1) Å, соответственно. Значения принципиально согласуются с литературными [12, 13].



Рисунок 3.2 – Рентгенограммы Ba₂InNbO₆, полученного по твердофазной (а) и растворной (б) технологиям, с обработкой по бесструктурной модели

Для полученного растворным методом перовскита Ba₂InNbO₆ на рентгенограмме наблюдается уширение пиков, что может быть объяснено увеличением дисперсности порошка по сравнению с образцом, полученным твердофазным методом.

3.1.2 Рентгенофазовый анализ образцов (1-x)Ва₂In₂O₅·xBa₂InNbO₆

На рисунках 3.3 и 3.4 приведены примеры обработки рентгенограмм для образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 \cdot xBa_2InNbO_6$ с $x \le 0.05$ после термообработки на 1300 °C. Образцы могут быть описаны как однофазные, изоструктурные Ba_2In_2O_5, описываются ромбической сингонией (пр.гр. *Ibm*2); уточненные параметры для состава с x=0.05 составляют: a=6.025(5) Å, b=16.860(7) Å, c=5.960(2) Å. Поскольку параметры решетки изменяются в сравнении с данными для Ba_2In_2O_5, то в указанной узкой области составов нельзя исключать формирование твердых растворов с общей формулой Ba_2In_2-yNb_yO_5+y.



Рисунок 3.3 – Рентгенограммы образцов (1–*x*)Ва₂In₂O₅·*x*Ba₂InNbO₆ (*x*≤0.05) в сравнении с данными для Ba₂In₂O₅ и Ba₂InNbO₆.



Рисунок 3.4 – Пример обработки рентгенограмм для образцов *x*=0.02 (а) и *x*=0.05 (а) с температурой обработки 1300 °C.

В таблице 3.1 приведены параметры элементарных ячеек для указанных образцов.

Для образцов с $x \le 0.05$ при увеличении содержания ниобия соотношение *с/а* становится более близким к единице по сравнению с индатом бария Ba₂In₂O₅, то есть наблюдается уменьшение ромбических искажений. Поскольку кристаллические радиусы ионов в октаэдрическом окружении составляют: $r(In^{3+})=9.4$ Å, $r(Nb^{5+})=7.8$ Å [106], то введение иона меньшего радиуса объясняет некоторое снижение объема элементарной ячейки. Таблица 3.1 – Параметры элементарных ячеек для образцов (1-x)Ba₂In₂O₅·xBa₂InNbO₆ с температурой обработки 1300 °C

Ofnorov	Приме-	$- Ba_2 In_{2-x} Nb_x O_{5+x}$					
Ооразец	чание	пр.гр.	<i>a</i> , Å	<i>b,</i> Å	<i>c,</i> Å	c/a	<i>V</i> , Å ³
x=0.00 y=0.00	1300 °C	74 Ibm2	6.079(5)	16.744(6)	5.950(2)	0.978(7)	605.723(2)
x=0.02 y=0.02	1300 °C	74 Ibm2	6.040(5)	16.835(7)	5.955(3)	0.985(9)	605.630(5)
x=0.05 y=0.05	1300 °C	74 Ibm2	6.025(5)	16.860(7)	5.960(2)	0.989(2)	605.521(4)
Ofnonou	Приме-	$Ba_2In_{2-x}Nb_xO_{5+x}$				Ba ₂ InNbO ₆	
Ооразец	чание	пр.гр.	<i>a,</i> Å	<i>b,</i> Å	<i>c,</i> Å	пр.гр.	<i>a,</i> Å
x=0.07 z=0.02	1300 °C	74 Ibm2	6.025(5)	16.862(2)	5.959(8)	225 Pm3m	4.145(4)
x=0.08 z=0.03	1300 °C	74 Ibm2	6.025(9)	16.859(3)	5.960(2)	225 Pm3m	4.145(4)
x=0.20 z=0.15	1300 °C	74 Ibm2	6.026(1)	16.859(5)	5.958(5)	225 Pm3m	4.145(4)
x=0.30 z=0.25	1300 °C	74 Ibm2	6.025(7)	16.859(6)	5.960(1)	225 Pm3m	4.145(4)
x=1.00 z=1.00	[12]	_	_	_	_	225 Pm3m	4.145(4)

Таким образом, при гетеровалентном (гомогенном) допировании ионом большего заряда Nb⁵⁺ происходит уменьшение количества структурных вакансий кислорода, но тип симметрии не меняется, при этом ромбические искажения уменьшаются.

Рентгенограммы композиционных образцов (1–*x*)Ba₂In₂O₅·*x*Ba₂InNbO₆ (*x*=0.07–0.90), приготовленных методом *in situ* с температурой обработки 1300 °C (ниже температуры эвтектики), приведены в сравнении с рентгенограммами

Ва₂In₂O₅ и Ва₂InNbO₆ на рисунке 3.5. Полученные образцы двухфазные, содержат основную фазу, изоструктурную индату бария Ba₂In₂O₅ и фазу добавки Ba₂InNbO₆, количество которой закономерно возрастает с увеличением *x*. Состав композиционных образцов (1-z)Ba₂In_{1.95}Nb_{0.05}O_{5.05}·*z*Ba₂InNbO₆. Установлено, что структура основной фазы ромбическая (пр. гр. *Ibm*2), соответствует низкотемпературной модификации Ba₂In₂O₅ с упорядоченным состоянием кислородных вакансий [3]. Параметры элементарной ячейки основной фазы соответствуют литературным [3] для индата бария и параметрам твердого раствора с *x*=0.05. Фаза Ba₂InNbO₆ описывается кубической симметрией со структурой одинарного перовскита (пр.гр. *Pm3m*). Уточненные параметры элементарной ячейки также согласуются с литературными данными [107, 108].

В таблице 3.1 приведены параметры элементарных ячеек для фаз, входящих в композиционные образцы (1-*x*)Ва₂In₂O₅·*x*Ba₂InNbO₆.



Рисунок 3.5 – Рентгенограммы образцов (1−*x*)Ва₂In₂O₅·*x*Ba₂InNbO₆ с обработкой 1300 °С в сравнении с данными для Ba₂In₂O₅ и Ba₂InNbO₆.



обработки 1300 °С

Для образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 \cdot xBa_2InNbO_6$ проведены аналогичные исследования с температурой обработки 1400 °С (выше эвтектической температуры). В таблице 3.2 приведены параметры элементарных ячеек для фаз, входящих в композиционные образцы $(1-x)Ba_2In_2O_5 \cdot xBa_2InNbO_6$ с температурой обработки 1400 °С.

Для образцов x<0.20 принципиального отличия в результатах рентгеновских данных по сравнению с термообработкой на 1300 °С не было. Для образцов с x=0.20, 0.30 с обработкой выше температуры эвтектики при $t_{ofp}=1400$ °С установлено, что структура основной фазы становится тетрагональной (пр.гр. *14cm*), соответствует высокотемпературной модификации Ba₂In₂O₅ с разупорядоченным состоянием кислородных вакансий [3]. Параметры основной фазы (таблица 3.2) хорошо соотносятся между собой для различных составов, но несколько ниже по сравнению с литературными данными для тетрагональной модификации Ba₂In₂O₅ [3]. Этот факт, с одной стороны, может отражать возможность того, что небольшое количество меньшего по размеру иона ниобия Nb⁵⁺ входит в позиции In³⁺, о чем мы говорили ранее. С другой стороны, литературные данные для тетрагональной модификации Ba₂In₂O₅ получены при температуре выше 925 °С, что предполагает термическое расширение ячейки, а в нашем случае стабилизация тетрагональной модификации происходит при комнатной температуре. Фаза Ba₂InNbO₆ в составе композитов описывается кубической симметрией со структурой одинарного перовскита (пр.гр. *Pm3m*). Уточненные параметры элементарной ячейки составляют: a=4.145(4) Å, что согласуется с литературой [107, 108]. На рисунке 3.7 представлены примеры обработки рентгенограмм для композиционных образцов $0.7Ba_2In_2O_5 \cdot 0.3Ba_2InNbO_6$ (см. рисунок 3.7) с различной температурой обработки: ниже (1300 °C) и выше (1400 °C) эвтектической температуры.



Рисунок обработки 3.7 Пример рентгенограмм образцов для 0.7Ва₂In₂O₅·0.3Ва₂InNbO₆ с температурой обработки 1300 °С (а) и 1400 °С (б) Таблица 3.2 Параметры элементарных образцов ячеек ДЛЯ (1-x)Ва₂In₂O₅·xBa₂InNbO₆ с температурой обработки 1400 °С

Ofnora	Приме-		Ba ₂ In	Ba ₂ InNbO ₆			
Ооразец	чание	пр.гр.	<i>a</i> , Å	<i>b</i> , Å	<i>c</i> , Å	пр.гр.	<i>a</i> , Å
<i>x</i> =0.07	1400.00	11 2	(025(2)	1(0(2(7)	5.0(0(1)		A 1 4 5 (A)
<i>z</i> =0.02	1400 °C	Ibm2	6.025(3)	16.862(7)	5.960(1)	Pm3m	4.145(4)
x=0.20	1400 °C	TA	5.040(0)	5.040(0)	1(000(5)	רת	4 1 4 5 (4)
<i>z</i> =0.15		$^{\circ}\text{C}$ [4 <i>cm</i>] 5.949(9)] 5.949(9)	10.899(3)	Pm3m	4.143(4)		
x=0.30	1400 °C	TA	5.047(2)	5.047(2)	1(001(7)	D 2	4 1 4 5 (4)
<i>z</i> =0.25		<i>14cm</i>	5.947(3)	5.947(3)	16.901(7)	Pm3m	4.145(4)
x=1.00	[10]					D	1 1 4 5 (4)
z=1.00		_	_	_	_	rmsm	4.143(4)

3.2 Определение эвтектического состава

Определение эвтектического состава в квазибинарной системе $Ba_2In_2O_5$ - Ba_2InNbO_6 проводили с помощью построения треугольника Таммана [91]. Для этого были получены кривые охлаждения композиционных образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 x Ba_2InNbO_6$, где x=0.20, 0.30, 0.40, 0.50 (см. рисунок 3.8а). Отметим, что в силу технических ограничений нагрев образцов проводили выше температуры эвтектики, но не выше температуры плавления системы. На всех кривых охлаждения наблюдаются плато при температуре 1355 °C, что соответствует температуре эвтектики. Длина плато для всех образцов отличается и пропорциональна количеству кристаллизующейся эвтектики. При наложении отрезков, пропорциональных длине плато, вниз от изотермической линии эвтектики был сформирован треугольник Таммана, через точку вершины которого был определен эвтектический состав (см. рисунок 3.8б).



Рисунок 3.8 -Кривые охлаждения образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6$ (a) и через определение эвтектического состава построение треугольника Таммана (б) квазибинарной эвтектической системы Ba₂In₂O₅-Ba₂InNbO₆ При построении треугольника Таммана была учтена возможность образования растворов В узкой области составов. Эвтектический твердых состав соответствует следующему соотношению компонентов: исходных

75.6 мас.% Ва₂In₂O₅·24.4 мас.% Ва₂InNbO₆ или 75.4 мол.% Ва₂In₂O₅·24.6 мол.% Ва₂InNbO₆. Также для состава 0.7Ba₂In₂O₅·0.3Ba₂InNbO₆ в ходе работы была определена температура полного плавления системы, которая составила 1410 °C. На основании литературных данных по температурам плавления индивидуальных фаз [76, 110] и полученных в этой работе данных был построен фрагмент диаграммы состояния квазибинарной системы Ba₂In₂O₅-Ba₂InNbO₆, представленный на рисунке 3.9.



Рисунок 3.9 – Фрагмент диаграммы состояния квазибинарной эвтектической системы Ba₂In₂O₅–Ba₂InNbO₆

3.3 Морфология и микроструктура

3.3.1 Сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионный рентгеновский анализ Ba₂In₂O₅ и Ba₂InNbO₆

Морфология порошков изучена методом сканирующей электронной микроскопии. На рисунках 3.10 и 3.11 представлены СЭМ-изображения порошков индата бария $Ba_2In_2O_5$, полученного твердофазным методом, и Ba_2InNbO_6 , полученного твердофазным и растворным методами. Частицы порошка индата бария $Ba_2In_2O_5$ агрегированы, зерна имеют округлую форму, диаметр составляет порядка 3–5 мкм (см. рисунок 3.10).



Рисунок 3.10 – СЭМ-изображение керамики на основе индата бария Ba₂In₂O₅, полученного твердофазным методом

Ba₂InNbO₆, синтезированный твердофазным Порошок методом, полидисперсный, зерна имеют неправильную форму размером от 2 до 10 мкм рисунок 3.11a). Для порошка, полученного растворным методом, (см. наблюдается увеличение дисперсности (см. рисунок 3.11б). Частицы более однородны по размеру, размер составляет порядка 200 нм, наблюдается их агломерация. Элементный состав для Ba₂InNbO₆, полученного твердофазным методом, соответствует следующему соотношению металлов: Ba:In:Nb=0.479:0.223:0.298. Это соответствует стехиометрическому содержанию элементов Ba:In:Nb=2:1:1, однако содержание индия несколько снижено.



Рисунок 3.11 – СЭМ-изображения порошка Ba₂InNbO₆, полученного твердофазным (а) и растворным (б) методами

3.3.2 Сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионный рентгеновский анализ образцов (1-*x*)Ва₂In₂O₅·*x*Ba₂InNbO₆

Керамический образец $Ba_2In_{1.95}Nb_{0.05}O_{5.05}$ $t_{obp}=1400$ °C характеризуется незначительной пористостью (см. рисунок 3.12а). Образец однофазен, представлен хорошо спеченными однотипными округлыми зернами (размером ~10–15 мкм) с характерной террасоподобной структурой (см. рисунок 3.12б).



Рисунок 3.12 – СЭМ-изображения керамики на основе Ba₂In_{1.95}Nb_{0.05}O_{5.05} с температурой обработки 1400 °C

Композиционные образцы, полученные методом in situ

керамического образца $0.93Ba_2In_2O_5 \cdot 0.07Ba_2InNbO_6$ (x=0.07) с Для *t*_{обр}=1300 °С наблюдаются крупные зерна с характерной морфологией основной фазы Ba₂In_{1.95}Nb_{0.05}O_{5.05}, на их поверхности находятся значительно меньшие по размеру кристаллиты фазы добавки Ba₂InNbO₆ с размером частиц 1-2 мкм (см. рисунок 3.13). Для образца x=0.07 обработка при 1400 °С приводит к существенному изменению микроструктуры (см. рисунок 3.14). Поверхность зерен при рассмотрении изображения общего плана становится более гладкой (см. рисунок 3.14а). На поверхности матричной фазы наблюдается слой из появившихся вследствие кристаллитов, кристаллизации расплава эвтектического состава (см. рисунок 3.14б), при этом отдельные зерна гетерогенного допанта отсутствуют.


Рисунок 3.13 – СЭМ-изображения скола керамического образца $0.93Ba_2In_2O_5$ · $0.07Ba_2InNbO_6$ *in situ*, обработанного при температуре 1300 °C



Рисунок 3.14 – СЭМ-изображения скола керамического образца $0.93Ba_2In_2O_5 \cdot 0.07Ba_2InNbO_6$ *in situ*, обработанного при температуре 1400 °C

На рисунке 3.15 представлено СЭМ-изображение *порошка* 0.8Ва₂In₂O₅·0.2Ва₂InNbO₆ после обработки при 1300 °С. Образец характеризуется неоднородной морфологией, содержит округлые зерна основной фазы, близкой по составу к Ba₂In₂O₅, и меньшие по размеру зерна неправильной формы, относящиеся к фазе Ba₂InNbO₆. Элементный состав был подтвержден энергодисперсионным рентгеновским анализом (см. рисунок 3.16). Первый

73

спектр близок к составу граничного твердого раствора $Ba_2In_{1.95}Nb_{0.05}O_{5.05}$, то есть небольшое содержание ниобия в зернах основной фазы фиксируется. Второй спектр в большей степени отвечает составу фазы Ba_2InNbO_6 . На рисунке 3.17 приведено СЭМ-изображение скола керамики $0.8Ba_2In_2O_5 \cdot 0.2Ba_2InNbO_6$ после обработки при 1300 °C. Образец характеризуется неоднородной морфологией, содержит крупные спеченные зерна основной фазы, а также неоднородные агломерированные включения (выделены на рисунке 3.17 стрелками) и меньшие по размеру зерна неправильной формы, относящиеся к фазе добавки Ba_2InNbO_6 .



(a) (б) Рисунок 3.15 – СЭМ-изображение порошка 0.8Ва₂In₂O₅·0.2Ва₂InNbO₆ *in situ* после обработки при 1300 °C



рентгенографического анализа (б).



Рисунок 3.17 – СЭМ-изображение скола керамики $0.8Ba_2In_2O_5 \cdot 0.2Ba_2InNbO_6$ *in situ* после обработки при 1300 °C

Для образца 0.8Ba₂In₂O₅·0.2Ba₂InNbO₆, полученного *in situ*, обработка (1400 °C) эвтектической температуры приводит выше К изменению микроструктуры (см. рисунок 3.18). На СЭМ-изображениях визуально можно идентифицировать зерна, относящиеся к основной фазе, включения фазы добавки в явном виде не наблюдаются. Однако в области, где видна поверхность зерен, можно отметить особое покрытие ИЗ мелких кристаллитов (см. рисунок 3.18б в), формирование, обусловлено И его вероятно, эвтектическим плавлением и последующей кристаллизацией.



(а)
 (б)
 (в)
 Рисунок 3.18 – СЭМ-изображения скола керамического образца с *x*=0.20 (а и б)
 и *x*=0.30 (в) *in situ*, обработанных при температуре 1400 °С

Композиционный образец с 20 мол.% Ва₂InNbO₆ получали методом механического смешения из исходных фаз Ba₂In₂O₅ и Ba₂InNbO₆. Для этого твердофазным методом был синтезирован Ba₂In₂O₅, a Ba₂InNbO₆ получен твердофазным и растворным методами. Керамику подвергали температурной обработке при 1400 °C, выше температуры эвтектики. Обозначение образца, где обе исходные фазы получены твердофазным методом $0.8Ba_2In_2O_5$ $\cdot 0.2Ba_2InNbO_6$ (тт); образца, где Ba_2InNbO_6 получен по растворной технологии – 0.8Ba₂In₂O₅·0.2Ba₂InNbO₆ (тр). СЭМ-изображения керамики на основе композиционных образов $0.8Ba_2In_2O_5 \cdot 0.2Ba_2InNbO_6$ (TT), 0.8Ва₂In₂O₅·0.2Ва₂InNbO₆ (тр) представлены на рисунках 3.19–3.20. Для образца 0.8Ba₂In₂O₅·0.2Ba₂InNbO₆, где обе фазы получены твердофазным методом (см. рисунок 3.19), наблюдаются значительная неоднородность в распределении Ba₂In₂O₅ и Ba₂InNbO₆. Зерна с бо́льшим размером, более округлой и гладкой формы относящиеся к фазе $Ba_2In_2O_5$ (либо твердому раствору на ее основе), на которых находятся частицы с разнородной поверхностью, принадлежащие фазе Ba₂InNbO₆. В местах со значительной агломерацией фазы Ba₂InNbO₆ наблюдаются отдельные участки подплавления.



Рисунок 3.19 – СЭМ-изображения скола керамики $0.8Ba_2In_2O_5 \cdot 0.2Ba_2InNbO_6$ (тт), обработанной на 1400 °С

Для керамического образца 0.8Ba₂In₂O₅·0.2Ba₂InNbO₆ (тр) (см. рисунок 3.20) наблюдается значимое уменьшение пористости по сравнению с образцом 0.8Ba₂In₂O₅·0.2Ba₂InNbO₆ (тт). Основная фаза представлена

достаточно большими округлыми зернами (~20–30 мкм) с террасоподобной структурой. Фаза добавки Ba₂InNbO₆ сосредоточена на поверхности крупных зерен: можно видеть мелкие кристаллиты размером 20–50 нм, вероятно, сформировавшиеся в ходе кристаллизации эвтектики.



 Рисунок
 3.20
 СЭМ-изображения
 скола
 керамики

 0.8Ba₂In₂O₅·0.2Ba₂InNbO₆ (тр), обработанной на 1400 °C
 С
 С
 С

3.4 Термические свойства и масс-спектрометрия

Методом термогравиметрического анализа в режиме нагрева в атмосфере сухого азота были получены ТГ-кривые для предварительно выдержанных во влажной атмосфере образцов (то есть, предварительно гидратированных).

Отметим, индат бария $Ba_2In_2O_5$ характеризуется что структурно некомплектной кислородной подрешеткой. Количество структурных кислородных вакансий составляет 16.7% от общего числа анионных позиций или моль на формульную единицу. Максимально возможное количество 1 внедряющейся воды, соответствующее числу незанятых кислородных позиций, также составляет 1 моль на формульную единицу [14]. Если мы примем во

внимание возможность частичного замещения позиций In³⁺ на Nb⁵⁺, то для предполагаемого предельного состава твердого раствора Ba₂In_{1.95}Nb_{0.05}O_{5.05} количество внедряющейся воды незначительно снизится и составит 0.95 моль, что подтверждается экспериментальными данными (см. рисунок 3.21а). Далее в рассуждениях для простоты будем обозначать матричную фазу как Ba₂In₂O₅, а не как твердый раствор предельного состава Ba₂In_{1.95}Nb_{0.05}O_{5.05}. Для номинально комплектной по кислородной подсистеме фазы Ba₂InNbO₆ количество внедряющейся воды незначительно и не превышает 0.02 моль на формульную единицу сложного оксида. То есть, можно ожидать, что количество внедряющейся воды в композиционные образцы будет пропорционально содержанию основной фазы.

Для состава $0.8Ba_2In_2O_5 \cdot 0.2Ba_2InNbO_6$, полученного разными способами, *in situ* и методом смешения, в котором использовали добавку Ba_2InNbO_6 , синтезированную различными методами (твердофазным или растворным) на рисунке 3.21a приведены термогравиметрические кривые в сравнении с данными для индата бария $Ba_2In_2O_5$.



Рисунок 3.21 – Результаты термогравиметрического анализа для образцов *x*=0.20 с различными способами приготовления в сравнении с ТГ-кривой для Ba₂In₂O₅ (a) и ДСК-кривая для образца 0.8Ba₂In₂O₅·0.2Ba₂InNbO₆ (тт) (б)

Образец 0.8Ba₂In₂O₅·0.2Ba₂InNbO₆ (тр) исследовали на приборе с возможностью съемки в режиме нагрева и охлаждения (см. главу 2), съемку вели

в атмосфере азота с повышенным парциальным давлением паров воды ($pH_2O=0.02$ атм.) со скоростью 0.5 °С/мин, данные представлены на рисунке 3.22а. Как видно, в режиме нагрева-охлаждения во влажной атмосфере наблюдается уменьшение-увеличение массы образца, соответственно, связанное с обратимостью процесса дегидратации-гидратации. Дегидратация образцов, независимо от способа получения, в режиме нагрева происходит в одном температурном интервале 200–550 °С. Охлаждение образца в сухой атмосфере ($pH_2O=3\cdot10^{-5}$ атм.) закономерно не приводит к существенному изменению массы.



Рисунок 3.22 – ТГ-кривые, полученные в режиме нагрева-охлаждения во влажной атмосфере (1, 2) и охлаждения в сухой атмосфере (3) для полученных методом смешения образцов 0.8Ba₂In₂O₅·0.2Ba₂InNbO₆ (тр) (а) и 0.8Ba₂In₂O₅·0.2Ba₂InNbO₆ (тт) (б)

Полученные данные позволили произвести расчет количества воды, внедряющейся В структуру композиционных образцов $0.8Ba_2In_2O_5$ $\cdot 0.2Ba_2InNbO_6$. учетом С некомплектности ПО кислородной подрешетке индата бария Ba₂In₂O₅, для которого максимальная степень гидратации достигает ~1 моль H₂O на формульную единицу [19], и незначительной степени гидратации для фазы Ba₂InNbO₆; теоретический расчет максимальной степени гидратации композиционных образцов численно соответствует содержанию мольной доли фазы Ba₂In₂O₅, то есть 0.8 моль на формульную единицу состава композита. Общее количество внедряющейся воды, независимо от способа приготовления композита, близко к теоретическому и составляет 0.7–0.8 моль на формульную единицу.

Зависимость степени гидратации от парциального давления паров воды

Для образцов $0.8Ba_2In_2O_5 \cdot 0.2Ba_2InNbO_6$ и $0.7Ba_2In_2O_5 \cdot 0.3Ba_2InNbO_6$, приготовленных методом *in situ*, получены изотермические зависимости массы воды в образцах при стадийном увеличении влажности атмосферы (интервал $pH_2O=3\cdot10^{-5}-0.02$ атм.). На рисунке 3.23 представлен типичный пример исходных данных – релаксационных зависимостей массы образца. Увеличение парциального давления паров воды закономерно приводит к росту количества внедряющейся воды.



Рисунок 3.23 – Типичный пример релаксационной зависимости содержания воды при стадийном изменении pH_2O для образца $0.7Ba_2In_2O_5 \cdot 0.3Ba_2InNbO_6$ при температуре 400 °C. Числа – значения $lgpH_2O$.

Полученные релаксационные зависимости содержания воды в образцах от pH_2O позволили рассчитать значения объемной концентрации протонных дефектов C_{H^+} . На рисунке 3.24 приведены изотермические зависимости объемной концентрации протонных дефектов от парциального давления паров воды. Поскольку внедрение воды обусловлено преимущественно содержанием фазы Ba₂In₂O₅, расчет C_{H^+} проводили с усреднением по его объему в композиционном образце. Данное упрощение позволяет провести анализ

зависимостей и дать оценку подвижностям протонных дефектов (см. пункт 3.5.2). Логарифмические зависимости $\lg C_{H^+} - f(\lg pH_2O)$ носят линейный характер в интервале значений парциального давления паров воды $2.5 \cdot 10^{-3} - 3.2 \cdot 10^{-2}$ атм. Тангенс угла наклона составляет ~1/3.



Рисунок 3.24 – Расчетные значения объемной концентрации протонных дефектов в зависимости от pH_2O для образцов $0.8Ba_2In_2O_5 \cdot 0.2Ba_2InNbO_6$ (a) и $0.7Ba_2In_2O_5 \cdot 0.3Ba_2InNbO_6$ (б)

Возможность внедрения молекул воды в структуру сложных оксидов зависит от некомплектности кислородной подрешетки, соответственно, наличия вакансий кислорода. В литературе для сложных оксидов со структурным разупорядочением вакансии кислорода рассматриваются как нейтральные дефекты. При этом внедрение молекул воды можно описать следующим образом: атом кислорода в молекуле H₂O встраивается на место структурной вакансии кислорода в сложном оксиде, протоны размещаются на регулярных позициях кислорода [111]:

$$\mathbf{V}_{\mathbf{O}}^{\times} + \mathbf{H}_{2}\mathbf{O} + 2\mathbf{O}_{\mathbf{O}}^{\times} \Leftrightarrow \mathbf{O}_{i}^{"} + 2(\mathbf{OH})_{\mathbf{O}}^{\bullet}, \qquad (3.1)$$

где V_{O}^{\times} – структурная вакансия кислорода; O_{O}^{\times} – кислород в регулярной позиции; $O_{i}^{"}$ – кислород, встроившийся в структурную вакансию; $(OH)_{O}^{\bullet}$ – протон, локализованный на ионе кислорода.

следующим тангенсом угла наклона:
$$\frac{\text{dlgC}_{H^+}}{\text{d} \log p H_2 O} \approx 1/3$$

Альтернативное квазихимическое уравнение внедрения молекул воды в фазы со структурными вакансиями кислорода [112]:

$$V_{O}^{\times} + H_{2}O + 2O_{O}^{\times} \Leftrightarrow OH_{O}^{\bullet} + OH_{V_{O}^{\times}}^{\prime}, \qquad (3.2)$$

где рассматривается локализация протона на кислороде, стоящем в регулярной позиции О H $_{\rm O}^{\bullet}$, и на кислороде, пришедшем от молекулы воды и занявшем структурную вакансию $OH'_{V_{\rm O}^{\times}}$ приводит к аналогичной зависимости:

$$\frac{\operatorname{digC}_{\mathrm{H}^+}}{\operatorname{d}\operatorname{lg}\,p\mathrm{H}_2\mathrm{O}}\approx 1/3\,.$$

Таким образом, тангенс угла наклона для полученных в настоящей работе зависимостей объемной концентрации протонных дефектов от *p*H₂O согласуется как с теоретически рассчитанным, так и с экспериментальными данными для других сложных оксидов со структурным разупорядочением [111, 112].

3.5 Электрические свойства

3.5.1 Электрические свойства Ва₂InNbO₆

Для понимания природы проводимости композиционных образцов необходимо детальное изучение природы проводимости обеих индивидуальных фаз, входящих в состав композита. В работе [25] были получены первичные данные по общей электропроводности фазы Ba₂InNbO₆. Поэтому в настоящей работе проведено детальное исследование электрических свойств и определение типа проводимости фазы Ba₂InNbO₆, синтезированной твердофазным методом. Что касается фазы Ba₂In₂O₅, то она достаточно подробно описана в литературе, поэтому измерение ее электрических свойств в настоящей работе проводили с целью подтверждения корреляции с ранее полученными литературными данными.

Зависимость электропроводности от температуры

На рисунке 3.25 представлены спектры импеданса для Ba₂InNbO₆ в атмосферах с различной влажностью. Годограф представляет собой симметричную полуокружность, исходящую из начала координат, отражающую объемные свойства образца. Значение сопротивления преимущественно определено при обработке годографа по эквивалентной схеме, представленной на рисунке 2.56 (см. главу 2). Значения емкостной составляющей, определяемые 10⁻¹¹ Φ, обработке годографов, составляют порядка что отражает при преимущественно объемные свойства образца.



Рисунок 3.25 – Типичный вид годографов импеданса для образца Ba₂InNbO₆ в сухой (закрытые символы) и во влажной (открытые символы) атмосферах при температуре 550 °C

Температурная зависимость общей электропроводности Ba₂InNbO₆ представлена на рисунке 3.26. На зависимостях как в сухой, так и во влажной атмосфере можно выделить два линейных участка с различной энергией 0.80 эΒ высокотемпературной области 0.30 эΒ активации: В И В низкотемпературной. При атмосфере этом BO влажной значения электропроводности выше на половину порядка величины, вследствие взаимодействия структуры сложного оксида с парами воды и, соответственно, появления вклада протонной проводимости.



Рисунок 3.26 – Температурная зависимость электропроводности Ba₂InNbO₆ в сухой (закрытые символы) и во влажной (открытые символы) атмосферах

Зависимость электропроводности от парциального давления кислорода

На рисунке 3.27 представлены изотермические зависимости общей электропроводности от парциального давления кислорода. В сухой атмосфере во всем интервале температур в области высоких pO_2 (>10⁻³ атм) наблюдается положительный тангенс угла наклона, свидетельствует о наличии ЧТО электронного вклада проводимости (р-типа). Во влажной атмосфере снижение температуры приводит к расширению области электролитической проводимости, и при 500 °C общая электропроводность не зависит от pO_2 . При 500 °С электропроводность во влажной атмосфере в электролитической области (область плато) на ~1.5 порядка выше величины по сравнению со значениями в сухой атмосфере, а при $pO_2=0.21$ атм выше на 1/2 порядка величины.



Рисунок 3.27 – Зависимости общей электропроводности Ba₂InNbO₆ от парциального давления кислорода в сухой (закрытые символы) и во влажной (открытые символы) атмосферах

Процессы дефектообразования для перовскитов, содержащих барий, в литературе [113, 114] рассматриваются с точки зрения частичной сублимации оксида бария с образованием вакансий в *А*-подрешетке и в подрешетке кислорода. Однако для сложнооксидных систем необходимо учитывать свойства всех входящих в состав оксидов. Так, например, сублимация оксида индия более значима, она выше по сравнению с оксидом бария и оксидом ниобия [115]. Следовательно, для фазы Ba₂InNbO₆ нестехиометрию, обусловленную недостатком индия, следует рассматривать как наиболее вероятную, это также подтверждается данными микроэлементного анализа (см. раздел 3.3.1). Квазихимическое описание процесса дефектообразования следующее:

$$2Ba_{Ba}^{\times} + In_{In}^{\times} + Nb_{Nb}^{\times} + 6O_{O}^{\times} \Leftrightarrow 0.5x(In_{2}O_{3})\uparrow + +2Ba_{Ba}^{\times} + (1-x)In_{In}^{\times} + xV_{In}^{"} + Nb_{Nb}^{\times} + (6-1.5x)O_{O}^{\times} + 1.5xV_{O}^{\bullet\bullet}$$
(3.3)

Упрощенно:

$$2\mathrm{Ba}_{\mathrm{Ba}}^{\times} + \mathrm{In}_{\mathrm{In}}^{\times} + \mathrm{Nb}_{\mathrm{Nb}}^{\times} + 6\mathrm{O}_{\mathrm{O}}^{\times} \Leftrightarrow 0.5\mathrm{In}_{2}\mathrm{O}_{3} \uparrow + 2\mathrm{Ba}_{\mathrm{Ba}}^{\times} + \mathrm{V}_{\mathrm{In}}^{*} + \mathrm{Nb}_{\mathrm{Nb}}^{\times} + 4.5\mathrm{O}_{\mathrm{O}}^{\times} + 1.5\mathrm{V}_{\mathrm{O}}^{\bullet\bullet} \qquad (3.4)$$

Однако, поскольку структуру перовскита формирует октаэдрический из полиэдров $[BO_6],$ образование вакансий В-подрешетке каркас В термодинамически невыгодно, октаэдр не может оставаться «пустым». Это позволяет предположить, что недостаток индия приводит к перераспределению A-В-подрешеткам образованием бария по И с ионов вакантных кубооктаэдрических позиций: $(Ba_{2-x}[V_{Ba}]_x)^{ky6}(In_{1-x}Ba_xNb)^{okt}O_{6-1.5x}[V_O]_{1.5x})$. В ходе происходит своего акцепторное самодопирование, синтеза рода которое можно представить следующим уравнением:

$$2Ba_{Ba}^{\times} + In_{In}^{\times} + Nb_{Nb}^{\times} + 6O_{O}^{\times} \Leftrightarrow 0.5x(In_{2}O_{3})\uparrow + (2-x)Ba_{Ba}^{\times} + xV_{Ba}^{'} + xBa_{In}^{'} + (1-x)In_{In}^{\times} + Nb_{Nb}^{\times} + (6-1.5x)O_{O}^{\times} + 1.5xV_{O}^{\bullet\bullet}$$
(3.5)

Упрощенно:

$$2Ba_{Ba}^{\times} + In_{In}^{\times} + Nb_{Nb}^{\times} + 6O_{O}^{\times} \Leftrightarrow 0.5In_{2}O_{3} \uparrow + Ba_{Ba}^{\times} + V_{Ba}^{'} + Ba_{In}^{'} + Nb_{Nb}^{\times} + 4.5O_{O}^{\times} + 1.5V_{O}^{\bullet\bullet}$$
(3.6)

Таким образом, именно летучесть оксида индия обуславливает наличие определенного количества вакансий в подрешетках бария и кислорода и создает предпосылки для возникновения кислородно-ионного транспорта в сухой

атмосфере, а во влажной атмосфере – протонного за счет появления протонных дефектов, согласно уравнению 3.1.

 $lg\sigma - f(lg(pO_2))$ Полученные зависимости были использованы для дифференциации общей электропроводности на парциальные вклады. Можно предполагать, что на воздухе фаза Ba₂InNbO₆ является смешанным ионнодырочным проводником ($\sigma_{obm} = \sigma_{uoH} + \sigma_h$). Электролитическая проводимость в сухой атмосфере определяется кислородно-ионным переносом. Соответственно, значения кислородно-ионной проводимости определить можно ИЗ электролитической области в сухой атмосфере (σ_{uoh})^{сух}= σ_{O2} . Увеличение влажности атмосферы приводит к диссоциативному взаимодействию образца с молекулами воды и возникновению протонных дефектов. Появляется вклад протонной проводимости, при этом ионная проводимость определяется суммой кислородно-ионной и протонной проводимостей: $(\sigma_{ион})^{B\pi} = \sigma_{O2} + \sigma_{H}$. В работах [116, 117] рассматривается приближение, в котором допускается отсутствие значимого влияния парциального давления паров воды на кислородно-ионную проводимость. В этом случае оценка значений протонной проводимости приближенно может проводиться как разность значений ионной проводимости во влажной и в сухой атмосферах: $\sigma_{H^+} = (\sigma_{uoh})^{B\pi} + (\sigma_{uoh})^{cyx}$. Данное приближение справедливо исключительно в высокотемпературной области, где количества дефектов незначительны, и их концентрация не протонных оказывает существенного влияния на кислородно-ионную подрешетку и кислородноионную проводимость. Общая электропроводность во влажной атмосфере обусловлена двумя вкладами проводимости: ионной (кислородно-ионной и протонной) и электронной (*p*-типа), выражения парциальных проводимостей:

$$\sigma_{\text{ион}} = (\sigma_{\text{общ}})^{\text{вл}} \cdot t_{\text{ион}}, \qquad (3.7)$$

$$\sigma_{\scriptscriptstyle 3,\Pi} = (\sigma_{\rm obill})^{\scriptscriptstyle B\Pi} \cdot (1 - t_{\scriptscriptstyle HOH}), \qquad (3.8)$$

где $\sigma_{ион}$ и $\sigma_{эл}$ – ионная и электронная проводимости, соответственно; $(\sigma_{oбщ})^{вл}$ – общая электропроводность во влажной атмосфере.

Вклад протонной составляющей проводимости с учетом кажущегося протонного числа переноса рассчитывается по уравнению:

$$\sigma_{\rm H} = (\sigma_{\rm obil})^{\rm BI} \cdot t_{\rm H} \tag{3.9}$$

где σ_H – протонная проводимость.

Вклад кислородно-ионной проводимости рассчитывается с учетом разницы общего ионного и кажущегося протонного чисел переноса по уравнению:

$$\sigma_{O2} = (\sigma_{obil})^{BI} \cdot (t_{uoH} - t_H)$$
(3.10)

где σ_{O2-} – кислородно-ионная проводимость во влажной атмосфере.

На рисунке 3.28 представлены температурные зависимости ионных чисел переноса в сухой и влажной атмосферах. При 500 °C ионная проводимость достигает 50% в сухой атмосфере и 90% во влажной. Ниже 700 °C увеличивается вклад протонной проводимости, при температуре 500 °C протонное число переноса составляет 0.8, протонные дефекты являются доминирующими носителями при этой температуре во влажной атмосфере.



Рисунок 3.28 – Температурные зависимости расчетных ионных чисел переноса для Ba₂InNbO₆ в сухой (закрытые символы) и влажной (открытые символы) атмосферах (а) и температурные зависимости парциальных проводимостей (протонной, кислородно-ионной, электронной (*p*-типа)) в сравнении со значениями общей электропроводности (б)

3.5.2 Электрические свойства Ва₂In₂O₅

На рисунке 3.29 представлены политермы проводимости Ba₂In₂O₅, полученные в сухом и влажном воздухе в сравнении с литературными данными [2, 17, 20]. Как видно, наблюдается хорошая корреляция данных. В области высоких температур для соединения Ba₂In₂O₅ реализуется фазовый переход, сопровождающийся разупорядочением вакансий кислорода, что обуславливает скачкообразное повышение проводимости.



Рисунок 3.29 – Температурные зависимости электропроводности Ba₂In₂O₅ в сухом и влажном воздухе в сравнении с литературными данными [2, 17, 20] (закрытые символы – сухая атмосфера, открытые символы – влажная)

На рисунке 3.30 представлены изотермы проводимости от парциального кислорода в атмосферах различной влажности. давления Как видно, проявляются общие тенденции, характерные для Ba₂In₂O₅ [2, 17, 20]. Так, в сухой атмосфере при температуре ниже 800 °C в области $pO_2 > 10^{-4}$ атм зависимости характеризующий имеют положительный наклон, вклад электронной области $pO_2 < 10^{-4}$ атм наблюдается В область проводимости р-типа. независимости электропроводности от pO_2 , что определяется большим вкладом кислородно-ионной проводимости. При температуре выше 800 °C проводимость не зависит от парциального давления кислорода во всем исследуемом интервале,

что свидетельствует о доминирующем ионном типе проводимости в широком интервале *p*O₂.

Во влажной атмосфере наиболее значимое увеличение проводимости наблюдается в области плато, что объясняется появлением дополнительного типа носителя заряда – протонов.



Рисунок 3.30 – Зависимость общей электропроводности от парциального давления кислорода для фазы Ba₂In₂O₅ в атмосфере сухого (закрытые символы) и влажного (открытые символы) воздуха

Присутствие некоторого вклада дырочных носителей (сухая атмосфера) в области высоких *p*O₂ для перовскитоподобных структур со структурным разупорядочением обычно описывается следующим уравнением:

$$V_{o}^{\times} + \frac{1}{2}O_{2} \Leftrightarrow O_{V_{o}^{\times}}^{"} + 2h^{\bullet}$$
(3.11)

Во влажной атмосфере концентрация дырок уменьшается в результате взаимодействия оксида с молекулами воды по реакции (3.11) и смещения равновесия (3.1) влево. Суммарный процесс при комбинации равновесий (3.11) и (3.1) может быть представлен следующим уравнением:

$$H_2O + 2h^{\bullet} + 2O_O^{\times} \Leftrightarrow \frac{1}{2}O_2 + 2(OH)_O^{\bullet}, \qquad (3.12)$$

Таким образом, в области высоких pO_2 во влажной атмосфере наблюдаются менее значимые эффекты увеличения электропроводности при смене влажности, что обусловлено уменьшением концентрации дырок, одновременно с этим увеличивается концентрация протонов, обладающих меньшей подвижностью. 3.5.3 Электрические свойства образцов (1-x)Ва₂In₂O₅·xBa₂InNbO₆

Зависимость электропроводности от температуры для образцов с $t_{o \delta p} = 1300 \ ^{o}C$

Электрические свойства образцов (1-x)Ва₂In₂O₅·xBa₂InNbO₆ (x=0.02-0.90), полученных методом *in situ* с финальной стадией обработки при 1300 °C, то есть ниже температуры эвтектики системы, изучены методом электрохимического импеданса в сухой и влажной атмосферах. На рисунке 3.31 представлен типичный вид годографов для серии образцов в атмосферах с различной влажностью. Вид годографов представлен фрагментами несимметричных полуокружностей, отражающими суммарное сопротивление объемных свойств и границ зерен образца. Обработку годографов производили по эквивалентной схеме (см. главу 2, рисунок 2.5г).



Рисунок 3.31 – Типичный вид годографов образцов (1–*x*)Ва₂In₂O₅·*x*Ba₂InNbO₆ в сухой (закрытые символы) и во влажной (открытые символы) атмосферах

На рисунке 3.32 представлены температурные зависимости общей электропроводности образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 \cdot xBa_2InNbO_6 t_{obp}=1300$ °C. Для всех образцов введение гетерогенной добавки Ba_2InNbO_6 приводит к снижению температуры структурного перехода Ba_2In_2O_5 [5], то есть, расширяется высокотемпературный интервал существования тетрагональной модификации Ba_2In_2O_5. Температура структурного перехода для всех образцов лежит в интервале 650–850 °C. В исследуемых условиях наблюдается увеличение общей электропроводности для всех образцов по сравнению с исходными Ba_2In_2O_5 и Ba_2InNbO_6 как в сухой (см. рисунок 3.28a), так и во влажной (см. рисунок 3.286) атмосферах. Электропроводность образцов во влажной атмосфере выше, чем в сухой, за счет появления протонного вклада проводимости.



Рисунок 3.32 — Политермы общей электропроводности образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6$ с $t_{obp}=1300$ °C в сухой (а) и влажной (б) атмосферах

На рисунке 3.33 приведены концентрационные зависимости общей электропроводности. Можно предполагать, что в области малых значений

x≤0.05, где предполагается формирование твердых растворов Ba₂In_{2-x}Nb_xO_{5+x}, увеличение электропроводности связано с уменьшением концентрации вакансий кислорода при донорном замещении In³⁺ на Nb⁵⁺, что приводит к частичному разупорядочению вакансий и способствует повышению подвижности ионных носителей, как это описано в работах [2, 12].



Рисунок 3.33 – Концентрационная зависимость электропроводности при 400 °C образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6$ с $t_{obp}=1300$ °C во всей области значений x (а) и в ограниченной области x (б) в сухой (закрытые символы) и влажной (открытые символы) атмосферах при 400 °C

Для двухфазных образцов (1-*x*)Ва₂In₂O₅·*x*Ba₂InNbO₆ (*x*>0.05) с *t*_{обр}=1300 °C в сухой и влажной атмосферах общая электропроводность продолжает немного повышаться для составов 0.05 < x < 0.30, но не столь существенно (до 0.25 - 0.30) порядка величины), а затем, при увеличении содержания низкопроводящей фазы Ba₂InNbO₆ снижается. То есть, при обработке ниже температуры эвтектики электропроводность влияние второй фазы образцов c 0.05<*x*<0.30 на присутствует, эффект повышения проводимости менее НО значителен. Максимальное общее увеличение проводимости (за счет гомогенного И допирования) для образцов, обработанных на 1300 °С, в гетерогенного сравнении с Ba₂In₂O₅ на температуре 400 °C достигает 3/4 порядка величины в сухой и примерно одного порядка величины во влажной атмосфере.

Зависимость электропроводности от температуры образцов с $t_{o o p} = 1400 \ ^{o}C$

Электрические свойства образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 \cdot xBa_2InNbO_6$, для полученных методом *in situ* с финальной стадией обработки при 1400 °C, то есть выше температуры эвтектики, изучены методом электрохимического импеданса в сухой и влажной атмосферах. На рисунке 3.34 представлены годографы для серии образцов в атмосферах с различной влажностью. Типичный ВИД годографов представлен достаточно симметричными полуокружностями, исходящими из начала координат и отражающими суммарное сопротивление объемных свойств и границ зерен образца. Обработку годографов производили по эквивалентной схеме (см. главу 2, рисунок 2.5б).



Рисунок 3.34 — Типичный вид годографов импеданса для образцов в сухой атмосфере (закрытые символы) и влажной (открытые символы) атмосферах





 $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6 c t_{obp} = 1400 °C в сухой (а) и влажной (б) атмосферах$

В исследуемых условиях наблюдается увеличение общей электропроводности для всех образцов по сравнению с исходными Ba₂In₂O₅ и Ba₂InNbO₆ как в сухой (см. рисунок 3.35а), так и во влажной (см. рисунок 3.35б) атмосферах. Для составов с малым значением *x* (как твердых растворов, так и композитов с малым содержанием гетерогенной добавки) сохраняется скачок на зависимостях электропроводности, сопровождающий структурный переход основной фазы из ромбической модификации в тетрагональную. Для гетерогенных образцов в области $x \ge 0.2$, содержащих достаточное количество второй фазы, скачков или перегибов на температурной зависимости электропроводности не наблюдается. Это согласуется с рентгеновскими данными, а именно, введение добавки Ba₂InNbO₆ приводит к стабилизации тетрагональной модификации основной фазы в случае обработки выше температуры эвтектики. Во влажной атмосфере за счет появления протонных дефектов и, соответственно, протонного вклада проводимости, значения общей электропроводности композитов значимо выше, чем в сухой.

Концентрационные зависимости общей электропроводности при 400 °С в сухой и влажной атмосферах для образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6$ с $t_{obp}=1400$ °С представлены на рисунке 3.36.



Рисунок 3.36 – Концентрационная зависимость электропроводности образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6 c t_{obp}=1400 °C в сухой (закрытые символы) и влажной (открытые символы) атмосферах при 400 °C$

На рисунке 3.37 представлено сравнение концентрационной зависимости общей электропроводности для образцов с $t_{obp}=1300$ °C и $t_{obp}=1400$ °C. Повышение температуры обработки выше эвтектической для образцов с x≤0.08 существенно не сказывается на величине общей электропроводности. Этот факт также говорит в пользу предположения о формировании твердых растворов в узкой области значений х. Электропроводность композиционных образцов после обработки на 1400 °С (выше температуры эвтектики), по сравнению с обработкой на 1300 °С (ниже температуры эвтектики) существенно возрастает, разница составляет около порядка величины, то есть, композиционный эффект проводимости более выражен. Эффект суммарного увеличения общей электропроводности в сравнении с данными для Ba₂In₂O₅ при 400 °C составляет более 2 порядков величины в сухой и во влажной атмосферах.



образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6$ в сухой (закрытые символы) и влажной (открытые символы) атмосферах при 400 °C

Зависимость электропроводности от парциального давления кислорода образцов с $t_{obp}=1400^{\circ}C$

Для установления доминирующего типа носителя были проведены исследования зависимостей общей электропроводности от парциального давления кислорода. Для исследования был выбран образец из области малых x (область предполагаемых твердых растворов, x=0.03 Ba₂In_{0.97}Nb_{0.03}O_{5.03}) и наиболее проводящие композиционные образцы с x=0.2, 0.3 условного состава 0.8Ba₂In₂O₅·0.2Ba₂InNbO₆ и 0.7Ba₂In₂O₅·0. 3Ba₂InNbO₆ (см. рисунок 3.38).

96

Для образца с x=0.03 в сухой атмосфере наблюдается рост общей электропроводности с увеличением парциального давления кислорода, что сопровождается появлением положительного тангенса угла наклона зависимостей в области высоких pO_2 ($lg(pO_2) > -4$). При меньшем парциальном давлении кислорода наблюдается область электролитической проводимости, где общая электропроводность практически не зависит от pO₂. Увеличение температуры (>800 °C) приводит к расширению электролитической области. Принимая во внимание, что внедряется лишь небольшое количеств Nb⁵⁺ в позиции In³⁺, можно предполагать, что характер проводимости образца будет близок к проводимости фазы Ba₂In₂O₅ [2, 12]. Действительно, в области атмосферного pO_2 ($lg(pO_2) = -0.68$) индат бария $Ba_2In_2O_5$ имеет смешанную электронную (р-типа) и кислородно-ионную проводимость, что соответствует полученными в этой работе данными для образца Ba₂In_{1.97}Nb_{0.03}O_{5.03}. При температурах выше 800 °С увеличение вклада ионной составляюшей проводимости объясняется структурным переходом в разупорядоченное состояние для Ba₂In₂O₅ [5]. Во влажной атмосфере за счет появления протонных дефектов И, соответственно, вклада протонного переноса, во-первых, наблюдается расширение электролитической области проводимости для температур ниже 800 °C (см. уравнение 3.1). Во-вторых, при температурах ниже 700 °С наблюдается рост общей электропроводности в сравнении с данными для сухой атмосферы.

Для образцов состава $0.8Ba_2In_2O_5 \cdot 0.2Ba_2InNbO_6$ и $0.7Ba_2In_2O_5 \cdot 0.3Ba_2InNbO_6$ общая электропроводность в исследуемых условиях практически не зависит от парциального давления кислорода как в сухой, так и во влажной атмосферах. В области высоких *p*O₂ наблюдается незначительный положительный наклон. При температурах ниже 700 °C во влажной атмосфере также наблюдается рост электропроводности (разница достигает 1 порядка величины при *t*<400 °C) за счет появления вклада протонного переноса.



98

Рисунок 3.38 – Изотермы общей электропроводности от pO_2 для образцов с x=0.03 (а), x=0.20 (б) и x=0.30 (в) в сухой (закрытые символы) и влажной (открытые символы) атмосферах

На рисунке 3.39 представлены зависимости рассчитанных парциальных проводимостей (электронной, кислородно-ионной и протонной) от температуры для исследуемых образцов (см. раздел 3.5.1). Установлено, что уменьшение температуры во влажной атмосфере приводит к росту вклада и величины протонной проводимости, при температурах ниже 550 °C протонный перенос становится доминирующим.



Рисунок 3.39 – Политермы общей и парциальных проводимостей для образцов с *x*=0.03 (а), *x*=0.20 (б) и *x*=0.30 (в) во влажной атмосфере

На рисунке 3.40 приведены температурные зависимости расчетных ионных чисел переноса в атмосферах с различной влажностью. Композиционные образцы x=0.2, 0.3 во всей исследуемой области температур как в сухой, так и во влажной атмосфере являются преимущественно ионными проводниками имеют число переноса выше 80%, то есть, являются преимущественно ионными проводниками. Суммарное ионное число переноса составляет 0.75–0.95.



Рисунок 3.40 – Температурные зависимости рассчитанных суммарных ионных чисел переноса в сухой в сравнении с Ba₂In₂O₅ [18] (а) и влажной (б) атмосфере для образцов 0.8Ba₂In₂O₅·0.2Ba₂InNbO₆ и 0.7Ba₂In₂O₅·0.3Ba₂InNbO₆

На рисунке 3.41 приведены температурные зависимости протонных чисел переноса для образцов $Ba_2In_{1.97}Nb_{0.03}O_{5.03}$ и $0.7Ba_2In_2O_5 \cdot 0.3Ba_2InNbO_6$ в сравнении с данными для индата бария $Ba_2In_2O_5$. Можно видеть, что вклад протонной проводимости для изученных образцов увеличивается по сравнению с индатом бария. Кажущееся протонное число переноса для образца $0.7Ba_2In_2O_5 \cdot 0.3Ba_2InNbO_6$ составляет 0.7 при 400 °C.



Рисунок 3.41 — Сравнение протонных рассчитанных чисел переноса для образцов $Ba_2In_{1.97}Nb_{0.03}O_{5.03}$ и 0.7 $Ba_2In_2O_5$ ·0.3 Ba_2InNbO_6 (в) с $Ba_2In_2O_5$

Зависимость электропроводности от парциального давления паров воды для образцов с $t_{obp}=1400^{\circ}C$

Для наиболее проводящих образцов композиционных $0.8Ba_2In_2O_5 \cdot 0.2Ba_2InNbO_6$ $0.7Ba_2In_2O_5 \cdot 0.3Ba_2InNbO_6$ общая И электропроводность изучена в зависимости от парциального давления паров воды. На рисунке 3.42 приведены примеры годографов в интервале $pH_2O=3\cdot10^{-5}$ до 1·10⁻² атм. Годографы при температуре 400 °С выглядят схоже, представляют собой фрагмент полуокружности, характеризующий свойства образца, и более сложную часть годографа в низких частотах, которая отражает процесс на электродах. Обработку годографов производили по эквивалентной схеме (см. главу 2, рисунок 2.56) без учета электродной части спектра.



Рисунок 3.42 – Типичный вид годографов импеданса для образца с *x*=0.30 при ступенчатом изменении влажности атмосферы при 400 °C

На рисунке 3.43 представлены изотермы общей электропроводности от парциального давления паров воды. Увеличение влажности атмосферы приводит к росту общей электропроводности. При температурах 400-500 °C зависимости носят линейный характер, тангенс угла наклона составляет от 1/3 2/3.При общая до этих температурах электропроводность имеет ионную преимущественно природу (кислородно-ионную, протонную). Протонная проводимость выражается следующей зависимостью:

$$\sigma_{\rm H^+} = Z_{\rm H^+} e C_{\rm H^+} \mu_{\rm H^+}, \tag{3.13}$$

где Z_{H+-} абсолютный заряд протона; e – заряд электрона; C_{H+} – объемная концентрация протонных дефектов; μ_{H+} – подвижность протонных дефектов. Рост общей проводимости с увеличением pH_2O связан, прежде всего, с увеличением концентрации протонов. Определение концентрации протонов от pH_2O было выполнено термогравиметрическим методом и описано в разделе 3.2. Однако, интерес представляет и анализ подвижности носителей, которая также может зависеть от концентрации протонов.



Рисунок 3.43 – Зависимости общей электропроводности от парциального давления паров воды, представленные в логарифмических координатах, для образцов 0.8Ba₂In₂O₅·0.2Ba₂InNbO₆ (а) и 0.7Ba₂In₂O₅·0.3Ba₂InNbO₆ (б)

Полученные данные электропроводности и ТГ-измерений позволили рассчитать подвижности протонных дефектов в соответствии с уравнением 3.13.

Значение протонной проводимости упрощенно определяли как разницу значений при требуемом парциальном давлении паров воды и в сухой атмосфере. На рисунке 3.44 приведены значения подвижностей протонов в зависимости от их объемной концентрации.



Рисунок 3.44 – Расчетные значения подвижностей протонов в зависимости от объемной концентрации протонных дефектов для образцов 0.8Ba₂In₂O₅·0.2Ba₂InNbO₆ (a), 0.7Ba₂In₂O₅·0.3Ba₂InNbO₆ (б)

Зависимости носят линейный характер, подвижности имеют тенденцию к увеличению с ростом концентрации протонных дефектов в исследуемых условиях. В области малых концентраций протонов (температура 600 °C) подвижность протонов не зависит от их концентрации.

В работе [118] рассматриваются сложнооксидные фазы со структурным разупорядочением, для которых концентрационные зависимости подвижности протонов в определенных интервалах концентраций дефектов также возрастают. Увеличение подвижности протонов рассматривается как следствие увеличения подвижности кислородной подрешетки при появлении протонных дефектов, взаимодействующих с электронными оболочками атома кислорода. Появление протона на кислородных узлах оказывает влияние на энергетические характеристики кислорода, при этом происходит рост подвижности кислорода. Перескок протонов между узловыми позициями кислорода инициируется колебаниями системы атомов кислорода, что отражается и на подвижности протонных дефектов. На рисунке 3.45 представлена зависимость подвижности протонных дефектов от температуры для композита с x=0.3. Зависимость в представленных координатах является линейной, расчетное значение кажущейся энергии активации составляет 0.70 эВ, что сопоставимо с литературными значениями E_a для протонного переноса [1].



Рисунок 3.45 – Температурная зависимость подвижности протонных дефектов для образца $0.8Ba_2In_2O_5 \cdot 0.2Ba_2InNbO_6$ при парциальном давлении паров воды $2 \cdot 10^{-2}$ атм.

Влияние способа синтеза исходных фаз на свойства композиционных образцов, полученных методом смешения

В настоящей работе методом смешения был получен образец состава $0.8Ba_2In_2O_5 \cdot 0.2Ba_2InNbO_6$ с финальной температурой обработки 1400 °C, что выше эвтектической. Индат бария $Ba_2In_2O_5$ был получен по твердофазной технологии, синтез добавки Ba_2InNbO_6 проводили по твердофазному или растворному методу (см. главу 2, раздел 2.1), образцы отмечены (тт) и (тр), соответственно. Анализ фазового состава и морфологии данных образцов приведен в разделах 3.1.1 и 3.1.2. Были выполнены исследования плотности методом гидростатического взвешивания для образцов, результаты приведены в таблице 3.3. Плотность композиционных образцов с добавкой Ba_2InNbO_6 , полученной растворным методом, несколько больше значений для керамики, где используется твердофазный метод получения Ba_2InNbO_6 .

Таблица 3.3 – Значения пористости и относительной плотности для керамики образцов с *x*=0.05 и 0.20

Образец	р _{отн (гидр)} , %	П _{отк} , %	П _{зак} , %	П _{общ} , %
<i>х</i> =0.20 (тт)	74.4	7.11	18.52	25.63
<i>х</i> =0.20 (тр)	85.8	2.66	11.53	14.19

Температурные зависимости общей электропроводности композиционных образцов в сравнении с данными для Ba₂In₂O₅ в сухой и влажной атмосферах представлены на рисунке 3.46. Для образцов с различной предысторией синтеза наблюдаются сходные зависимости электропроводности: наблюдается композиционный эффект проводимости, образцы реагируют на изменение влажности атмосферы.



Рисунок 3.46 – Температурная зависимость электропроводности для образцов с *x*=0.20, полученных смешением фаз с различной предысторией синтеза. Закрытые символы – сухая атмосфера, открытые символы – влажная атмосфера

Как видно из данных температурных зависимостей электропроводности (см. рисунок 3.46) при температурах ниже 600 °С наблюдается различие в значениях общей электропроводности в зависимости от способа получения гетерогенной добавки. Использование допанта Ba₂InNbO₆, полученного обшей значений растворным методом, приводит к снижению электропроводности по сравнению с системой x=0.20 (тт). Для образца с 20 мол.% Ва₂InNbO₆ (тр) снижение электропроводности в сухой атмосфере достигает 0.5 порядка величины при t<400 °C. Изменение предыстории синтеза гетерогенного допанта на растворную технологию приводит к получению высокоплотной керамики, что является благоприятным фактором с точки зрения повышения электропроводности. Однако, нами наблюдается противоположная ситуация. То есть, с одной стороны, эти результаты показывают, что эффект повышения электропроводности обусловлен не изменением относительной плотности исследуемых материалов, а с другой – основное влияние на величину электропроводности оказывает другой фактор. Как было показано выше, морфология композиционных образцов x=0.20 (тт) и x=0.20 (тр), полученных отличается. Можно разными способами, заметить, что ДЛЯ образца 0.8Ва₂In₂O₅·0.2Ва₂InNbO₆ (тр), обработанного на 1400 °С (рис. 3.20) очень значительно увеличивается размер зерен основной фазы (до 20-30 мкм) по сравнению с $0.8Ba_2In_2O_5 \cdot 0.2Ba_2InNbO_6$ (тт), для которого максимальный размер зерен основной фазы достигает 5 мкм (рис. 3.19). Хотя в обоих случаях формирование субмикронных зерен To происходит эвтектики. есть. использование растворного метода синтеза приводит к активации различных процессов, как процессов спекания, так и роста зерен, что особенно значимо при термообработке на довольно высокой температуре (1400 °C). Соответственно, эффектов, доля поверхностных ответственных за формирование высокодефектных (высокопроводящих) состояний снижается, и образцы $0.8Ba_2In_2O_5 \cdot 0.2Ba_2InNbO_6$ (тр) проявляют меньшую проводимость. Как видно, такие различия в морфологии обеспечивают изменения в проводимости до 0.5 порядка величины.

Стоит отметить, что данные общей электропроводности для композитов, где использован допант Ba_2InNbO_6 , полученный твердофазным методом, совпадают с данными для композитов, полученных по твердофазной технологии методом *in situ* (данные приведены ранее в пункте 3.5.2).

Таким образом, установлено, что значительное влияние на формирование оптимальных электрических свойств изучаемых композиционных образцов оказывает дисперсность исходных фаз и, соответственно, морфология полученных образцов.

3.6 Обсуждение природы композиционного эффекта

Для композиционных образцов на основе эвтектической системы Ba₂In₂O₅–Ba₂InNbO₆ эффекта. установлено наличие композиционного Композиционный эффект проводимости наблюдается образцов с ДЛЯ температурой обработки ниже (1300 °C) и выше (1400 °C) эвтектической, при этом эффект для образцов с температурой обработки выше *t*_{эвт} более выражен. К причинам возникновения композиционного эффекта проводимости можно отнести особый характер микроструктуры композиционных образцов. обусловленный выбором режима температурной обработки. Это приводит к плавлению при нагревании и дальнейшей кристаллизации при охлаждении состава, соответствующему эвтектическому.

настоящей работе предпринята B попытка описания поведения электрической проводимости композиционных образцов С помощью математических моделей. В литературном обзоре рассмотрены основные модели, объясняющие появление композиционного эффекта в системах «ионная соль-простой оксид». Однако с помощью этих моделей наиболее точно описываются концентрационные зависимости электропроводности только в областях с малым или большим содержанием добавки. Альтернативная оценка значений проводимости композиционных электролитов может быть выполнена с помощью обобщенного уравнения смешения (I модель):

$$\sigma = (1 - f)\sigma_1 + f\sigma_2, \qquad (3.14)$$

где f – объемная доля добавки; σ_1 , σ_2 – значения электропроводности матричной фазы и гетерогенной добавки, соответственно.

Рассмотрение композиционных электролитов с точки зрения модели кубических блоков предполагает образование поверхностного высокопроводящего слоя на поверхности матрицы [33]. При этом изменение микроструктуры композитов происходит в зависимости от количества гетерогенной добавки. Это может быть отражено вводом дополнительных

величин, уравнение проводимости модифицируется следующим образом (II модель):

$$\sigma^{\alpha(f)} = (1 - f_s)\sigma_1^{\alpha(f)} + f_s\sigma_s^{\alpha(f)} + f\sigma_2^{\alpha(f)}, \qquad (3.15)$$

где f_s и σ_s – объемная доля и электропроводность поверхностного слоя, соответственно.

Для учета изменения микроструктуры композиционных образцов с увеличением содержания добавки вводится коэффициент *а*. Выражение зависимости коэффициента *а* от объемных долей компонентов композиционного образца:

$$\alpha \equiv \alpha(f) = (1 - f)\alpha_1 + f\alpha_2, \qquad (3.16)$$

где α_1 и α_2 – параметры, отражающие морфологию композита в граничных условиях ($f \rightarrow 0$ и $f \rightarrow 1$).

При значении $\alpha = 1$ уравнение 3.8 приобретает вид (III модель):

$$\sigma = (1 - f - f_s)\sigma_1 + f_s\sigma_s + f\sigma_2 \tag{3.17}$$

Расчет значений электропроводности композиционных образцов по уравнению 3.14 происходит только с учетом появления поверхностного слоя, обладающего проводимостью, превышающей проводимости σ_1 , σ_2 и не учитывает его объемную долю и, соответственно, изменение микроструктуры композиционных образцов в зависимости от количества гетерогенного допанта.

В настоящей работе предпринята попытка математического обсчета концентрационных зависимостей для системы Ba₂In₂O₅-Ba₂InNbO₆. Расчет значений проводимости проходил с учетом объемной доли фазы допанта и обоих компонентов (при *t*=400 °C электропроводностей значения σ(Ba₂In_{1.95}Nb_{0.05}O_{5.05})=7.08·10⁻⁶ Ом·см⁻¹ электропроводности: И $\sigma(Ba_2InNbO_6)=3.9\cdot10^{-7} OM \cdot cM^{-1}$ сухой атмосфере; В $\sigma(Ba_2In_{1.95}Nb_{0.05}O_{5.05})=9.55\cdot10^{-5}$ Ом·см⁻¹ и $\sigma(Ba_2InNbO_6)=1.15\cdot10^{-6}$ Ом·см⁻¹ во влажной атмосфере). Расчет по уравнениям 3.13 и 3.14 требует установления дополнительных величин. Расчет объемной доли поверхностного слоя проводят по уравнению:

$$f_s = \left(\frac{2\beta\lambda}{L_2}\right) f(1-f), \qquad (3.18)$$

где β – геометрический коэффициент для частиц (в модели кубических блоков принимает значение 3 для кубических частиц [33]), λ – толщина поверхностного слоя, *L*₂ – средний размер частиц допанта;

С помощью СЭМ-фотографий композиционного электролита $0.7Ba_2In_2O_5 \cdot 0.3Ba_2InNbO_6$, был установлен средний размер частиц допанта, который составляют 400–600 нм, соответственно. При расчете f_s значение толщины поверхностного слоя принимали за 5 нм, как наиболее часто определяемую величину [33].

Значение электропроводности поверхностного слоя происходит по уравнению 3.14, выражение для расчета выглядит следующим образом:

$$\sigma_s = \frac{\sigma - (1 - f - f_s)\sigma_1 - f\sigma_2}{f_s}$$
(3.19)

На рисунке 3.47 представлены экспериментальная и расчетные модельные концентрационные композиционных образцов зависимости для $(1-x)Ba_2In_2O_5 \cdot xBa_2InNbO_6$. Наиболее удовлетворительное описание концентрационной зависимости общей электропроводности композиционных образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 \cdot xBa_2InNbO_6$ с температурой обработки 1400 °C достигается при использовании модели II, учитывающего объемную долю поверхностного слоя и изменение морфологии композита при увеличении количества гетерогенного допанта. Однако значения общей электропроводности модельной и экспериментальной зависимостей не совпадают для образцов с малым содержанием гетерогенного допанта (x=0.07-0.08). Вероятно, такое отклонение связано с недостатком количества гетерогенного допанта Ba₂InNbO₆, способствующему переходу некоторого количества бария индата для возникновения размерного эффекта и, соответственно, перехода Ba₂In₂O₅ в высокосимметричную модификацию [119]. Для образцов с x=0.07-0.08 удовлетворительное соответствие между экспериментальными и рассчитанными значениями электропроводности достигается с моделью III, где поведение
электропроводности композиционных образцов определяется только вкладом проводимости поверхностного слоя. При использовании модели III наблюдается удовлетворительное согласие между экспериментальными и рассчитанными значениями наблюдается для композиционных образцов с температурой обработки 1300 °C, что ниже температуры эвтектики.



Рисунок 3.47 – Экспериментальная и модельные концентрационные зависимости электропроводности для образцов (1–*x*)Ba₂In₂O₅·*x*Ba₂InNbO₆ с различной температурой обработки (выше или ниже эвтектической) в сухой (а) и влажной (б) атмосферах при 400 °C

3.7 Перспективы практического применения

Интерес представляет прикладная область использования композиционных электролитов с оптимальными функциональными свойствами. Для изучения перспективы практического применения была изучена их химическая стабильность в атмосфере влажного углекислого газа, а также проведены длительные испытания в атмосфере с повышенным парциальным давлением паров воды.

3.7.1 Химическая устойчивость

Были проведены исследования химической стабильности образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6$ (*x*=0.00–1.00) в атмосфере влажного углекислого газа. Образцы $Ba_2In_2O_5$ и $0.8Ba_2In_2O_5 \cdot 0.2Ba_2InNbO_6$, выдержанные при 600 °C в атмосфере влажного CO₂ в течение 150 мин, деградируют. Согласно рентгенофазового (см. рисунок 3.48) результатам анализа продуктами разложения являются карбонат бария и оксид индия, что обусловлено химической природой основной фазы индата бария. В соответствии с данными рентгенофазового анализа сложный оксид Ba₂InNbO₆ стабилен в этих условиях, во после выдержки влажном углекислом газе не меняет состав (см. рисунок 3.48б).



Рисунок 3.48 – Рентгенограммы образцов $Ba_2In_2O_5$ (a) и Ba_2InNbO_6 (б) исходные (1) и после выдержки во влажном CO_2 (2)

Уравнение химической реакции взаимодействия индата бария Ba₂In₂O₅ с углекислым газом:

$$Ba_2In_2O_5 + 2CO_2 = 2BaCO_3 + In_2O_3,$$
 (3.20)

Увеличение количества допанта Ba_2InNbO_6 до x=0.7 и выше приводит к увеличению химической стабильности композиционных образцов, однако речь идет не о термодинамической стабильности, а о кинетической. Так, образцы с $x\geq0.7$ не изменяют значений электропроводности во влажном CO₂ в течение более 3 часов (см. рисунок 3.49а). По данным РФА после выдержки во влажном CO₂ образца $0.1Ba_2In_2O_5 \cdot 0.9Ba_2InNbO_6$ не наблюдается изменений (см. рисунок 3.49б).



(а)
Рисунок 3.49 – Изотермическая зависимость общей электропроводности в атмосфере влажного CO₂ на примере образца 0.3Ba₂In₂O₅·0.7Ba₂InNbO₆ в сравнении с данными для Ba₂In₂O₅ (а) и рентгенограмма образца 0.1Ba₂In₂O₅·0.9Ba₂InNbO₆ до (1) и после (2) выдержки во влажном CO₂ (б)

Для композиционных образцов установлено увеличение химической стабильности во влажном углекислом газе. Введение Ba₂InNbO₆ приводит к возникновению кинетических затруднений для химического взаимодействия основной фазы (как результат капсулирования матричной фазы), близкой по составу к индату бария Ba₂In₂O₅, в объеме композиционного образца.

3.7.2 Испытания керамики в качестве чувствительного элемента пароводяного сенсора резистивного типа

Для образцов с x=0.2, 0.3 зависимости $lg\sigma - lg(pH_2O)$ в температурном 400-500°C интервале носят линейный характер 3.43). (см. рисунок Электрические свойства композиционных образцов были исследованы в течение длительного времени (нескольких недель) выдержки в атмосфере воздуха при $pH_2O=0.02$ атм, не содержащем углекислого газа. На рисунке 3.50 представлены общей электропроводности образца изотермы композиционного $0.8Ba_2In_2O_5 \cdot 0.2Ba_2InNbO_6$ при обратимом изменении *p*H₂O (см. рисунок 3.50б). Показано, что значения общей электропроводности образца стабильны при выдержке на заданном значении *p*H₂O и хорошо обратимы при его изменении. Также наблюдается достаточно малое время отклика на изменение *p*H₂O.



Рисунок 3.50 – Зависимость общей электропроводности от влажности атмосферы (а) и релаксационные зависимости электропроводности при увеличении/уменьшении *p*H₂O (б) для образца с *x*=0.20 при температуре 400 °C

Результаты позволяют рассматривать изученные композиционные электролиты как потенциальные функциональные материалы для пароводяного сенсора резистивного типа, в интервале рабочих температур 400–500 °C. Однако наличие углекислого газа в рабочем пространстве пароводяного датчика будет приводить к постепенной деградации композиционного материала.

ГЛАВА 4. СИСТЕМА Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅-Ba₂InAlO₅

4.1 Фазовый состав и микроструктура

4.1.1 Рентгенофазовый анализ

Как было показано в литературном обзоре на основе индата бария Ba₂In₂O₅ формируется твердый раствор при замещении индия на алюминий в довольно широком концентрационном интервале с граничным составом Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅, поэтому композитные системы были получены на основе фаз Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ и Ba₂InAlO₅. На рисунке 4.1 представлены рентгенограммы твердого раствора Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ и фазы Ba₂InAlO₅. Обе фазы описываются тетрагональной структурой с пространственной группой *P4/mmm*. Бесструктурным методом установлены параметры элементарной ячейки: для Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ *a*=4.218(6) Å, *c*=8.350(6) Å, $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$; для Ba₂InAlO₅ *a*=4.238(5) Å, *c*=7.768(4) Å, $\alpha = \beta = \gamma = 90^{\circ}$.



Рисунок 4.1 – Рентгенограммы образцов Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ (a) и Ba₂InAlO₅ (б), обработанные по бесструктурной модели Ле Бейла

Для фазы Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ параметры соответствуют литературным [88]. Для фазы Ba₂InAlO₅ наблюдается разногласие с литературой, в работах [91, 92] структура описывается гексагональной (пр.гр. P6₃/mmc) [91] или кубической симметрией (пр.гр. Рт3т) [92]. Можно предполагать, что в настоящей работе получена другая структурная модификация фазы Ba₂InAlO₅ из-за использования методики синтеза, отличной от описанных в литературе. Так, фазу Ba₂InAlO₅ с гексагональной структурой синтезировали в виде монокристаллов из BaCO₃, In_2O_3 и Al₂O₃ с предварительной обработкой стехиометрической смеси на 900 °C, с последующим добавлением флюса (BaCl₂·2H₂O) и длительной выдержкой на температуре 1050 °С до образования кристаллов [91]. Кубический Ba₂InAlO₅ получали поликристаллическим по керамической технологии в одну стадию при 1100 °С с максимальной температурой спекания керамики 1400 °С [92], что вызывает некоторые сомнения в сохранении требуемой стехиометрии из-за крайне высокой летучести In_2O_3 . В настояшей работе синтез поликристаллического образца начинали с более низких температур обработки (см. раздел методики), что способствует сохранению заданной стехиометрии. Элементный состав образца был подтвержден спектрально-эмиссионным методом с индуктивно-связанной плазмой, мольное соотношение металлических элементов составило Ba:In:Al=2:0.97:1.04, что хорошо согласуется с заданной стехиометрией: 2:1:1. Данные энергодисперсионного рентгенографического анализа для Ba₂InAlO₅ также свидетельствуют о соответствии элементного состава стехиометрическому (см. раздел 4.1.2).

Композиционные образцы $(1-z)Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot zBa_2InAlO_5$ (z=0.04-0.83) подвергались температурной обработке при 1220 °C, что ниже температуры эвтектики ($t_{3BT}=1255$ °C), и температурной обработке при 1270 °C, что выше температуры эвтектики. Однако различий в рентгеновских данных не выявлено. Для образцов (1-z)Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ · zBa_2InAlO_5 (z=0.04-0.83) подтверждено наличие двух фаз: Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ (пр.гр. *P4/mmm*) и фазы Ba₂InAlO₅ (пр.гр. *P4/mmm*), параметры элементарных ячеек соответствуют параметрам индивидуальных фаз, полученным в настоящей работе. В качестве примера на рисунке 4.2 приведена рентгенограмма образца $0.7Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot 0.3Ba_2InAlO_5$, для которого уточненные параметры элементарных ячеек фаз составляют: $Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 a=4.198(9)$ Å, c=8.276(8) Å, $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$; $Ba_2InAlO_5 a=4.230(9)$ Å, c=7.729(3) Å, $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$.



Рисунок 4.2 – Пример обработки рентгенограммы для композиционного образца 0.7Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·0.3Ba₂InAlO₅

4.1.2 Сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионный рентгеновский анализ композиционных образцов

Исследования особенностей микроструктуры образцов $Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5$ и Ba_2InAlO_5 выполнены методом сканирующей электронной микроскопии. На рисунке 4.3 представлены СЭМ-изображения скола керамики образца Ba_2InAlO_5 , полученные во вторичных электронах. Образец состоит из частиц неправильной формы с диаметром около 1 мкм, сросшихся в более крупные агломераты с размером 2–6 мкм. Результаты элементного анализа подтверждают соответствие образца составу сложного оксида Ba_2InAlO_5 . На рисунке 4.4 приведен спектр элементного распределения в образце Ba_2InAlO_5 , мольное соотношение металлов Ba:In:Al=2.02:1.00:0.99. Это хорошо согласуется со стехиометрическими значениями Ba:In:Al=2:1:1.



Рисунок 4.3 – СЭМ-изображения скола компактированного образца Ba_2InAlO_5 ($t_{obp}=1270$ °C), полученные во вторичных электронах



Рисунок 4.4 – Данные энергодисперсионного рентгенографического анализа образца Ba₂InAlO₅

На рисунках 4.5-4.7 приведены СЭМ-изображения сколов керамики композиционных образцов $(1-z)Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot zBa_2InAlO_5$ с z=0.12 и 0.30. приведены СЭМ-изображения На рисунке 4.5 для образца *z*=0.12 с обработки 1220 °C, с температурой ЧТО ниже температуры эвтектики $(t_{3BT}=1255 \text{ °C})$. Фаза Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ представлена крупными зернами с терассоподобной поверхностью (примеры фрагментов указаны кружками на рисунках 4.5а и 4.5б), 8-10 Также размер частиц составляет мкм. наблюдаются меньшие по размеру (1-3 мкм) отдельные частицы неправильной формы, относящиеся к фазе Ba₂InAlO₅ (указаны стрелочками), и образованные ими агломераты размером 10 и более мкм (примеры фрагментов указаны квадратами на рисунках 4.5а и б).



Рисунок 4.5 – СЭМ-изображения скола таблетки композиционного образца 0.88Ва₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·0.12Ва₂InAlO₅ после обработки при 1220 °C

На рисунке 4.6 приведены СЭМ-изображения, полученные на разных электронных микроскопах, для образца 0.88Ва2In1.57Al0.43O5 0.12Ba2InAlO5 с температурой обработки 1270 °C, что выше температуры эвтектики (*t*_{эвт}=1255 °C). Повышение температуры обработки приводит к существенному изменению микроструктуры образца. Происходит общее подплавление поверхности зерен, положительно сказывается на плотностных что характеристиках, увеличивается относительная плотность. Ha СЭМидентифицировать изображениях четко можно крупные только зерна, относящиеся к фазе Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅. На поверхности зерен наблюдается появление слоя мелких кристаллитов нанометрового размера (см. рисунки 4.66 и 4.6в). На сколах зерен видны полосы, которые также могут отражать процесс повторной кристаллизации (примеры фрагментов указаны квадратами на рисунке 4.66).

Появление нанометровых кристаллитов обусловлено эвтектическим характером системы Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅–Ba₂InAlO₅ и температурной обработкой керамики выше температуры эвтектики, при которой часть вещества переходит в расплав. Поскольку выраженных зерен, относящихся к фазе Ba₂InAlO₅, не

наблюдается, вероятно, для данного состава композита данная фаза при нагревании полностью переходит в расплав, а фаза Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ подплавляется частично. При охлаждении происходит изменение состава расплава до эвтектического и последующая кристаллизация эвтектики, что приводит к появлению нанометровых кристаллитов.



Рисунок 4.6 – СЭМ-изображения скола таблетки композиционного образца 0.88Ва₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·0.12Ва₂InAlO₅ после обработки при 1270 °C

Для композиционного образца $0.7Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot 0.3Ba_2InAlO_5$ СЭМизображения скола керамики, обработанной выше температуры эвтектики ($t_{oбp}$ =1270 °C), представлены на рисунке 4.7. При увеличении количества гетерогенного допанта микроструктура образца видна не так четко: кристаллиты нанометрового размера можно наблюдать только на внутренней поверхности пор или на отдельных участках более крупных по размеру (8–10 мкм) зерен основной фазы (примеры фрагментов указаны квадратами на рисунке 4.7). Количественное увеличение добавки с 12 до 30 мол.% приводит к значительному увеличению плотности образца.





Рисунок 4.7 – СЭМ-изображения скола таблетки композиционного образца 0.7Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·0.3Ba₂InAlO₅ после обработки на 1270 °С при различном увеличении – (а) и (б); увеличенный квадратный фрагмент изображения 4.7а – (в); изображение поверхности поры – (г)

Результаты энергодисперсионного анализа композитов из-за их особой микроструктуры позволяют увидеть только усредненное распределение элементов, которое соответствует общему элементному составу образцов.

4.2 Термические свойства

образцов $(1-z)Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot zBa_2InAlO_5$ Возможность гидратации определяли с помощью термогравиметрического анализа. На рисунке 4.8а представлены ТГ-кривые, полученные в режиме охлаждения во влажной атмосфере для Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅, Ba₂InAlO₅ и композиционных образцов с z=0.12и 0.48. Термогравиметрические кривые для всех образцов имеют схожий вид: при охлаждении образцов во влажной атмосфере происходит увеличение их массы: рост массы наблюдается уже при температурах ниже 600 °C, основное количество воды внедряется при температурах 200-300 °С. Полученные данные масс-спектроскопического анализа и метода дифференциальной сканирующей калориметрии для предварительно гидратированного композиционного образца z=0.12 (см. рисунок 4.86) в режиме нагрева подтверждают потерю массы образца в температурном интервале 200–500 °C в связи с удалением молекул воды из структуры сложного оксида. Несоответствие температурных интервалов внедрения/удаления воды на ТГ-кривых (см. рисунки 4.8а и 4.8б) можно объяснить различием режима (нагрев или охлаждение) и скорости съемки.



Рисунок 4.8 – Термогравиметрические кривые, полученные в режиме охлаждения во влажной атмосфере, образцов (1–*z*)Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·*z*Ba₂InAlO₅ (а) и ТГ-кривая с данными масс-спектра и ДСК-сигнала, полученная в режиме нагрева, для предварительно гидратированного образца с *z*=0.12 (б)

Для твердого раствора количество структурных вакансий кислорода составляет 1 моль на формульную единицу сложного оксида $Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5(V_o)_1$, соответственно, предполагаемое количество внедряемой воды при заполнении всех имеющихся вакансий (см. уравнение 3.1) должно также составлять 1 моль. При этом установленное экспериментально количество воды составляет 0.49 моль H₂O на формульную единицу Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅. При изовалентном допировании катионами алюминия индата бария Ba₂In₂O₅ происходит замещение индия на алюминий преимущественно в тетраэдрическом окружении [88]. В этом случае максимальная степень гидратации образцов в сравнении с Ba₂In₂O₅ уменьшается из-за энергетически затрудненного перехода тетраэдров [AlO₄] в октаэдры с участием ОН⁻-групп в координации алюминия [AlO₄(OH)₂] [88]. В соответствии с этим, для твердого раствора Ва₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ теоретическая максимальная степень гидратации должна составлять 0.57 моль на формульную единицу, экспериментальные данные удовлетворительно соответствуют этому значению.

Для фазы Ba₂InAlO₅, где содержание Al³⁺ еще выше, степень гидратации мала: количество воды на формульную единицу составляет 0.12 моль.

Для композиционных образцов наблюдается закономерное снижение степени гидратации при увеличении содержания гетерогенного допанта Ba₂InAlO₅. Учитывая максимальную степень гидратации фаз Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ и Ba₂InAlO₅ и их мольное соотношение в образцах, экспериментальный предел гидратации удовлетворительно соответствуют теоретическому. Следует подчеркнуть, что температура обработки композиционных образцов не влияла на степень гидратации.

4.3 Спектроскопические свойства

На рисунке 4.9 представлены инфракрасные спектры гидратированных образцов $(1-z)Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot zBa_2InAlO_5$ (*z*=0.00, 0.12). При анализе ИК-спектров установлены валентные колебания связей О–Н в интервале частот 3000–3500 см⁻¹, доказывающие присутствие кислородно-водородных группировок в структуре [9]. В области деформационных колебаний от 1000 до

2000 см⁻¹ присутствует несколько полос со следующими значениями длин волн: 1370 и 1430 см⁻¹. Деформационные колебания при значениях длин волн ≤1500 см-1 относят к колебаниям связей в гидроксильных группах [9]. Таким образом, можно заключить, что процесс внедрения воды носит диссоциативный характер, вода присутствует в структуре в виде протонов, локализованных на ионах кислорода, то есть, в виде ОН--групп. Соответственно, возвращаясь к анализу валентных колебаний связей О-Н, можно сказать, что эта широкая полоса представляет собой суперпозицию нескольких вкладов. В общем случае в области v(OH) можно четко выделить две компоненты, как результат присутствия ОН⁻-групп с различным набором силовых постоянных. Это, как правило, обусловлено наличием ОН-групп, с разной степенью их участия в водородных связях. Максимум широкой полосы около 2810 см⁻¹ указывает на наличие ОН--групп, участвующих в сильных водородных связях. Основной максимум широкой полосы около 3355 см⁻¹ указывает, что некоторое количество ОН⁻-групп участвуют в более слабых водородных связях. При варьировании *х* смещения полос не происходило, что закономерно, так как основной вклад в гидратацию композитов обеспечивается присутствием индиевых тетраэдров в ϕ ase Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅.



Рисунок 4.9 – ИК-спектры предварительно гидратированных образцов (1–*z*)Ва₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·*z*Ba₂InAlO₅ (*z*=0.00, 0.12)

В КР-спектрах для дегидратированной фазы Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ наблюдаются линии различной интенсивности (см. рисунок 4.10), которые, согласно литературным данным [120, 121], можно отнести к разного типа колебаниям связей Ме–О в полиэдрах [MeO_n], где Me=Ba, Al, In. Линии, наблюдающиеся при длинах волн ниже 200 см⁻¹, отвечают колебаниям связей типа Ва-О; в интервале 400–750 см⁻¹ – колебаниям связей In–O в октаэдрическом и/или тетраэдрическом окружении; выше 750 см⁻¹ – колебаниям связей Аl-O. В спектре колебаний решетки присутствует широкая полоса ~800 см⁻¹, которая характерна для связей Al–O, где катион алюминия находится в тетраэдрической координации [120]. Как видно, при гидратации фазы эта полоса не меняет своего положения, то есть, полиэдры, в которых находится алюминий, не принимают участия в гидратации. Линия 605 см⁻¹ принадлежит колебаниям связей In–O в тетраэдрах [InO₄], а линия 530 см^{-1} – октаэдрическим колебаниям [InO₆]. Как видно, при гидратации наиболее значительные изменения в спектре наблюдаются именно в этой области частот. При гидратации образца Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ происходит смена тетраэдрического окружения ионов In³⁺ на октаэдрическое, как результат заполнения структурных вакансий кислорода и появления в структуре OH⁻-групп [121], это приводит к исчезновению линии КР-спектра в области ~600 см⁻¹ (рисунок 4.10). Можно полагать, что образующиеся кислородные октаэдры при этом являются центросимметричными, поэтому интенсивность линии от этого колебания мала.



Рисунок 4.10 – КР-спектры образца $Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5$

4.4 Электрические свойства

4.4.1 Электрические свойства Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ и Ba₂InAlO₅

На рисунке 4.11 представлены годографы образцов Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ и Ba₂InAlO₅. В случае Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ вид годографов представлен симметричными полуокружностями, исходящими из начала координат, которые

отражают преимущественно объемное сопротивление образца. Для Ba_2InAlO_5 годографы представлены несимметричными полуокружностями: ниже 450 °C можно выделить два вклада, относящихся к свойствам объема и границ зерен образца. Выше 450 °C в низкочастотной области появляется третий вклад, относящийся к электродному процессу. За сопротивление образца принимали суммарное сопротивление объема и границ зерен, поскольку выделить объемную составляющую для всего исследуемого интервала температур не удалось. Обработку годографов производили по эквивалентным схемам (см. главу 2, рисунок 2.4б и 2.5б).



Рисунок 4.11 – Годографы импеданса для Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ (a, б) и Ba₂InAlO₅ (в, г) полученные в сухой атмосфере при различных температурах (а, в); в сравнении при 300 °C в сухой (закрытые символы) и влажной (открытые символы) атмосфере (б, г)

На рисунке 4.12 представлены температурные зависимости общей электропроводности для образцов Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ и Ba₂InAlO₅. Для твердого раствора Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ наблюдается незначительный перегиб на зависимости проводимости в температурном интервале 700-800 °C как в сухой, так и во влажной атмосферах. Перегиб на температурной зависимости вызван структурным переходом твердого раствора Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ из тетрагональной симметрии в кубическую, что соответствует литературным данным [88]. Ниже 700 °C, можно выделить линейный участок зависимости электропроводности, на котором определяемое значение эффективной энергии активации составляет 0.80 эВ. Для индата-алюмината бария Ba₂InAlO₅ электропроводность в сухой атмосфере линейно зависит от температуры, эффективная энергия активации составляет 0.92 эВ. Для обоих образцов ниже 600 °С наблюдается увеличение электропроводности во влажной атмосфере; в соответствии с данными ТГ, это определяется внедрением в структуру сложных оксидов молекул воды и появлением протонного вклада проводимости. Ниже 450 °C увеличение электропроводности во влажной атмосфере для Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ и Ba₂InAlO₅ достигает 2 и 1 порядка величины, соответственно, по сравнению со значениями сухой атмосфере. При температурах ниже 500 °C электропроводности В значения кажущейся энергии активации во влажной среде уменьшаются: для Ва₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ до 0.22 эВ, для Ва₂InAlO₅ до 0.60 эВ.



Рисунок 4.12 — Температурные зависимости электропроводности для Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ и Ba₂InAlO₅ в сухом (закрытые символы) и влажном (открытые символы) воздухе

На рисунке 4.13 представлены изотермы проводимости для Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ и Ba₂InAlO₅ в зависимости от парциального давления кислорода. В общем случае понижение *p*O₂ приводит к уменьшению общей электропроводности с выходом на плато – в область электролитической проводимости как в сухой, так и во влажной атмосферах. В случае $Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5$ рост температуры способствует уменьшению тангенса угла наклона в области парциального давления кислорода 10⁻⁶-0.21 атм, что, вероятно, связано с увеличением доли ионной составляющей проводимости из-за роста подвижности ионных носителей вследствие перехода структуры в высокосимметричную кубическую модификацию с полностью кислородных вакансий. Для Ba₂InAlO₅ статистическим расположением существенного изменения тангенса угла наклона в этом интервале pO_2 не наблюдается. Увеличение парциального давления паров воды приводит к росту вклада ионной проводимости для Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ и Ba₂InAlO₅ во всех исследуемых условиях. Общую электропроводность обеих фаз на воздухе можно охарактеризовать как смешанную: ионную (в сухой кислородно-ионную, во влажной кислородно-ионную и протонную) и электронную (*p*-типа). При этом для Ba₂InAlO₅ вклад электронной проводимости существенно выше.



Рисунок 4.13 – Изотермические зависимости общей электропроводности от парциального давления кислорода для Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ (a) и Ba₂InAlO₅ (б) в сухой (закрытые символы) и влажной (открытые символы) атмосферах

Для индата-алюмината бария Ba₂InAlO₅ методом ЭДС определены суммарные ионные и кажущиеся протонные числа переноса во влажной

атмосфере (см. рисунок 4.14а). Установлено, что вклад ионной проводимости во влажной атмосфере растет при снижении температуры. При 600 °C вклад ионной проводимости во влажной атмосфере достигает 50%, доля протонного переноса составляет около 35%. Комбинация данных по температурной зависимости общей электропроводности во влажной атмосфере и чисел переноса позволила произвести расчет парциальных проводимостей в температурном интервале 600–850 °C (математические расчеты представлены в главе 3, раздел 3.5.1).

На рисунке 4.146 представлены температурные зависимости для кислородно-ионной, протонной, электронной (*p*-типа) парциальных проводимостей в сравнении с общей проводимостью для Ba₂InAlO₅. При температурах ниже 650 °C во влажной атмосфере индат-алюминат бария можно охарактеризовать как смешанный проводник с сопоставимыми вкладами ионной и дырочной проводимости.



Рисунок 4.14 – Температурные зависимости суммарных ионных и кажущихся протонных чисел переноса во влажной атмосфере для образца Ba₂InAlO₅, измеренные методом ЭДС (а), и зависимость общей электропроводности от температуры в сравнении с парциальными проводимостями во влажной атмосфере (б)

4.4.2 Электрические свойства композиционных образцов

Как и для описанных выше композиционных систем при гетерогенном допировании перовскитной фазой Ba₂InNbO₆ (см. главу 3), для системы

 $(1-z)Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot zBa_2InAlO_5$ электрические измерения проводили для композиционных образцов, полученных при термообработке ниже (1220 °C) и выше (1270 °C) температуры эвтектики (1255 °C). Однако при термообработке на 1220 °С электропроводность композиционных образцов системно уменьшалась с увеличением концентрации гетерогенного допанта Ba₂InAlO₅ и определялась суммой вкладов от двух фаз $Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5$ и Ba_2InAlO_5 (см. уравнение 3.14). То есть, композиционного эффекта не проявлялось. Соответственно, такая система представляла интереса для системного изучения. Дальнейшие не ee образцов исследования проводили для композиционных (1-z)Ва₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·*z*Ва₂InAlO₅ с t_{obp} 1270 °С (выше температуры эвтектики).



Рисунок 4.15 – Температурные зависимости общей электропроводности для образцов $0.96Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot 0.04Ba_2InAlO_5$ (a) и $0.88Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot 0.12Ba_2InAlO_5$ (б) с различной температурой обработки в сухом (закрытые символы) и влажном (открытые символы) воздухе

Электрические свойства образцов $(1-z)Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot zBa_2InAlO_5,$ полученных методом смешения с финальной стадией обработки при 1270 °C, то есть, выше температуры эвтектики системы, изучены методом электрохимического импеданса в сухой и влажной атмосферах. На рисунке 4.16 представлены примере образца спектры импеданса на $0.88Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot 0.12Ba_2InAlO_5$. Вид годографов представляет собой несимметричные полуокружности. Сопротивление, полученное при обработке годографов, принимали за общее сопротивление образца. Обработку годографов производили по эквивалентным схемам (см. рисунок 2.5б и г, см. главу 2).



Рисунок 4.16 – Годографы импеданса для $0.88Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot 0.12Ba_2InAlO_5$, полученные в сухой атмосфере при *t*=310, 350 и 400 °C (a); при 300 °C в сухой (закрытые символы) и влажной (открытые символы) атмосферах (б)

На рисунках 4.17 и 4.18 представлены температурные зависимости общей электропроводности образцов $(1-z)Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot zBa_2InAlO_5$. Установлено, что введение Ba₂InAlO₅ приводит к повышению общей электропроводности композиционных образцов при температурах ниже 600 °C по сравнению с проводимостью исходных фаз Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ и Ba₂InAlO₅. Максимальное электропроводности достигается образца увеличение для 0.7Ва₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·0.3Ва₂InAlO₅ и составляет 1/4 порядка величины как в сухой, так и во влажной атмосферах. В высокотемпературной области наблюдается сглаживание или полное исчезновение перегиба на зависимости проводимости, характерного для твердого раствора Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅, вследствие увеличения количества добавки Ba₂InAlO₅ и формирования особой микроструктуры. Во влажной атмосфере наблюдается рост общей электропроводности композиционных образцов по сравнению со значениями проводимости для сухой атмосферы из-за возникновения вклада протонного переноса.



Рисунок 4.17 – Температурные зависимости общей электропроводности для образцов (1–*z*)Ва₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·*z*Ba₂InAlO₅ в сухом (а) и влажном (б) воздухе



Рисунок 4.18 – Температурные зависимости общей электропроводности для образцов (1–*z*)Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·*z*Ba₂InAlO₅ в сравнении в сухом (закрытые символы) и влажном (открытые символы) воздухе

130

На рисунке 4.19 представлены изотермы общей электропроводности образца $0.88Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot 0.12Ba_2InAlO_5$ в зависимости от парциального давления кислорода. Наблюдается тенденция уменьшения тангенса угла наклона зависимости в области высоких $pO_2=10^{-5}-0.21$ атм при увеличении температуры и влажности атмосферы, как и для твердого раствора $Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5$, что характеризует увеличение вклада ионной проводимости. Во влажной атмосфере при температурах ниже 600 °C наблюдается электролитическая область проводимости, то есть доминируют атомные дефекты, соответственно, преимущественный вклад вносит ионная проводимость.



Рисунок 4.19 – Зависимости общей электропроводности от парциального давления кислорода для образца 0.88Ва₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·0.12Ba₂InAlO₅ в сухой (закрытые символы) и влажной (открытые символы) атмосферах

На рисунке 4.20а представлена температурная зависимость суммарных ионных (кислородно-ионных, протонных) и кажущихся протонных чисел переноса композита $0.7Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot 0.3Ba_2InAlO_5$, определенных методом ЭДС во влажной атмосфере. Снижение температуры приводит к увеличению вклада ионной проводимости, ниже 700 °C она становится доминирующей. При 600 °С суммарное ионное число переноса достигает значения 0.85. Используя полученные результаты совместно с данными температурных зависимостей общей электропроводности BO влажной атмосфере, были рассчитаны парциальные вклады проводимости (кислородно-ионный, протонный,

электронный) (математические расчеты представлены в главе 3, раздел 3.5.1). На рисунке 4.20б представлены температурные зависимости общей и парциальных проводимостей. Общую электропроводность композиционного образца 0.7Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·0.3Ba₂InAlO₅ во влажной атмосфере можно охарактеризовать как смешанную: ионную (суммарную кислородно-ионную и протонную) и электронную (*p*-типа). Ниже 600 °C доминирует ионная проводимость.



Рисунок 4.20 – Температурные зависимости общих ионных и протонных чисел переноса во влажной атмосфере для образца *z*=0.30, измеренные методом ЭДС (а); температурные зависимости общей и парциальных проводимостей во влажной атмосфере (б).

Концентрационные зависимости электропроводности образцов

На рисунке 4.21 представлена концентрационная зависимость общей электропроводности для образцов (1-z)Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·zBa₂InAlO₅ при 500 °C в атмосферах с различной влажностью. Увеличение мольной доли фазы Ba₂InAlO₅ до 30 мол.% приводит к увеличению электропроводности как в сухой, так и во влажной атмосферах. Вид зависимости схож для композиционных электролитов на основе систем «ионный проводник–диэлектрик», наблюдается максимум проводимости при концентрации добавки 20–30 мол.% добавки. Достигающийся максимум общей электропроводности не является суммой электропроводностей исходных компонентов Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ и Ba₂InAlO₅ с учетом их объемных долей. Увеличение общей электропроводности композиционного образца

0.7Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·0.3Ba₂InAlO₅ в сравнении с Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ при температуре 500 °C 1/4 невелико И достигает порядка величины. При этом рентгенографические исследования позволили исключить образование новых фаз в системе и определить, что введение гетерогенной добавки Ba₂InAlO₅ не приводит к изменению структурной модификации базовой фазы Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅. Вероятно, увеличение электропроводности образцов композиционных обусловлено изменением микроструктуры образца при обработке выше температуры эвтектики поверхность основной фазы $Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5$ композиционных образцов покрывается слоем наноразмерных кристаллитов, появившихся вследствие кристаллизации эвтектического состава, что мы наблюдаем на СЭМ-изображениях. Появившийся слой кристаллитов обладает большей дефектностью, что определяет появление путей быстрого ионного Максимум проводимости, наблюдающийся образца переноса. для 0.7Ва₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅·0.3Ва₂InAlO₅, обусловлен достижением непрерывности путей транспорта объему образца. Дальнейшее ионного по увеличение низкопроводящей фазы приводит к снижению величины электропроводности до уровня проводимости гетерогенной добавки Ba₂InAlO₅, из-за ее количественного преобладания и, соответственно, блокирования путей быстрого ионного переноса. Строго говоря, для композитов $(1-z)Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 \cdot zBa_2InAlO_5$ нельзя исключать и возможность частичной стабилизации кубической модификации, идентифицировать которую по данным рентгеновского анализа затруднительно.



Рисунок 4.21 – Концентрационная зависимость общей электропроводности образцов (1–*x*)Ва₂In₂O₅·*x*Ba₂InAlO₅ в сухой атмосфере при 500°С

ГЛАВА 5. СИСТЕМА Ba₂In₂O₅-Ba₄In₆O₁₃

5.1 Фазовый состав и микроструктура

5.1.1 Рентгенофазовый анализ

Методом порошковой рентгеновской дифракции получены рентгенограммы индивидуальных фаз $Ba_2In_2O_5$, $Ba_4In_6O_{13}$ и композиционных образцов состава $(1-z)Ba_2In_2O_5 \cdot zBa_4In_6O_{13}$ (z=0.03-0.30). Рентгенограммы приведены на рисунках 5.1 и 5.2.

Фаза $Ba_4In_6O_{13}$ наиболее точно описывается пространственной группой *Cmm2* с параметрами элементарной ячейки: *a*=11.909(3) Å, *b*=11.861(6) Å, *c*=20.572(5) Å. [93]. По данным литературных источников фаза $Ba_4In_6O_{13}$ описывается различными пространственными группами в ромбической симметрии [93, 94, 95], полученные данные согласуются с литературными, приведенными в работе [93].



Рисунок 5.1 – Рентгенограмма Ва₄In₆O₁₃, обработанная бесструктурным методом

Композиционные образцы $(1-z)Ba_2In_2O_5 \cdot zBa_4In_6O_{13}$ (*z*=0.03–0.30) двухфазные (см. рисунок 5.2), содержат фазы $Ba_2In_2O_5$ с пространственной группой *Ibm2* и $Ba_4In_6O_{13}$ с пространственной группой *Cmm2* (см. рисунок 5.2). Композиционные образцы с *z*<0.5 преимущественно содержат фазу $Ba_2In_2O_5$ (см. рисунок 5.3а). По результатам обработки рентгенограмм методом Ритвельда по бесструктурной модели фаза $Ba_2In_2O_5$ описывается ромбической структурой.

Введение гетерогенного допанта не приводит к стабилизации тетрагональной модификации индата бария, сохраняется низкотемпературная модификация Ba₂In₂O₅, в которой вакансии кислорода находятся в упорядоченном состоянии.



Рисунок 5.2 – Рентгенограммы композитов (1–*z*)Ва₂In₂O₅·*z*Ba₄In₆O₁₃ (*z*=0.03–0.30) в сравнении с индивидуальными фазами Ba₂In₂O₅ и Ba₄In₆O₁₃. Звездочками обозначены рефлексы, относящиеся к фазе Ba₄In₆O₁₃



Рисунок 5.3 – Обработка рентгенограммы методом полнопрофильного анализа для образца 0.7Ва₂In₂O₅·0.3Ва₄In₆O₁₃

5.1.2 Сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионный рентгеновский анализ

Методом сканирующей электронной микроскопии проанализирована морфология порошковых и керамических образцов (поверхность и скол) индивидуальных фаз Ba₂In₂O₅, Ba₄In₆O₁₃ и композиционных образцов состава $(1-z)Ba_2In_2O_5 \cdot zBa_4In_6O_{13}$. Также методом энергодисперсионного рентгеновского анализа установлен элементный состав полученных керамических образцов. На рисунке 5.4 представлено СЭМ-изображение порошка фазы Ba₄In₆O₁₃, полученное во вторичных электронах. Порошок преимущественно состоит из агломерированных частиц пластинчатой формы, размер которых составляет по длине и ширине 2–5 мкм, с толщиной от 0.5 до 1 мкм. На рисунке 5.5 представлены СЭМ-изображения, полученные во вторичных электронах, для На поверхности керамического образца основе $Ba_4In_6O_{13}$. керамики на отсутствуют открытые поры и трещины (см. рисунок 5.5а). На сколе керамического образца (см. рисунок 5.5б) видна незначительная пористость (закрытая пористость), размер пор от 1 до 2 мкм. В целом, керамика на основе $Ba_4In_6O_{13}$ характеризуется незначительной пористостью.



Рисунок 5.4 – СЭМ-изображение порошка Ва₄In₆O₁₃



(a) Рисунок 5.5 – СЭМ-изображение поверхности (а) и скола (б) керамического образца Ва₄In₆O₁₃

Данные энергодисперсионного микроанализа для поверхности и скола керамического образца $Ba_4In_6O_{13}$ приведены на рисунках 5.6 и 5.7. На сколе керамики наблюдается достаточно однородное распределение элементов по барию, индию и кислороду. В соответствии с полученной диаграммой распределения металлических элементов для поверхности керамического образца, катионный состав совпадает с теоретическим расчетом атомных долей по барию и индию для $Ba_4In_6O_{13}$ (40 ат.% для Ba и 60 ат.% для In).



Рисунок 5.6 – СЭМ-изображение в отраженных электронах скола компактированного образца Ва₄In₆O₁₃ в сопоставлении с картой электронного распределения (Ва~зелёный, In~красный, O~синий)



Рисунок 5.7 – СЭМ-изображение поверхности керамического образца Ва₄In₆O₁₃ (а) и диаграмма элементного распределения Ва и In (б)

На рисунках 5.8–5.9 представлены СЭМ-изображения порошков, а также поверхности и сколов керамического композиционного образца состава $0.7Ba_2In_2O_5 \cdot 0.3Ba_4In_6O_{13}$. Для порошка с 30 мол.% гетерогенной добавки $Ba_4In_6O_{13}$ можно наблюдать частицы различных форм: на более крупных округлых частицах, относящихся к фазе $Ba_2In_2O_5$, находятся пластинчатые частицы, относящиеся к фазе $Ba_4In_6O_{13}$ (см. рисунок 5.8а). На поверхности

138

керамики на основе композиционного образца с x=0.30 отсутствуют трещины и поры (см. рисунки 5.9а). На сколе присутствует незначительное количество пор (см. рисунки 5.9б). Керамические образцы на основе Ba₂In₂O₅ с гетерогенной добавкой Ba₄In₆O₁₃ плотные с незначительной закрытой пористостью. На СЭМ-изображениях скола керамических композиционных образцов отсутствуют области, которые можно было бы идентифицировать как частицы индивидуальных фаз Ba₂In₂O₅ и Ba₄In₆O₁₃.



Рисунок 5.8 – СЭМ-изображения порошка композиционного образца 0.7Ba₂In₂O₅·0.3Ba₄In₆O₁₃ (a)



компактированного композиционного образца $0.7Ba_2In_2O_5 \cdot 0.3Ba_4In_6O_{13}$

Вероятно, близкий элементный состав и сходный структурный мотив обеих фаз (низкотемпературная орторомбическая структура для $Ba_2In_2O_5$ является перовскитоподобной [5], в то время как блочно-слоевая структура $Ba_4In_6O_{13}$ предполагает наличие перовскитных блоков « $Ba_2In_2O_6$ » [77]) обуславливает высокое сопряжение их частиц при высокотемпературной обработке керамики при 1350 °C.

5.2 Термические свойства

Изучение возможности взаимодействия фазы $Ba_4In_6O_{13}$ и композиционных образцов $(1-z)Ba_2In_2O_5 \cdot zBa_4In_6O_{13}$ (z=0.03-0.30) с парами воды осуществляли с помощью термогравиметрического анализа. Для предварительно выдержанного во влажной атмосфере порошка $Ba_4In_6O_{13}$ наблюдали уменьшение массы при нагреве (см. рисунок 5.10), это связано с выходом воды из структуры сложного оксида. Удаление воды в соответствии с термогравиметрической кривой происходит в интервале температур от 400 до 600 °C.



Рисунок 5.10 – Термогравиметрическая кривая, полученная в условиях нагрева, предварительно гидратированного порошка Ba₄In₆O₁₃

Общее количество воды, внедряемое в структуру, невелико и составляет 0.06 моль на формульную единицу $Ba_4In_6O_{13}$. Поскольку структура $Ba_4In_6O_{13}$ изначально комплектна по кислородно-ионной подрешетке, то незначительные количества внедряющейся воды могут быть обусловлены нарушением стехиометрии (см. раздел 3.5.1). На рисунке 5.11а представлены ТГ-кривые для композиционных образцов(1–*z*) $Ba_2In_2O_5 \cdot zBa_4In_6O_{13}$ (*z*=0.03–0.30).



Рисунок 5.11 – Термогравиметрические кривые, полученные в режиме нагрева, композиционных образцов (1–*z*)Ва₂In₂O₅·*z*Ba₄In₆O₁₃ (*z*=0.03–0.30) (а) и ТГ-кривая с данными масс-спектра для образца с *z*=0.03 (б),

Характер зависимостей для всех композиционных образцов соотносится с данными количественного содержания фазы $Ba_2In_2O_5$ [15]. При нагревании предварительно гидратированных образцов происходит одностадийное изменение массы в интервале температур 300–400 °C. В соответствии с данными масс-спектроскопического анализа (см. рисунок 5.11б) уменьшение массы композиционных образцов при этих температурах происходит из-за удаления воды. Поскольку для $Ba_2In_2O_5$ характерно внедрение больших количеств воды (порядка 1 моль H_2O на формульную единицу сложного оксида [15]), а для $Ba_4In_6O_{13}$ – незначительных (0.06 моль на формульную единицу), то именно присутствие фазы $Ba_2In_2O_5$ определяет максимальную степень гидратации композиционных образцов (1–*z*) $Ba_2In_2O_5 \cdot zBa_4In_6O_{13}$.

На рисунке 5.12 представлено сравнение мольного количества фазы Ba₂In₂O₅ в композитах (максимальная степень гидратации) и количество воды, внедряющиеся в образцы, и определенное по результатам ТГ-данных. При гетерогенной добавки $Ba_4In_6O_{13}$ (уменьшении увеличении количества $Ba_2In_2O_5$) происходит закономерное содержания уменьшение степени композиционных образцов, наблюдается соответствие между гидратации теоретическим пределом степени гидратации и экспериментальными данными.



Рисунок 5.12 — Внедряемое количество воды для образцов $(1-z)Ba_2In_2O_5 \cdot zBa_4In_6O_{13}$ ($0 \le z \le 1$) в сравнении мольным количеством фазы $Ba_2In_2O_5$ (пунктирная линия)

5.3 Электрические свойства

Для корректной интерпретации электрических свойств композиционных образцов необходимо иметь представление о характере проводимости обеих исходных фаз $Ba_2In_2O_5$ и $Ba_4In_6O_{13}$. Для индата бария $Ba_2In_2O_5$ электрические свойства достаточно подробно изучены [17, 18], для $Ba_4In_6O_{13}$ информация об электрических свойствах ограничена одной статьей [95], в которой указывается о сопоставимых значениях удельной электропроводности с $Ba_2In_2O_5$, при этом измерения были произведены без контроля влажности атмосферы. Поэтому в настоящей работе электрические свойства фазы $Ba_4In_6O_{13}$ были детально изучены.

5.3.1 Электрические свойства фазы Ва₄In₆O₁₃

Температурные зависимости электропроводности

Электрические свойства Ba₄In₆O₁₃ изучены методом электрохимического импеданса. На рисунке 5.13 представлены примеры годографов электрохимического импеданса в атмосферах с различной влажностью. Спектры электрохимического импеданса для Ba₄In₆O₁₃ – полуокружности практически

правильной формы, исходящие из начала координат. Для нахождения значения сопротивления образца использовались эквивалентная схема, представленная на рисунке 2.56 (см. главу 2). Значения емкостной составляющей, определяемые при обработке годографов, составляют порядка 10⁻¹¹ Ф, что, с большой вероятностью, демонстрируют преимущественно объемные свойства образца.



Рисунок 5.13 – Типичный вид годографов импеданса для образца Ва₄In₆O₁₃ в сухой (закрытые символы) и влажной (открытые символы) атмосферах

На рисунке 5.14 представлена температурная зависимость удельной электропроводности для Ba₄In₆O₁₃. Вид зависимости носит полупроводниковый электропроводности характер, значения снижаются при уменьшении температуры как в сухой, так и во влажной атмосферах. С ростом температуры происходит увеличение энергии активации, что, вероятно, связано с изменением парциального вклада проводимости или сменой типа носителей заряда. Во влажной атмосфере ниже 700 °C значения электропроводности значительно выше, чем в сухой атмосфере. Максимальный рост электропроводности достигается при температурах ниже 500 °С и составляет порядок величины. Увеличение электропроводности согласуются с данными термогравиметрического анализа: в результате внедрения молекул воды в структуру сложного оксида Ва₄In₆O₁₃ происходит образование протонных дефектов. Во влажной атмосфере при температурах ниже 600 °C значение кажущейся энергии активации составляет 0.46 эВ.



Рисунок 5.14 – Температурные зависимости общей электропроводности для образца Ba₄In₆O₁₃ в сухой (закрытые символы) и влажной (открытые символы) атмосферах

Зависимости электропроводности от парциального давления кислорода

Для установления типа доминирующего носителя заряда для фазы $Ba_4In_6O_{13}$ были получены изотермы электропроводности в зависимости от парциального давления кислорода в сухой и влажной атмосферах (см. рисунки 5.15 - 5.17). В сухой атмосфере во всем интервале температур увеличение pO_2 приводит к снижению значений общей электропроводности (см. рисунок 5.15). Наблюдается отрицательный наклон для всех зависимостей, отражающий значительный вклад электронной проводимости *n*-типа; тангенс угла наклона по абсолютному значению с ростом температуры увеличивается и достигает значений -1/6 для 920 °C. Появление электронных дефектов связано с выходом кислорода из структуры сложного оксида и может быть представлено следующим квазихимическим уравнением 5.3:

$$O_{o}^{\times} \leftrightarrow \frac{1}{2}O_{2} + V_{o}^{\bullet} + 2e', \qquad (5.1)$$

где O_0^{\times} – кислород в регулярной позиции; $V_0^{\bullet \bullet}$ – вакансия кислорода.

При температурах ниже 700 °C в узком интервале высоких парциальных давлений кислорода $pO_2=1\cdot10^{-2}-2\cdot10^{-1}$ атм. значения электропроводности практически не зависят от парциального давления кислорода, что обусловлено
доминированием собственных атомных дефектов (см. уравнение 5.1): наблюдается область электролитической проводимости. Таким образом, в исследуемом интервале температур и парциального давления кислорода в сухой атмосфере электропроводность Ba₄In₆O₁₃ смешанная: кислородно-ионная и электронная (*n*-типа).



Рисунок 5.15 – Изотермы общей электропроводности образца Ba₄In₆O₁₃ в сухой атмосфере в зависимости от парциального давления кислорода

Во влажной атмосфере зависимости общей электропроводности от рО2 носят схожий характер с данными, полученными в сухой атмосфере (см. рисунок 5.16). В исследуемых условиях во всем интервале температур наблюдается отрицательный наклон, что говорит о наличии электронного вклада проводимости (*n*-типа). При этом тангенс угла наклона меняется с температурой немонотонно – с уменьшением температуры сначала уменьшается по абсолютному значению, как и в случае сухой атмосферы, но в области низких температур, где появляются протонные дефекты, тангенс угла наклона снова незначительно возрастает, в высоких pO_2 наблюдается уже не электролитической области.



Рисунок 5.16 – Зависимости общей электропроводности образца Ва₄In₆O₁₃ от парциального давления кислорода во влажной атмосфере

Таким образом, одновременно с появлением протонов в структуре увеличивается вклад электронного переноса. Для объяснения этого факта вспомним, что в процессе формирования протонных дефектов может быть задействованы не только вакансии кислорода, но и электронная подсистема. Так, для ионно-дырочных проводников приводится следующее квазихимическое уравнение реакции [122]:

$$H_2O + 2h^{\bullet} + 2O_0^{\times} \Leftrightarrow \frac{1}{2}O_2 + 2(OH)_0^{\bullet}, \qquad (5.2)$$

где O₀[×] – кислород в регулярной позиции; (OH)₀[•] – протон, локализованный на ионе кислорода.

Соответственно, для ионного-электронного проводника рост электронной проводимости (*n*-типа) может быть обусловлен появлением электронов по следующему квазихимическому уравнению:

$$H_{2}O + 2O_{O}^{\times} \Leftrightarrow 2OH_{O}^{\bullet} + 2e' + \frac{1}{2}O_{2}, \qquad (5.3)$$

При этом сравнительный анализ зависимостей общей электропроводности от pO_2 (см. рисунок 5.17) для $Ba_4In_6O_{13}$ в сухой и влажной атмосферах, показал выраженный рост общей электропроводности во влажной атмосфере при температурах ниже 700 °C.



Рисунок 5.17 – Зависимости общей электропроводности образца Ва₄In₆O₁₃ от парциального давления кислорода во влажной и в сухой атмосферах

Соответственно, с точки зрения квазихимического описания процессов дефектообразования в Ba₄In₆O₁₃, диаграмма Броуэра, показывающая влияние влажности, может быть представлена следующим видом:



Рисунок 5.18 — Диаграмма Броуэра, показывающая влияние pH_2O на концентрации дефектов в кислород-дефицитном оксиде (t, pO_2 =const) [124].

Таким образом, во влажной атмосфере для фазы $Ba_4In_6O_{13}$ происходит появление протонных дефектов, что также способствует смещению равновесия дефектов в область более высокого парциального давления кислорода и росту концентрации электронных носителей на воздухе ($pO_2=0.21$ атм).

147

Зависимости чисел переноса

Значения ионных чисел переноса определены методом ЭДС в сухой и Ha 5.19 влажной атмосферах. рисунке приведены зависимости экспериментально измеренных значений суммарных ионных чисел переноса в сухой и влажной атмосферах и кажущегося протонного числа переноса. В сухой и влажной атмосферах (см. рисунок 5.19а) значения чисел переноса возрастают при снижении температуры. В области высоких температур (>700 °C) значение ионного числа переноса невелико, вклад ионной проводимости в общую электропроводность не превышает 20–30%. Преобладание в этом температурном интервале электронного (*n*-типа) вклада согласуется с полученными данными общей электропроводности в зависимости от парциального давления кислорода (см. рисунок 5.19). Снижение температуры (<700 °C) приводит к смене доминирующего типа носителей тока, значительно возрастает вклад ионного переноса: при температуре 500 °C вклад ионного переноса составляет около 60%. Примечательно, что повышение парциального давления паров воды не приводит к существенному изменению ионного числа переноса, несмотря на появление протонных дефектов, что подтверждает выдвинутое нами предположение о влиянии влажности атмосферы на равновесие электронных дефектов.



Рисунок 5.19 – Температурные зависимости суммарного числа переноса ионов в атмосферах различной влажности (а) и суммарного числа переноса ионов и кажущегося числа переноса протонов во влажной атмосфере (б)

Точным подтверждением появления протонных дефектов является определение кажущегося числа протонов. На рисунке 5.196 представлена температурная зависимость t_H в сопоставлении с суммарным ионным числом переноса во влажной атмосфере. Наибольший вклад протонного переноса наблюдается при температурах ниже 700 °C, максимум достигается при 500 °C (вклад протонной общую температуре проводимости В электропроводность – 20 %). В соответствии с полученными данными по общей электропроводности во влажной атмосфере и числам переноса проведен расчет парциальных (электронной, кислородно-ионной и протонной) проводимостей (математические расчеты представлены в главе 3, раздел 3.5.1).

На рисунке 5.20 приведены температурные зависимости парциальных проводимостей в сравнении с общей электропроводностью для Ba₄In₆O₁₃ во влажной атмосфере.



Рисунок 5.20 – Температурные зависимости общей и парциальных (электронной, кислородно-ионной и протонной) проводимостей Ba₄In₆O₁₃ во влажной атмосфере

В температурном интервале 600-900 °C общая электропроводность преимущественно электронной составляющей. Снижение определяется температуры приводит к увеличению вклада ионного переноса. Кажущиеся электронного кислородно-ионного переноса энергии активации И 600–900 °C 0.60 в температурном интервале составляют 0.90 эΒ И

соответственно. Значение Е_А для кислородно-ионной проводимости сложных оксидов с перовскитоподобной структурой составляет 1.0 эВ, что несколько выше значения, полученного для Ва₄In₆O₁₃. Разница между расчетным и литературным значениями может объясняться, особенностями структуры $Ba_4In_6O_{13}$, в которой присутствуют не только перовскитные блоки "Ba₂In₂O₆", но и блоки "Ba₂In₄O₇". Для протонного вклада проводимости значение кажущейся энергии активации составляет 0.30 эВ, что, принимая во внимание ограниченный температурный участок обработки, согласуется со значением *Е*_A для прыжкового механизма переноса протонных дефектов (0.5 эВ) [1]. Таким образом, установлено, что в сухой атмосфере индат бария Ba₄In₆O₁₃ обладает смешанной проводимостью: в интервале температур 500–900 °С преимущественно электронной (*n*-типа), ниже 500 °С начинает доминировать кислородно-ионная проводимость, во влажной атмосфере в области температур ниже 500 °C доминирует ионный перенос, включающий кислородно-ионный и протонный вклады.

Сравнительная характеристика электрических свойств $Ba_2In_2O_5$ и $Ba_4In_6O_{13}$

Температурные зависимости общей электропроводности для индатов бария состава $Ba_2In_2O_5$ и $Ba_4In_6O_{13}$ представлены на рисунке 5.21а. Установлено, что значения общей электропроводности $Ba_2In_2O_5$ и $Ba_4In_6O_{13}$ сопоставимы при температурах ниже 900 °C как в сухой, так и во влажной атмосферах. На рисунке 5.216 приведены температурные зависимости ионных чисел переноса для $Ba_2In_2O_5$ и $Ba_4In_6O_{13}$ в сравнении. Характер проводимости принципиально различен: индат бария $Ba_2In_2O_5$ в сухой атмосфере смешанный кислородно-ионный и электронный (*p*-типа) проводник, вклад дырочной проводимости ниже 600 °C достигает 80%, во влажной – преимущественно ионный, протонное число переноса начинает возрастать при температурах ниже 650 °C, достигает 45% при температурах ниже 450 °C, но в низких *p*O₂, в градиенте водорода. Показано увеличение протонного числа переноса

со снижением температуры, при 100 °C $t_{\rm H}$ =0.99. Ва₄In₆O₁₃ является электронноионным проводником со значительной ионной составляющей в сухой и влажной атмосферах ниже 500 °C, суммарные ионные числа переноса в сухой и влажной атмосферах составляют ~60%.



Рисунок 5.21 – Температурные зависимости общей электропроводности в сухой (закрытые символы) и влажной (открытые символы) атмосферах (а) и кислородно-ионных (закрытые символы) и протонных (открытые символы) чисел переноса для Ba₂In₂O₅ и Ba₄In₆O₁₃ (б)

5.3.2 Электрические свойства композиционных образцов

Температурные зависимости электропроводности

Электрические свойства композиционных образцов $(1-z)Ba_2In_2O_5$: $xBa_4In_6O_{13}$ (z=0.03-0.97) исследованы методом электрохимического импеданса. На рисунке 5.22 представлен вид типичных годографов при различных температурах для образцов с z=0.03, 0.10, 0.30. Годографы представляют собой несимметричные полуокружности, исходящие из начала координат. При обработке годографов использовались эквивалентные схемы, представленные на рисунке 2.56 и 2.66 и г (см. главу 2).



(B)

Рисунок 5.22 – Типичный вид годографов импеданса для образцов (1–*z*)Ва₂In₂O₅·*z*Ba₄In₆O₁₃ при различных температурах в сухой атмосфере (а), при одной температуре для различных образцов (б) и сравнение вида в сухой (закрытые символы) и влажной (открытые символы) атмосферах (в)

Температурные зависимости общей электропроводности для композиционных образцов $(1-z)Ba_2In_2O_5 \cdot zBa_4In_6O_{13}$ (*z*=0.03–0.97) в сопоставлении с данными для $Ba_2In_2O_5$ с поправкой на пористость керамики приведены для сухой (см. рисунок 5.23а и б) и влажной атмосфере (см. рисунок 5.24а и б).



Рисунок 5.23 – Температурные зависимости общей электропроводности образцов (1-*z*)Ba₂In₂O₅·*z*Ba₄In₆O₁₃ в сухой атмосфере



Рисунок 5.24 – Температурные зависимости общей электропроводности образцов (1-*z*)Ва₂In₂O₅·*z*Ba₄In₆O₁₃ во влажной атмосфере

153

Отметим, что значения электропроводности приведены с учетом поправки на пористость образцов для корректности сравнения. Установлено, что наличие гетерогенной добавки приводит к смещению скачка электропроводности, сопровождающего структурный переход упорядоченной (орторомбической) (тетрагональную) модификацию $Ba_2In_2O_5$, в разупорядоченную в более низкотемпературную область. Значения общей электропроводности всех композиционных образцов $(1-z)Ba_2In_2O_5 \cdot zBa_4In_6O_{13}$ (z=0.03-0.970) практически во всех исследуемых условиях выше электропроводности индата бария Ba₂In₂O₅ и Ba₄In₆O₁₃. Максимальные значения электропроводности достигаются для композиционных образцов с 10 и 30 мол.% гетерогенной добавки Ва₄In₆O₁₃. На рисунке 5.25 представлены зависимости общей электропроводности этих композиционных образцов в сравнении с данными для индата бария Ba₂In₂O₅.



Рисунок 5.25 – Температурные зависимости общей электропроводности образцов (1–*z*)Ba₂In₂O₅·*z*Ba₄In₆O₁₃ в сухой и влажной атмосферах

Зависимости электропроводности при изменении парциального давления кислорода

Для понимания природы проводимости композиционных образцов $(1-z)Ba_2In_2O_5 \cdot zBa_4In_6O_{13}$ получены зависимости общей электропроводности от парциального давления кислорода в газовой фазе. При этом общая электропроводность от pO_2 изучалась для композиционных образцов с

количественным преобладанием фазы $Ba_2In_2O_5$ (состав с z=0.30). На рисунке 5.26 приведены зависимости общей электропроводности от парциального давления кислорода для образца $0.7Ba_2In_2O_5 \cdot 0.3Ba_4In_6O_{13}$. В области температур до 600– 800 °C наблюдается отрицательный тангенс угла наклона зависимостей, что может свидетельствовать о наличии вклада электронного переноса *n*-типа. При температурах ниже 600 °C общая электропроводность в сухой атмосфере не зависит от значений pO_2 , что может отражать доминирование ионного переноса. Во влажной атмосфере наблюдается более выраженный отрицательный наклон полученных зависимостей общей электропроводности, свидетельствующий о большем вкладе электронной (*n*-типа) проводимости при повышении влажности.



Рисунок 5.26 – Изотермические зависимости общей электропроводности от парциального давления кислорода для 0.7Ba₂In₂O₅·0.3Ba₄In₆O₁₃ в сухой (закрытые символы) и влажной (открытые символы) атмосфере

Сходные закономерности зависимости электропроводности от *p*O₂ были Общая выявлены для фазы $Ba_4In_6O_{13}$. электропроводность образца 0.7Ва₂In₂O₅·0.3Ва₄In₆O₁₃ при температурах выше ~900 °С практически не зависит от парциального давления кислорода в сухой и влажной атмосферах, что может свидетельствовать о преимущественно ионном переносе и обусловлено преобладанием фазы Ba₂In₂O₅. На температурной зависимости (см. рисунки 5.24 -5.26а) при этих значениях температуры наблюдается скачок проводимости изза структурного перехода $Ba_2In_2O_5$ В разупорядоченное состояние (тетрагональную модификацию).

Таким образом, можно предполагать, что композиционные образцы в сухой атмосфере при температурах ниже 600 °С являются преимущественно ионными проводниками. Во влажной атмосфере возрастает общая проводимость, но при этом увеличивается вклад переноса электронов.

Зависимости чисел переноса

На рисунке 5.27 приведены зависимости экспериментально измеренных значений суммарных ионных чисел переноса в сухой и влажной атмосферах и кажущегося протонного числа переноса для композита $0.7Ba_2In_2O_5 \cdot 0.3Ba_4In_6O_{13}$. В сухой и влажной атмосферах (см. рисунок 5.27а) значения чисел переноса возрастают при снижении температуры. В области высоких температур (>700 °C) значение ионного числа переноса невелико, вклад ионной проводимости в общую электропроводность не превышает 20% в сухой и во влажной атмосферах. В сухой атмосфере при температуре ниже 600 °С ионный транспорт начинает доминировать, при температуре 450 °C ионное число переноса достигает 95%. Рассмотрение природы исходных Ba₂In₂O₅ и Ba₄In₆O₁₃ позволяет предполагать преимущественно кислородно-ионную проводимость для композиционного электролита. Во влажной атмосфере суммарное ионное число переноса ниже и достигает 45% при 450 °C, основной вклад проводимости электронными дефектами. На рисунке 5.276 определяется представлена температурная зависимость t_H в сопоставлении с суммарным ионным числом переноса во влажной атмосфере. Вклад протонной проводимости появляется при

температурах ниже 650 °C и достигает максимума при 450 °C (вклад протонной проводимости в общую электропроводность ~15%).



Рисунок 5.27 – Температурные зависимости суммарного числа переноса ионов в атмосферах различной влажности (а) и суммарного числа переноса ионов и кажущегося числа переноса протонов во влажной атмосферы (б) образца 0.7Ba₂In₂O₅·0.3Ba₄In₆O₁₃

Таким образом, композиционные образцы по характеру проводимости в большей степени сходны с фазой Ba₄In₆O₁₃ и являются ионно-электронными проводниками. В сухой атмосфере носителями заряда являются ионы кислорода и электроны, ионная проводимость начинает доминировать при температурах ниже 600 °C. Во влажной атмосфере заряд переносят ионы кислорода, протоны и электроны, в области средних температур вклад ионных и электронных носителей почти одинаков.

Концентрационные зависимости электропроводности образцов

На рисунке 5.28 представлены концентрационные зависимости общей проводимости для образцов $(1-z)Ba_2In_2O_5 \cdot zBa_4In_6O_{13}$ (z=0.00-1.00). Концентрационная зависимость носит немонотонный характер с выраженным максимумом. Электропроводность образца с z=0.33 ниже по сравнению с проводимостью исходных $Ba_2In_2O_5$ и $Ba_4In_6O_{13}$, что обусловлено высокой плотностью полученной керамики. Сложный характер концентрационный зависимости обусловлен разной природой проводимости исходных $\phi_{a3}Ba_2In_2O_5$ (ионно-дырочный проводник) и $Ba_4In_6O_{13}$ (ионно-электронный проводник). В

зависимости от мольного соотношения исходных компонентов в составе композита и от *p*H₂O и температуры меняются вклады ионной (кислородно-ионной и протонной) и электронной (*n*- и *p*-типа) проводимости.



Рисунок 5.28 – Концентрационные зависимости общей электропроводности образцов (1–*z*)Ва₂In₂O₅·*z*Ba₄In₆O₁₃ в сухой (а) и во влажной (б) атмосферах

Ha 5.29a представлена рисунке концентрационная зависимость кислородно-ионных чисел переноса в сухой атмосфере. Для композиционного образца с z=0.30 показан рост ионного вклада проводимости по сравнению с исходными Ba₂In₂O₅ и Ba₄In₆O₁₃. На рисунке 5.296 приведена зависимость ионной проводимости в сухой атмосфере для данного композита в сравнении с исходными фазами. Можно видеть, что в области температур ниже 600 °С величина ионной проводимости для композита также возрастает, разница значений составляет до 1/2 порядка величины. Увеличение вклада и величины ионной проводимости в сухой атмосфере, вероятно, можно ожидать для всех композиционных образцов, что и определяет рост их общей проводимости. Таким образом, что в системе Ba₂In₂O₅-Ba₄In₆O₁₃ наблюдается композиционный эффект проводимости. К причинам возникновения КЭ можно отнести образование более дефектного слоя на контакте фаз Ba₂In₂O₅ и Ba₄In₆O₁₃, что способствует увеличению подвижности ионных носителей и, соответственно, приводит к росту ионной проводимости.



Рисунок 5.29 – Концентрационные зависимости кислородно-ионных чисел переноса (а) и ионной электропроводности (б) образцов (1–*z*)Ba₂In₂O₅·*z*Ba₄In₆O₁₃ в сухой атмосфере

Анализ результатов, полученных во влажной атмосфере, более сложен, поскольку появление протонных дефектов, как было выявлено, сопряжено с ростом концентрации электронных дефектов и увеличением электронной составляющей проводимости. Ионные числа переноса во влажной атмосфере для композита снижаются в сравнении с Ba₄In₆O₁₃, величина ионной проводимости почти не изменяется, либо незначительно снижается (см. рисунок 5.30).



Рисунок 5.30 – Концентрационные зависимости суммарных ионных чисел переноса (черные символы) и ионной электропроводности (серые символы) образцов (1–*z*)Ba₂In₂O₅·*z*Ba₄In₆O₁₃ во влажной атмосфере

159

Следует предположить, что рост общей проводимости во влажной атмосфере связан, с увеличением вклада и величины электронного переноса. Фаза $Ba_2In_2O_5$ способна к внедрению воды, это приводит к увеличению концентрации протонных дефектов в композитах, по сравнению с $Ba_4In_6O_{13}$, что может способствовать росту концентрации электронных носителей в области контакта двух фаз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проводимость ионных соединений – солей, а также оксидных и сложнооксидных фаз – в большинстве случаев увеличивается при их гетерогенном допировании дисперсным диэлектриком, химически инертным по отношению к базовой матрице [26–70]. При этом соотношение вкладов поверхностных и объемных свойств для фазы-допанта имеет очень большое значение [33, 34]. В связи с этим, свойства композиционных электролитов в большей степени определяются морфологией частиц гетерогенного допанта и характером взаимодействия компонентов композита на поверхности раздела фаз. Использование эвтектических систем «матричная фаза–гетерогенный допант» для получения композиционных электролитов позволяет, с одной стороны, обеспечить химическую инертность этих фаз (на макроскопическом уровне), а с другой – дает возможность, варьируя способ термообработки, получить композиционный электролит с особой микроструктурой, отличной от структуры матричной фазы, которая формируется в процессе кристаллизации эвтектики.

Обобщая литературный материал по описанию композиционного эффекта (КЭ) увеличения проводимости электролитов при гетерогенном допировании, можно выделить несколько основных типов морфологических особенностей композиционных электролитических систем. На рисунках 6.1–6.3 приведены схемы, иллюстрирующие различные механизмы образования особой микроструктуры композиционных твердых электролитов.

Так, например, причиной возникновения композиционного эффекта «ионная соль-простой/сложный проводимости в системах оксид» ИЛИ «простой/сложный оксид-соль» (см. рисунок 6.1) является твердофазное растекание и/или аморфизация солевой фазы по другому компоненту композиционного электролита [51, 60-62, 125, 126] (более подробное описание представлено в главе 1). Для систем «ионная соль-простой/сложный оксид» высокотемпературной происходит стабилизация (ВТ-модификации) И, соответственно, высокопроводящей модификации ионной соли.



Причина КЭ: стабилизация ВТ-модификации ионной соли Рисунок 6.1 – Схема образования различной микроструктуры композиционных электролитов – а, СЭМ-изображение, система и источник – б

В композиционных электролитах на основе молибдатов и вольфраматов $M(Mo,W)O_4$ -(Mo,W)O₃ и $M_2(WO_4)_3$ -WO₃ при твердофазном растекании и формировании композита с матричной распределенной структурой В межзеренном пространстве между базовой фазой и гетерогенным допантом наблюдается образование новой неавтономной высокопроводящей поверхностной микрофазы иного состава по сравнению с исходными фазами [80, 127], что определяет значительное увеличение ионной проводимости композиционных образцов. Образование неавтономной высокопроводящей поверхностной микрофазы иного состава наблюдалось также в системе La₂Mo₂O₉–La₂Mo₃O₁₂[70] даже в отсутствии твердофазного растекания, но лишь в местах контакта зерен двух фаз (см. рисунок 6.2).



(б)

Причина КЭ: образование новой высокопроводящей фазы, отличной по составу от исходных фаз

Рисунок 6.2 – Схема образования различной микроструктуры композиционных электролитов – а, СЭМ-изображение, система и источник – б

Для композиционных эвтектических систем с базовой фазой индата бария $Ba_2In_2O_5$ и твердых растворов на его основе с различными сложнооксидными гетерогенными допантами, изученными в настоящей работе, установлено наличие композиционного эффекта. Показано, что основным фактором, объясняющим природу возникновения композиционного эффекта, является формирование кристаллитов с повышенной степенью дефектности (степенью разупорядочения в кислородно-ионной подрешетке), как результат изменения морфологии и микроструктуры композиционных образцов при обработке выше температуры эвтектики (см. рисунок 6.3). Обработка композиционных образцов при температуре выше эвтектики ($t_{3вт}$) приводит к образованию и последующей кристаллизации расплава эвтектического состава. Процесс кристаллизации

сопровождается образованием на поверхности и в объеме основной фазы кристаллитов субмикронных размеров, при этом возможна стабилизация высокопроводящих модификаций. Для Ba₂In₂O₅ установлено, что увеличение стабилизации дисперсности зерен приводит К высокотемпературной И даже кубической модификации Ва₂In₂O₅ с полным тетрагональной разупорядоченным состоянием в кислородно-ионной подрешетке [102].

Схема изменения микроструктуры:



Причина КЭ: образование кристаллических разупорядоченных фаз при кристаллизации эвтектики с размером зерен субмикронного размера Рисунок 6.3 – Схема образования различной микроструктуры композиционных электролитов – а, СЭМ-изображение и система – б

(б)

На рисунках 6.4–6.7 приведены концентрационные зависимости относительной общей или ионной проводимостей для изученных в работе композиционных эвтектических образцов на основе систем $Ba_2In_2O_5$ – Ba_2InNbO_6 , $Ba_2In_2O_5$ – Ba_2InAlO_5 и $Ba_2In_2O_5$ – $Ba_4In_6O_{13}$. Для каждой системы показан эффект увеличения проводимости как общей, так и ионной (см. рисунок 6.2). Стоит

отметить, что экспериментальные значения электропроводности для композиционных образцов не являются суммой проводимостей базовой фазы и фазы-допанта с учетом их объемной доли (см. уравнение 3.14).



Рисунок 6.4 – Концентрационные зависимости общей относительной электропроводности (относительно индата бария Ba₂In₂O₅ – а, относительно граничного твердого раствора при возможности его образования – б) образцов в сухой атмосфере воздуха при температуре 500 °C

Наибольший эффект увеличения проводимости достигается для системы $Ba_2In_2O_5-Ba_2InNbO_6$ (см. рисунок 6.5) как по сравнению с $Ba_2In_2O_5$ (для образцов с $t_{oбp}=1300$ °C эффект увеличения общей проводимости составляет 1 порядок величины, ионной – 1.75; для образцов с $t_{oбp}=1400$ °C общая проводимость выше на 1.75 порядка величины, ионная на 2.5), так и по сравнению с формирующимся в квазибинарной системе граничным твердым раствором состава $Ba_2In_{1.95}Nb_{0.05}O_5$ (для образцов с $t_{oбp}=1300$ °C эффект увеличения общей и ионной проводимости составляет около 0.5 порядка; для образцов с $t_{oбp}=1400$ °C общая и ионная проводимость выше на ~1.25 порядка величины) при 500 °C. Значительный эффект увеличения проводимости для образцов с $t_{oбp}=1400$ °C можно объяснить следующим механизмом: при кристаллизации расплава эвтектического состава

происходит стабилизация тетрагональной модификации базовой фазы. Однако, эффект увеличения проводимости (хотя и менее выраженный) наблюдается и для для образцов с t_{obp} =1300 °C, то есть, ниже эвтектики. Можно предполагать, что термообработка образцов высокотемпературная приводит частичной к стабилизации высокодефектных состояний, близких структуре по К разупорядоченной высокопроводящей фазе, при этом РФА-исследования не позволяют установить их наличие вследствие незначительного количества.



Рисунок 6.5 – Концентрационные зависимости общей и ионной относительной электропроводности (относительно индата бария $Ba_2In_2O_5 - a$, относительно $Ba_2In_{1.95}Nb_{0.05}O_{5.05} - b$) для образцов с гетерогенным допантом Ba_2InNbO_6 в сухой атмосфере при 500 °C. Штрихпунктирная линия – модельная концентрационная зависимость ионной проводимости композиционных образцов, расчет по уравнению смешения (см. уравнение 3.14)

В системе Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅–Ba₂InAlO₅ для образцов с *t*_{обр}=1270 °C эффект увеличения проводимости (см. рисунок 6.6) по сравнению с Ba₂In₂O₅ достигает 1.25 порядка величины общей и 1.6 порядка величины ионной проводимости при 500°C. По сравнению с Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ увеличение общей проводимости достигает 0.2 порядка величины, ионной – 0.6 при 500 °C. В отличие от системы

Ва₂In_{1.95}Nb_{0.05}O_{5.05}–Ва₂InNbO₆ с очень узкой областью гомогенности, в которой сохраняется низкотемпературная модификация индата бария, замещение индия на алюминий реализуется в достаточно широких концентрациях, и стабилизация тетрагональной модификации происходит уже в пределах области гомогенности. Ни в одной из изученных систем нами не было обнаружено присутствие кубической модификации, возможно, по причине достаточно сложной задачи ее идентификации из рентгеновских данных. Тем не менее, в композитах Ва₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅–Ba₂InAlO₅ наблюдается повышение проводимости. Вероятно, нельзя исключать образование высокодефектных состояний, близких по структуре к разупорядоченной высокопроводящей кубической фазе, что является причиной роста электропроводности.



Рисунок 6.6 – Концентрационные зависимости общей и ионной относительной электропроводности (относительно индата бария Ba₂In₂O₅ – а, относительно Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅ – б) для образцов с гетерогенным допантом Ba₂InAlO₅ в сухой атмосфере при 500 °C. Штрихпунктирная линия – модельная концентрационная зависимость ионной проводимости композиционных образцов, расчет по уравнению смешения (см. уравнение 3.14)

В системе Ba₂In₂O₅–Ba₄In₆O₁₃ для образцов с t_{obp} =1300 °C, что ниже температуры эвтектики, эффект увеличения проводимости (см. рисунок 6.7) по сравнению с Ba₂In₂O₅ достигает 0.25 порядка величины общей и 0.6 порядка величины ионной проводимости при 500 °C. При этом, обращая внимание на различие природы проводимости исходных Ba₂In₂O₅ и Ba₄In₆O₁₃ (ионные проводники с электронным вкладом *p*- и *n*-типа, соответственно), необходимо сделать акцент на изменении именно ионной проводимости композиционных образцов. Введение гетерогенного допанта обусловливает увеличение ионной проводимости композиционных образцов.



Рисунок 6.7 – Концентрационные зависимости общей и ионной относительной электропроводности для образцов с гетерогенным допантом Ba₄In₆O₁₃ в сухой атмосфере при 500 °C. Штрихпунктирная линия – модельная концентрационная зависимость ионной проводимости композиционных образцов, расчет по уравнению смешения (см. уравнение 3.14)

Таким образом, показано, что формирование композиционных электролитов на основе квазибинарных эвтектических сложнооксидных систем приводит увеличению ионной проводимости К И возникновению композиционного эффекта. В процессе термообработки композитов происходит изменение микроструктуры и образование разупорядоченных кристаллических фаз субмикронного размера. Величина эффекта увеличения проводимости определяется как особой морфологией композитов, формирование которой происходит в результате кристаллизации эвтектического расплава, так и возможностью стабилизации высокотемпературных модификаций базовой кристаллической матрицы. Природа гетерогенного допанта влияет на величину композиционного эффекта, так как определяет состояние и относительную долю кристаллических разупорядоченных фаз, кроме того, позволяет снизить величину и долю электронной проводимости.

Проведенные исследования показали перспективность метода гетерогенного допирования для эвтектических сложнооксидных систем, который позволяет получить высокопроводящие (кислородно-ионные и протонные) электролиты с контролируемыми для возможных рабочих условий характеристиками. В целом, можно сказать, что наблюдается корреляция свойств различных неорганических систем по изменению их объемных свойств при переходе в высокодисперсное состояние.

выводы

В настоящей работе было проведено комплексное исследование свойств компо-зиционных эвтектических образцов на основе $Ba_2In_2O_5$ и твердых растворов на его основе с различными гетерогенными допантами (Ba_2InNbO_6 , Ba_2InAlO_5 и $Ba_4In_6O_{13}$). В соответствии с полученными результатами сформулированы основные выводы:

1. Установлены оптимальные условия приготовления композиционных образцов. Ключевую роль формировании свойств В композиционных эвтектических электролитов играет температура обработки керамики, это значительно отражается на микроструктуре композиционных образцов. При этом использование разных методов получения композиционных образцов (метод in situ. при одновременном твердофазном синтезе исходных компонентов, или метод смешения из исходных компонентов с различной предысторией синтеза) позволяет шире влиять на микроструктуру образцов, соответственно, на оптимизацию их свойств.

2. Впервые изучены термические свойства композиционных образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6$, $(1-z)Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 zBa_2InAlO_5$ и $(1-z)Ba_2In_2O_5 zBa_4In_6O_{13}$. Установлено, что все изученные образцы способны к диссоциативному инкорпорированию паров воды из газовой фазы, количество воды определяется только содержанием основной фазы композиционного образца.

3. Изучены электрические свойства композиционных образцов $(1-x)Ba_2In_2O_5 xBa_2InNbO_6$, $(1-z)Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5 zBa_2InAlO_5$ и $(1-z)Ba_2In_2O_5 zBa_4In_6O_{13}$. Установлен композиционный эффект проводимости для всех образцов как в сухой, так и во влажной атмосфере. Величина композиционного эффекта общей электропроводности для системы $Ba_2In_2O_5$ - Ba_2InNbO_6 составляет 1–2 порядка величины, для систем $Ba_2In_{1.57}Al_{0.43}O_5$ - Ba_2InAlO_5 и $Ba_2In_2O_5$ - $Ba_4In_6O_{13}$ примерно 1/4 порядка величины. Для всех композиционных образцов наблюдается увеличение доли кислородно-ионной проводимости в сухой атмосфере по сравнению с проводимостью для матричной

фазы и гетерогенной добавки. Для композиционных образцов в системах Ba₂In₂O₅–Ba₂InNbO₆ и Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅–Ba₂InAlO₅ также наблюдается повышение вклада ионного (суммарного кислородно-ионного и протонного) переноса во влажной атмосфере.

4. Установлена взаимосвязь электропроводности «величина Композиционный композиционного электролита-метод приготовления». эффект проводимости наблюдается для композиционных эвтектических образцов с температурой обработки как ниже, так и выше температуры эвтектики. При этом величина композиционного эффекта проводимости для композиционных образцов с температурой обработки выше эвтектической больше. Причиной увеличения существенно проводимости является формирования межфазных возможность границ с разупорядоченным состоянием.

5. На примере композиционных образцов в системах Ba₂In₂O₅– Ba₂InNbO₆ и Ba₂In_{1.57}Al_{0.43}O₅–Ba₂InAlO₅ показана взаимосвязь между величиной композиционного эффекта и структурой матричной фазы. Для матричной фазы при создании композита происходит стабилизация высокотемпературной модификации, что значимо отражается на увеличении электропроводности.

6. На примере композиционных образцов в системах Ba₂In₂O₅– Ba₂InNbO₆ и Ba₂In₂O₅–Ba₄In₆O₁₃ показана взаимосвязь между величиной композиционного эффекта и природой электропроводности гетерогенного допанта. Композиционный эффект проводимости сопровождается увеличением ионной проводимости композиционных образцов и не зависит от электрической природы гетерогенного допанта.

7. Получение композиционных образцов в системе Ba₂In₂O₅– Ba₂InNbO₆ способствует увеличению химической стойкости образцов как результат кинетических затруднений карбонизации керамики из-за наличия эффекта капсулирования матричной фазы.

8. Проведено тестирование керамики состава (1-*x*)Ва₂In₂O₅·*x*Ва₂InNbO₆ (*x*=0.20, 0.30) в качестве электролита для сенсора

влажности. Высокая чувствительностью проводимости к присутствию паров воды в атмосфере, стабильные и воспроизводимые характеристики, хорошая обратимость значений при смене pH_2O позволяют рекомендовать данный состав для создания высокотемпературного пароводяного сенсора резистивного типа в интервале рабочих температур 400–500 °C, $3.5 \cdot 10^{-3} \le pH_2O \le 2 \cdot 10^{-2}$ атм, при $pO_2=0.21$ атм.

Перспективы дальнейшей разработки темы

Дальнейшая работа в продолжение настоящей исследовательской работы будет связана с изучением композиционных электролитов на основе эвтектических систем «сложный оксид–сложный оксид». Ввиду ограниченности уже описанных подобных композиционных систем их изучение несколько затруднено. При этом интерес представляет расширение базы по влиянию природы (как химической природы, так и природы проводимости) гетерогенного допанта на свойства матричной фазы и, как следствие, композиционных электролитов. Также интересен механизм изменения микроструктурных и морфологических свойств В композиционных электролитах, которые сопутствуют увеличению именно кислородно-ионного и протонного вклада проводимости И, соответственно, величине композиционного эффекта проводимости. В перспективе расширение изученности этой темы приведет к получению композиционного эвтектического электролитического материала с набором рабочих оптимальным характеристик (высокими ионной механической прочностью, термической и проводимостью, химической стабильностью) использования В лля его качестве материала ЛЛЯ электролитической мембраны твердооксидного топливного элемента.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

- *a*, *b*, *c*, *α*, *β*, *γ* параметры элементарной ячейки
 - *г* радиус атома (кристаллический или ионный по Шеннону [106]); Å
 - τ время; с, мин
 - СЭМ сканирующая электронная микроскопия
 - ДСК дифференциальная сканирующая калориметрия
 - КР спектроскопия комбинационного рассеивания
 - ИК инфракрасный спектроскопия
 - ТГ термогравиметрический анализ
 - пр.гр. пространственная группа
 - ф объемная доля
 - ат.% атомная доля
 - *х, у, z* мольная доля
 - мол.% мольная доля
 - ω массовая доля
 - мас.% массовая доля
 - t температура, °С
 - *t*_{эвт} температура эвтектики квазибинарной системы, °С

t _{obp}	– температура	обработки	керамических	образцов,	°C
oop	1 /1	1	1	1 7	

Т – температура, К

t – суммарное число переноса

t_{ион} – ионное число переноса

t_{O2}. – кислородно-ионное число переноса

t_н – протонное число переноса

обозначение исходного компонента композиционного
 образца, полученного по твердофазной технологии

обозначение исходного компонента композиционного
 образца, полученного по растворной технологии

обозначение композиционного образца, приготовленного
 (тт) методом смешения из синтезированных по твердофазной технологии исходных компонентов

обозначение композиционного образца, приготовленного
 методом смешения из синтезированных по твердофазной и
 растворной технологиям матричной фазы и гетерогенного
 допанта, соответственно

метод приготовления композиционного образца, при котором
 in situ происходит одновременный синтез исходных компонентов в
 peakционной смеси

*p*H₂O – парциальное давление паров воды, атм

*p*O₂ – парциальное давление кислорода, атм

Р^к − кажущаяся плотность, г/см³

плотность жидкости, в которой производится
 ρ_ж
 гидростатическое взвешивание, г/см³

 $\rho_{\text{ист}}$ – истинная плотность, г/см³

 $\rho_{\text{отн}},\,\rho_{\text{отн (гидр)}}$ — относительная плотность, %

m_i	— масса, г		
$\Pi_{ m 3akp}$	– закрытая пористость, %		
$\Pi_{\mathrm{откp}}$	– открытая пористость, %		
$\Pi_{ m oбщ}$	– общая пористость, %		
R	– сопротивление, Ом		
С	– емкость, Ф		
$\sigma_{ m o m b m}$	– общая электрическая проводимость, Ом ⁻¹ см ⁻¹		
σ_{noh}	– ионная проводимость, Ом ⁻¹ см ⁻¹		
$(\sigma_{\text{ион}})^{cyx}$	– ионная проводимость в сухой атмосфере, Ом- ¹ см- ¹		
$(\sigma_{\text{ион}})^{\text{вл}}$	– ионная проводимость во влажной атмосфере, Ом ⁻¹ см ⁻¹		
σ_h	– дырочная (<i>p</i> -типа) проводимость, Ом ⁻¹ см ⁻¹		
σ_e	– электронная (<i>n</i> -типа) проводность, Ом ⁻¹ см ⁻¹		
σ ₀₂₋	– кислородно-ионная проводимость, Ом ⁻¹ см ⁻¹		
$\sigma_{\rm H}$	– протонная проводимость, Ом ⁻¹ см ⁻¹		
E_A	– энергия активации, эВ		
$C_{\mathrm{H^+}}$	– подвижность протонных дефектов, 1/см ³		
Z"	– сопротивление действительной части спектра импеданса, Ом		
Z'	– сопротивление мнимой части спектра импеданса, Ом		
μ_{H^+}	– подвижность протонных дефектов, см ² /(B·c)		

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Анимица И. Е., Кочетова Н. А., Нейман А. Я. Материалы для водородной энергетики. – Изд-во Уральского ун-та, 2009.

 Rolle A., Giridharan N. V., Roussel P. et al. Oxide Ion Conduction in Oxygen Rich Doped Ba₂In₂O_{5+δ} Brownmillerite // MRS Online Proceedings Library (OPL). – 2004. – V. 835.

3. Speakman S. A., Richardson J. W., Mitchell B. J. et al. In-situ diffraction study of Ba₂In₂O₅ // Solid State Ionics. – 2002. – V. 149, № 3-4. – P. 247–259.

4. Ito S., Mori T., Yan P. et al. High electrical conductivity in $Ba_2In_2O_5$ brownmillerite based materials induced by design of a Frenkel defect structure // RSC Advances. - 2017. - V. 7, No 8. - P. 4688-4696.

5. Fisher W., Reck G., Schober T. Structural transformation of the oxygen and proton conductor Ba₂In₂O₅ in humid air: an in-situ X-ray powder diffraction study // Solid State Ionics. – 1999. – V. 116, № 3-4. – P. 211–215.

6. Gregory D. H., Weller M. T. Phases in the System Ba₂M_{2-x}Cu_xO_{4+d}, M= In,
Sc Structure and Oxygen Stoichiometry // Journal of Solid State Chemistry. – 1993.
– V. 107, № 1. – P. 134–148.

 Fischer W., Reck G., Schober T. Phase Transition of Ba₂In₂O₅ in Humid Air Studied by In-Situ X-Ray Powder Diffraction // Materials Science Forum. – Trans Tech Publications Ltd, 2000. – V. 321. – P. 363–367.

 Shin J. F., Orera A., Apperley D. C. et al. Oxyanion doping strategies to enhance the ionic conductivity in Ba₂In₂O₅ // Journal of Materials Chemistry. – 2011.
 V. 21, № 3. – P. 874–879.

9. Tenailleau C., Pring A., Moussa S. M. et al. Composition-induced structural phase transitions in the $(Ba_{1-x}La_x)_2In_2O_{5+x}$ ($0 \le x \le 0.6$) system // Journal of Solid State Chemistry. – 2005. – V. 178. – P. 882–891.

10. Noirault S., Celerier S., Joubert O. et al. Water incorporation into the $(Ba_{1-x}La_x)_2In_2O_{5+x-1-x}$ ($0 \le x \le 0.6$) system // Solid State Ionics. - 2007. - V. 178, No 23-24. - P. 1353-1359.

11. Shin J.F., Apperley D.C., Slater P.R.: Silicon doping in $Ba_2In_2O_5$: Example of a beneficial effect of silicon incorporation on oxide ion/proton conductivity // Chemistry of Materials. – 2010. – V. 22, No 21. – P. 5945–5948.

12. Kochetova N. A., Alyabysheva I. V., Belova K. G. et al. Thermal and spectroscopic properties of $Ba_2In_{2-x}W_xO_{5+3x/2}$ solid solutions // Inorganic Materials. – 2015. – V. 51, No 11. – P. 1120–1126.

Mancini A., Shin J. F., Orera A. et al. Insight into the local structure of barium indate oxide-ion conductors // Dalton Transactions. – 2012. – V. 41, № 1. – P. 50–53.

Martinez J. R., Mohn C. E., Stølen S. et al. Ba₂In₂O₄(OH)₂: Proton sites, disorder and vibrational properties // Journal of Solid State Chemistry. – 2007. – V. 180, № 12. – P. 3388–3392.

 Schober T., Friedrich J., Krug F. Phase transformation in the oxygen and proton conductor Ba₂In₂O₅ in humid atmospheres below 300°C // Solid State Ionics.
 – 1997. – V. 99, № 1-2. – P. 9–13.

16. Hashimoto T., Inagaki Y., Kishi A. et al. Absorption and secession of H_2O and CO_2 on $Ba_2In_2O_5$ and their effects on crystal structure // Solid State Ionics. – 2000. - V. 128, No 1-4. – P. 227–231.

17. Zhang G. B., Smyth D. M. Protonic conduction in $Ba_2In_2O_5$ // Solid State Ionics. – 1995. – V. 82, No 3-4. – P. 153–160.

18. Zhang G. B., Smyth D. M. Defects and transport of the brownmillerite oxides with high oxygen ion conductivity $-Ba_2In_2O_5$ // Solid State Ionics. -1995. - V. 82, No 3-4. -P. 161-172.

19. Noirault S., Quarez E., Piffard Y. et al. Water incorporation into the $Ba_2(In_{1-x}M_x)_2O_5$ (M = Sc³⁺ 0 \leq x < 0.5 and M = Y³⁺ 0 \leq x < 0.35) system and protonic conduction // Solid State Ionics. – 2009. – V. 180, No 20-22. – P. 1157–1163.

20. Hideshima N., Hashizume K. Effect of partial substitution of In by Zr, Ti and Hf on protonic conductivity of BaInO_{2.5} // Solid State Ionics. – 2010. – V. 181, № 37-38. – P. 1659–1664.

21. Animitsa I., Tarasova N., Filinkova Ya. Electrical properties of the fluorine-doped $Ba_2In_2O_5$ // Solid State Ionics. – 2012. – V. 207. – P. 29–37.

22. Yamamura H., Yamada Y., Mori T. et al. Order-disorder transition of oxygen vacancy in brawnmillerite system // Solid State Ionics. – 1998. – V. 108. – P. 377–381.

23. Ta T. Q., Tsuji T., Yamamura Y. Thermal and electrical properties of $Ba_2In_2O_5$ substituted for In site by rare earth elements // Journal of Alloys and Compounds. – 2006. – V. 408. – P. 253–256.

24. Kochetova N., Alyabysheva I., Animitsa I. Composite proton-conducting electrolytes in the Ba₂In₂O₅–Ba₂InTaO₆ system // Solid State Ionics. – 2017. – V. 306. – P. 118–125.

25. Алябышева И. В. Транспортные и термические свойства моно-и гетерофазных составов на основе Ba₂In₂O₅: дис... канд. хим. наук. – Екатеринбург, 2013. – 147 с.

26. Liang C. C. Conduction characteristics of the lithium iodide-aluminum oxide solid electrolytes // Journal of the Electrochemical Society. – 1973. – V. 120, № 10. – P. 1289–1298.

27. Mateyshina Yu., Alekseev D., Uvarov N. The effect of the nanodiamonds additive on ionic conductivity of silver iodide // Materials Today: Proceedings. – 2020. – V. 25. – P. 373–376.

28. Alekseev D. V., Mateyshina Yu. G., Komarov V. Yu. et al. Synthesis and characterization of solid composite electrolytes LiClO₄ – Nanodiamonds // Materials Today: Proceedings. – 2020. – V. 31. – P. 576–579.

29. Ponomareva V. G., Shutova E. S., Lavrova G. V. Electrical conductivity and thermal stability of $(1-x)CsH_2PO_4/xSiPyO_z$ (x = 0.2-0.7) composites // Inorganic Materials-2008. – V. 44. – P. 1009–1014.

30. Muroyama H., Matsui T., Kikuchi R. et al. Influence of the supporting matrix on the electrochemical properties of $CsH_5(PO_4)_2$ composites at intermediate temperatures // The Journal of Physical Chemistry C. – 2008. – V. 112, No 39. – P. 15532–15536.

31. Matsui T., Kukino, T., Kikuchi R. et al. Composite effects of silicon pyrophosphate as a supporting matrix for $CsH_5(PO_4)_2$ electrolytes at intermediate temperatures // Electrochimica acta. – 2006. – V. 51, No 18. – P. 3719–3723.

32. Kikuchi R., Ogawa A., Matsuoka T. et al. Interfacial conduction mechanism of cesium hydrogen phosphate and silicon pyrophosphate composite electrolytes for intermediate-temperature fuel cells // Solid State Ionics. – 2016. – V. 285. – P. 160–164.

 Уваров Н. Ф. Композиционные твердые электролиты. – Изд-во Сибирского отд-ния РАН, 2008. – 258 с.

34. Лаврова Г. В. Протонные композиционные электролиты на основе гидросульфатов щелочных металлов : дис... канд. хим. наук. – Новосибирск, 2001. – 157 с.

35. Ponomareva V. G., Lavrova G. V. Influence of dispersed TiO₂ on protonic conductivity of CsHSO₄ // Solis State Ionics. – 1998. – V.106. – P. 137–141.

36. Ponomareva V. G., Shutova E. S. High-temperature behavior of CsH₂PO₄ and CsH₂PO₄–SiO₂ composites // Solid State Ionics. – 2007. – V. 178, № 7-10. – P. 729–734.

37. Chang M. R., Shahi K., Wagner Jr J. B. The Effect of Particle Size on the Electrical Conductivity of CuCl (Al₂O₃) Composites // Journal of the Electrochemical Society. – 1984. – V. 131, № 5. – P. 1213.

Френкель Я. И. Кинетическая теория жидкостей. – Изд-во АН СССР,
 1959. – 460 с.

39. Kliewer K. L., Koehler J. S. Space charge in ionic crystals. I. General approach with application to NaCl. // Physical Review. – 1965. – V. 140, № 4A. – P. A1226–1240.

40. Kliewer K. L. Space charge in ionic crystals—III. Silver halides containing divalent cations // Journal of Physics and Chemistry of Solids. – 1966. – V. 27, № 4. – P. 705–717.

41. Kliewer K. L. Space charge in ionic crystals – IV. Interstitial-producing impurities in the silver halides. // Journal of Physics and Chemistry of Solids. – 1966. – V. 27, N_{2} 4. – P. 719-725.

42. Лифшиц И. М., Гегузин Я. Е. Поверхностные явления в ионных кристаллах // ФТТ. – 1965. – Т. 7, № 1. – С. 62–74.

43. Лифшиц И. М., Косевич А. М., Гегузин Я. Е. Поверхностные явления и диффузионный механизм движения дефектов в ионных кристаллах // Поверхностная диффузия и растекание – 1969. – С. 243–263.

44. Maier J. Space charge regions in solid two-phase systems and their conduction contribution—I. Conductance enhancement in the system ionic conductor-'inert'phase and application on AgCl:Al₂O₃ and AgCl:SiO₂ // Journal of Physics and Chemistry of Solids. – 1985. – V. 46, No 3. – P. 309–320.

45. Maier J. Enhancement of the Ionic Conductivity in Solid-Solid-Dispersions by Surface Induced Defects // Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie. – 1984. – V. 88, № 11. – P. 1057–1062.

46. Maier J. Heterogeneous doping of silver bromide (AgBr:Al₂O₃) // Materials research bulletin. – 1985. – V. 20, N_{2} 4. – P. 383–392.

47. Maier J., Reichert B. Ionic Transport in Heterogeneously and Homogeneously Doped Thallium (I)-Chloride // Berichte der Bunsengesellschaft für physikalische Chemie. – 1986. – V. 90, № 8. – P. 666–670.

48. Jow T., Wagner J. B. The effect of dispersed alumina particles on the electrical conductivity of cuprous chloride // Journal of the Electrochemical Society. – 1979. – V. 126, № 11. – P. 1963–1972.

49. Maier J. Defect chemistry and conductivity effects in heterogeneous solid electrolytes // Journal of The Electrochemical Society. – 1987. – V. 134, № 6. – P. 1524–1535.

50. Maier J. Ionic conduction in space charge regions // Progress in solid state chemistry. – 1995. – V. 23, № 3. – P. 171–263.
51. Lavrova G. V., Shutova E. S., Ponomareva V. G. et al. Proton conductivity and interphase interaction in CsH_2PO_4 -SrZrO₃ composites // Russian Journal of Electrochemistry. – 2013. – V. 49, No 7. – P. 718–724.

52. Mateyshina Y. G., Alekseev D. V., Khusnutdinov V. R. et al. Mechanochemical synthesis of inert component for composite solid electrolytes $CsNO_2-MgAl_2O_4$ // Materials Today: Proceedings. – 2019. – V. 12. – P. 13–16.

53. Kim J. T., Lee T. H., Park K. Y. et al. Electrochemical properties of dual phase neodymium-doped ceria alkali carbonate composite electrolytes in intermediate temperature // Journal of Power Sources. – 2015. – V. 275. – P. 563–572.

54. Yao C., Meng J., Liu X. et al. Enhanced ionic conductivity in Gd-doped ceria and (Li/Na)₂SO₄ composite electrolytes for solid oxide fuel cells // Solid State Sciences. – 2015. – V. 49. – P. 90–96.

55. Li T., Wang K., Yuan Y. et al. Interface dominated conductivity change in Ce_{0.8}Sm_{0.1}Nd_{0.1}O₂₋₈/La_{9.33}Si₆O₂₆ composite electrolyte // Solid State Ionics. – 2019. – V. 331. – P. 12–17.

56. Raza R., Abbas G., Wang X. et al. Electrochemical study of the composite electrolyte based on samaria-doped ceria and containing yttria as a second phase // Solid State Ionics. – 2011. – V. 188, № 1. – P. 58–63.

57. Singh P. Electrical conductivity of YSZ-SDC composite solid electrolyte synthesized via glycine-nitrate method // Ceramics International. – 2017. – V. 43, № 15. – P. 11692–11698.

58. Li B., Liu S., Liu X. et al. Electrical properties of SDC–BCY composite electrolytes for intermediate temperature solid oxide fuel cell // International journal of hydrogen energy. – 2014. – V. 39, № 26. – P. 14376–14380.

59. Wang H., Zhang L., Liu X. et al. Electrochemical study on $Ce_{0.85}Sm_{0.15}O_{1.925}$ -Ba $Ce_{0.83}Y_{0.17}O_{3-\delta}$ composite electrolyte // Journal of Alloys and Compounds. – 2015. – V. 632. – P. 686–694.

60. Łącz A., Pasierb P. Synthesis and properties of $BaCe_{1-x}Y_xO_{3-\delta}$ -BaWO₄ composite protonic conductors // Journal of thermal analysis and calorimetry. – 2013. – V. 113, No 1. – P. 405–412.

61. Lacz A., Pasierb P. Electrical properties and chemical stability of $BaCe_{0.9}Y_{0.1}O_3$ -BaWO₄ composites synthesized by co-sintering and impregnation method // Solid State Ionics. – 2017. – V. 302. – P. 152–157.

62. Lacz A., Silarska K., Piecha I. et al. Structure, chemical stability and electrical properties of $BaCe_{0.9}Y_{0.1}O_{3-\delta}$ proton conductors impregnated with $Ba_3(PO_4)_2$ // International Journal of Hydrogen Energy. – 2016. – V. 41, No 31. – P. 13726–13735.

63. Hei Y., Huang J., Wang C. et al. Novel doped barium cerate–carbonate composite electrolyte material for low temperature solid oxide fuel cells // International journal of hydrogen energy. -2014. - V. 39, No 26. -P. 14328-14333.

64. Xiong X., Lei X., Zhang C. et al. Synergetic proton conduction in $BaZr_{0.8}Y_{0.2}O_3$ - δ -carbonate composite electrolyte for intermediate-temperature solid oxide fuel cells // Solid State Ionics. – 2015. – V. 279. – P. 66–71.

65. Zhang W., Yuan M., Wang H. et al. High-performance intermediate temperature fuel cells of new $SrCe_{0.9}Yb_{0.1}O_{3-\alpha}$ -inorganic salt composite electrolytes // Journal of Alloys and Compounds. – 2016. – V. 677. – P. 38–41.

66. Wang H., Liu J. Low temperature synthesis of novel $SrCe_{0.9}Yb_{0.1}O_{3-\alpha}$ chlorides composite electrolytes for intermediate temperature protonic ceramics fuel cells // Ceramics International. – 2016. – V. 42, No 16. – P. 18136–18140.

67. Liu F., Dang J., Hou J. et al. Study on new BaCe_{0.7}In_{0.3}O_{3- δ}-Gd_{0.1}Ce_{0.9}O_{2- δ} composite electrolytes for intermediate-temperature solid oxide fuel cells // Journal of Alloys and Compounds. – 2015. – V. 639. – P. 252–258.

68. Park K. Y., Lee T. H., Jo S. et al. Electrical and physical properties of composite $BaZr_{0.85}Y_{0.15}O_{3-d}$ -Nd_{0.1}Ce_{0.9}O_{2- δ} electrolytes for intermediate temperature-solid oxide fuel cells // Journal of Power Sources. – 2016. – V. 336. – P. 437–446.

69. Huang X., Liu C., Lu Y. et al. Li-Garnet composite ceramic electrolyte and its solid-state Li-S battery // Journal of Power Sources. – 2018. – V. 382. – P. 190–197.

70. Porotnikova N., Khrustov A., Farlenkov A. et al. Promising La₂Mo₂O₉–
 La₂Mo₃O₁₂ Composite Oxygen-Ionic Electrolytes: Interphase Phenomena //
 ACS Applied Materials & Interfaces. – 2022. – V. 14, № 4. – P. 6180–6193.

71. Нейман А. Я., Пестерева Н. Н., Шарафутдинов А. Р. и др. Проводимость и числа переноса метакомпозитов MeWO₄ · WO₃ (Me – Ca, Sr, Ba) // Электрохимия. – 2005. – Т. 41, № 6. – С. 680–693.

72. Neiman A. Ya., Uvarov N. F., Pestereva N. N. Solid state surface and interface spreading: An experimental study // Solid State Ionics. – 2007. – V. 177. – P. 3361–3369.

73. Пестерева Н. Н., Жукова А. Ю, Нейман А. Я. Числа переноса носителей и ионная проводимость эвтектических метакомпозитов {MeWO₄·xWO₃} (Me=Sr, Ba) // Электрохимия. – 2007. – Т. 43, № 11. – С. 1379–1386.

74. Нейман А. Я., Карапетян А. В., Пестерева Н. Н. Проводимость композитных материалов на основе $Me_2(WO_4)_3$ и WO_3 (Me = Sc, In) // Электрохимия. – 2014. – Т. 50, № 1. – С. 66–77.

75. Neiman A. Ya, Pestereva N. N., Tsipis E. V. Surface diffusion, migration, and conjugated processes at heterophase interfaces between WO₃ and MeWO₄ (Me = Ca, Sr, Ba) // Russian Journal of Electrochemistry. -2007. - V. 43. - P. 672-681.

76. Pestereva N. N., Safonova I. G. Nokhrin S. S. et al. Effect of MWO₄ (M = Ca, Sr, Ba) dispersion on the interfacial processes in $(+/-)WO_3|MWO_4|WO_3(-/+)$ cells and transport properties of metacomposite phases // Russian Journal of Inorganic Chemistry. – 2010. – V. 55, No 6. – P. 940–946.

77. Нейман А. Я., Пестерева Н. Н., Чжоу Ю. и др. Природа и механизм ионного переноса в вольфраматах Me²⁺{WO4} (Ca, Sr, Ba) и M³⁺{WO₄}₃ (Al, Sc, In) по данным метода тубандта // Электрохимия. – 2013. – Т. 49, № 9. – С. 999–1012.

78. Neiman A. Ya., Konisheva E. Yu. Electrosurface transfer of WO₃ into CaWO4 ceramics it // Solid State Ionics. – 1998. – V. 110, № 1-2. – P. 211–219.

79. Guseva A. F., Pestereva N. N., Vostrotina E. L. et al. Ionic Conductivity of Solid Solutions and Composites Based on $Sm_2W_3O_{12}$ // Russian Journal of Electrochemistry. – 2020. – V. 56, No 5. – P. 447–451.

80. Guseva A. F., Pestereva N. N., Lopatin D. A. et al. Transport processes on the $M_2(WO_4)_3|WO_3$ (M = Sm, Gd) interphase boundary // Russian Journal of Physical Chemistry. – 2019. – V. 93, No 3. – P. 555–560.

81. Belousov V. V. Grain boundary wetting in ceramic cuprates // Journal of materials science. – 2005. – V. 40, №. 9. – P. 2361–2365.

82. Fedorov S. V., Belousov V. V., Vorobiev A. V. Transport properties of $BiVO_4-V_2O_5$ liquid-channel grain-boundary structures // Journal of the Electrochemical Society. – 2008. – V. 155, No. 12. – P. F241.

83. Белоусов В. В., Федоров С. В. Ускоренный массоперенос с участием жидкой фазы в твердых телах // Успехи химии. – 2012. – Т. 81, №. 1. – С. 44–64.

84. Lyskov N. V., Metlin Y. G., Belousov V. V. et al. Transport properties of Bi₂CuO₄–Bi₂O₃ ceramic composites // Solid State Ionics. – 2004. – V. 166, №. 1-2. – P. 207–212.

85. Belousov V. V., Fedorov S. V., Vorobiev A. V. The oxygen permeation of solid/melt composite $BiVO_4$ -10 wt% V_2O_5 membrane // Journal of the Electrochemical Society. - 2011. - V. 158, No. 6. - P. B601.

86. Kul'bakin I., Belousov V., Fedorov S. et al. Solid/melt ZnO–Bi₂O₃ composites as ion transport membranes for oxygen separation from air // Materials Letters. – 2012. – V. 67, No. 1. – P. 139–141.

87. Кульбакин, И. В., Федоров, С. В., Воробьев, А. В. и др. Транспортные свойства композитов ZrV₂O₇-V₂O₅ с жидкоканальной зернограничной структурой // Электрохимия. – 2013. – Т. 49, №. 9. – С. 982–982.

88. Spesivtseva I. V., Kochetova N. A., Gorbunova E. M. et al. Solid solutions of $Ba_2(In_{1-x}Al_x)_2O_5$: Structural evolution and hydration processes // Russian Journal of Physical Chemistry A. – 2011. – V. 85, No 10. – P. 1689–1694.

89. Кочетова Н. А., Алябышева И. В., Анимица И. Е. Протонная проводимость твердых растворов Ва₂(In_{1-x}Al_x)₂O₅ // Электрохимия. – 2015. – Т. 51, № 9. – С. 994–994.

90. Христова М. О., Алябышева И. В. Фазовый состав и электрические свойства образцов Аl-допированного индата бария // Актуальные проблемы развития естественных наук. – 2020. – С. 48–50.

91. Yamamura H., Hamazaki H., Kakinuma K. Order-disorder transition and electrical conductivity of the brownmillerite solid-solutions system Ba₂(In,M)₂O₅ (M=Ga, Al) // J. Korean Phys. Soc. – 1999. – V. 35. – P. 200–204.

92. Müller-Buschbaum H., Abed M. Ba₂InAlO₅: Ein weiterer Strukturtyp bei Ox-ometallaten der Formel A₂M₂O₅ // Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. – 1990. – V. 591, № 1. – P. 174–180.

93. Kalinina T. A., Lykova L. N., Kovba L. M. et al. Phase diagrams of BaO-In₂O₃ system // Russian Journal of Inorganic Chemistry. – 1983. – V. 28, № 2. – P. 466–470.

94. Yoshiasa A., Takeno S., Iishi K. $Ba_2In_6O_{13}$: a compound with distorted square pyramidal InO₅ coordination polyhedra // Mineralogical Journal. – 1992. – V. 16, No 1. – P. 40–48.

95. Abakumov A. M., Rossell M. D., Gutnikova O. Y. et al. Superspace description, crystal structures, and electric conductivity of the $Ba_4In_{6-x}Mg_xO_{13-x/2}$ solid solutions // Chemistry of Materials. – 2008. – V. 20, No 13. – P. 4457–4467.

96. Boukamp, B. A. A nonlinear least squares fit procedure for analysis of immittance data of electrochemical system // Solid State Ionics. 1986. – V. 20. – P. 31–44.

97. Fleig J., Maier J. The impedance of ceramics with highly resistive grain boundaries: validity and limits of the brick layer model // Journal of European Ceramic Society. – 1999. – V. 19. – P. 693–696.

98. Abrantes J. C., Labrincha J. A., Frade J. R. An alternative representation of impedance spectra of ceramics // Materials Research Bulletin. -2000. - V. 35, $N_{2} 5. - P. 727-740$.

99. Vecherskii S. I., Tabatchikova S. N., Antonov B. D.et al. Electrical conductivity of $LaCo_xFe_{1-x}O_{3-\delta}$ and $LaLi_{0.1}Co_xFe_{0.9-x}O_{3-\delta}$ ($0 \le x \le 0.4$) oxides // Inorganic Materials. – 2011. – V. 47, No 12. – P. 1356–1360.

100. Iwahara H., Uchida H., Maeda N. Studies on solid electrolyte gas cells with high-temperature-type proton conductor and oxide ion conductor // Solid State Ionics. -1983. - V. 11, No 2. - P. 109-115.

101. Norby T. EMF method determination of conductivity contributions from protons and other foreign ions in oxides // Solid State Ionics. – 1988. – V. 28. – P. 1586–1591.

102. Iwahara H. Oxide-ionic and protonic conductors based on perovskite-type oxides and their possible applications // Solid State Ionics. – 1992. – V. 52, № 1-3. – P. 99–104.

103. Dunyushkina L. A., Kuz'min A. V., Balakireva V. B. et al. Electrical conduction nature and phase transition in $CaTi_{1-x}Fe_xO_{3-\delta}$ (x= 0.1–0.5) // Russian Journal of Electrochemistry. – 2006. – V. 42, No 4. – P. 375–380.

104. Pérez-Coll D., Heras-Juaristi G., Fagg D. P. et al. Transport-number determination of a protonic ceramic electrolyte membrane via electrode-polarisation correction with the Gorelov method // Journal of Power Sources. – 2014. – V. 245. – P. 445–455.

105. Горелов В. П., Балакирева В. Б., Кузьмин А. В. Парциальные проводимости в перовскитах CaZr_{1-x}Sc_xO_{3-alpha} (x= 0.03-0.20) в окислительной атмосфере // Физика твердого тела. – 2016. – Т. 58, № 1. – С. 14–20.

106. Shannon R.D. Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides // Acta Crystallographica. – 1976. – V. A32. – P. 751–767.

107. Yin J., Zou Z., Ye J. Photophysical and photocatalytic properties of $MIn_{0.5}Nb_{0.5}O_3$ (M = Ca, Sr, and Ba) // The Journal of Physical Chemistry B. – 2003. – V. 107, No 1. – P. 61–65.

108. Galasso F. S., Layden G. K., Flinchbaugh D. E. $Ba(B_{0.5}Ta_{0.5})O_3$ ordered perovskite-type compounds, possible new laser host materials // The Journal of Chemical Physics. – 1966. – V. 44, No 7. – P. 2703–2707.

109. Андреев О. В., Русейкина А. В., Харитонова В. П. Использование треугольника Таммана, микроструктуры для определения нонвариантных точек в системе Cu₂S-EuLaCuS₃ // Вестник Тюменского государственного университета. Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика. – 2009, № 6. – С. 257–262.

110. Baller F. Züchtung und Charakterisierung der Mischkristalle $(Ba_{1-x}Sr_x)TiO_3$ und der Kristalle $Ba_2(In, Nb)O_6$ und $(Na, Bi)Ti_2O_6$. – Shaker, 1996.

111. Корона Д. В., Нейман А. Я., Анимица И. Е. и др. Влияние влажности на проводимость фазы Ba₄Ca₂Nb₂O₁₁ и твердых растворов на ее основе // Электрохимия. – 2009. – Т. 45, №5. – С. 622–628.

112. Animitsa I., Norby T., Marion S. et al. Incorporation of water in strontium tantalates with perovskite-related structure // Solid State Ionics. – 2001. – V. 145. – P. 357–364.

113. Norby T., Ch. 11: Proton Conductivity in Perovskite Oxides // Perovskite Oxide for Solid Oxide Fuel Cells // Springer, Boston, MA, 2009. – P. 217–241.

114. Yamazaki Y., Yang C. K., Haile S. M. Unraveling the defect chemistry and proton uptake of yttrium-doped barium zirconate // Scripta Materialia. – 2011. – V. 65, № 2. – P. 102–107.

115. Казенас Е. К., Цветков Ю. В. Испарение оксидов. М.: Наука, 1997. 543 с.

116. Кочетова Н. А., Анимица И. Е., Нейман А. Я. Электрические свойства твердых растворов на основе танталата стронция с перовскитоподобной структурой. Протонная проводимость // Электрохимия. – 2010. – Т. 46, № 2. – С. 177–182.

117. Quarez E., Noirault S., Caldes M. T. et al. Water incorporation and proton conductivity in titanium substituted barium indate // Journal of Power Sources. –
2010. – V.195. – P. 1136.

118. Анимица И. Е. Высокотемпературные протонные проводники на основе перовскитоподобных сложных оксидов со структурным разупорядочением кислородной подрешетки : дис. ... д-ра хим. наук / И. Е. Анимица ; Урал. Фед. Ун-т – УрФУ – Екатеринбург, 2011. – 303.

119. Rey J. F. Q., Ferreira F. F., Muccillo E. N. S. Primary particle size effect on phase transition in Ba₂In₂O₅ // Solid State Ionics. – 2008. – V. 179, № 21-26. – P. 1029–1031.

120. Lazic B., Kahlenberg V., Kaindl R. et al. On the symmetry of Ba₃Al₂O₆–
X-ray diffraction and Raman spectroscopy studies // Solid State Sciences. – 2009. –
V. 11, № 1. – P. 77–84.

121. Bielecki J., Parker S. F., Mazzei L. et al. Structure and dehydration mechanism of the proton conducting oxide $Ba_2In_2O_5(H_2O)_x$ // Journal of Materials Chemistry A. – 2016. – T. 4, No 4. – C. 1224–1232.

122. Sata N., Ishigame M., Shin S. Optical absorption spectra of acceptordoped SrZrO₃ and SrTiO₃ perovskite-type proton conductors // Solid State Ionics. – 1996. – V. 86. – P. 629–632.

123. Анимица И. Е., Кочетова Н. А. Квазихимическое описание процессов дефектообразования в оксидах: учебное пособие. – 2019.

124. Jankovic J., Wilkinson D. P., Hui R. Proton conductivity and stability of $Ba_2In_2O_5$ in hydrogen containing atmospheres // Journal of The Electrochemical Society. – 2010. – V. 158, No 1. – P. B61.

125. Lacz A., Pasierb P. Reaction mechanism in solid BaCe_{0. 9}Y_{0.1}O₃–liquid BaWO₄ system // Journal of Alloys and Compounds. – 2017. – V. 723. – P. 288–294.

126. Lee J. S., Adams S., Maier J. Transport and Phase Transition Characteristics in AgI:Al₂O₃ Composite Electrolytes Evidence for a Highly Conducting 7-Layer AgI Polytype // Journal of the Electrochemical Society. – 2000. – V. 147, No. 6. – P. 2407.

127. Koteneva E. A., Pestereva N. N., Astapova, D. V. et al. Transport properties of $SrMoO_4/MoO_3$ composites // Russian Journal of Electrochemistry. – 2017. – V. 53, No. 2. – P. 187–195.